

TPS1HC03-Q1 3.2mΩ シングル チャネル 車載スマート ハイサイド スイッチ

1 特長

- シングル チャネル 完全な診断機能を持つスマート ハイサイド スイッチ
 - GPIO ピンを使用した制御
 - オープンドレイン ステータス出力
 - 電流検出アナログ出力: 検出精度 $\leq 5A$ で $\pm 7\%$
- 広い動作電圧範囲: $3V \sim 28V$
- 低 R_{ON} : $3.2m\Omega$ (代表値)、 $5.7m\Omega$ (最大値、 $150^\circ C$ 時)
- 超低スリープ電流: $< 1.4\mu A$ ($85^\circ C$ 時)
- サーマル・レギュレーションありなしで調整可能な電流制限
 - 電流制限範囲: $20A \sim 57A$
- 保護
 - 過負荷および短絡保護
 - 低電圧誤動作防止 (UVLO)
 - 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスリング
 - 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
 - GND 消失、バッテリー消失、バッテリー逆極性からの保護
- 診断
 - グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
 - 過電流およびグラウンドへの短絡の検出
 - 開放負荷およびバッテリーへの短絡の検出
- 車載アプリケーション認定済み
 - 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
 - 温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 $-40^\circ C \sim 125^\circ C$
 - 電氣的過渡ノイズ耐性テスト (ISO7637-2 および ISO16750-2) に合格
- 小さい占有面積: 11 ピンウェットパブルフランク VQFN-HR $2.2mm \times 3.6mm$, $0.55mm$ ピッチ
- 機能安全規格に対応
 - 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

2 アプリケーション

- ゾーン制御モジュール
- ボディコントロール モジュール
- 白熱光および LED ライティング
- フロントドア モジュール
- シートヒーター

3 説明

TPS1HC03-Q1 は、12V 車載バッテリー システム向けに設計された、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵する シングル チャネルのスマート ハイサイド スイッチです。低オン抵抗 ($3.2m\Omega$) により、最大 $19A$ DC までの幅広い出力負荷電流を駆動する際のデバイス損失を最小限に抑えます。

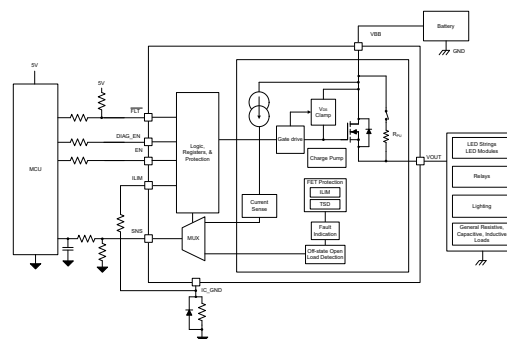
このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。TPS1HC03-Q1 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。調整可能な電流制限を、ILIM ピンの外付け抵抗を使用して $20A \sim 57A$ に調整します。本デバイスは、起動時の容量性負荷に対するサーマル制御型電流制限と、モーター突入電流やバルブ用途向けの非制御型電流制限の両方を提供します。

本デバイスは高精度な電流検出機能を備えており、過負荷検出や開放負荷の検出といった負荷診断の精度向上に寄与し、予知保全の高度化を可能にします。TPS1HC03-Q1 は、11 ピン、 $0.55mm$ ピッチの $2.2mm \times 3.6mm$ VQFN-HR ウェットパブル フランク パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
TPS1HC03-Q1	VAH (VQFN-HR, 11)	$2.2mm \times 3.6mm$

- 詳細については、[セクション 12](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ $\times$ 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



代表的なアプリケーション回路図



目次

1 特長	1	8.2 機能ブロック図	18
2 アプリケーション	1	8.3 機能説明	18
3 説明	1	8.4 デバイスの機能モード	51
4 デバイス比較表	3	9 アプリケーションと実装	54
5 ピン構成および機能	4	9.1 アプリケーション情報	54
6 仕様	5	9.2 代表的なアプリケーション	54
6.1 絶対最大定格.....	5	9.3 電源に関する推奨事項	59
6.2 ESD 定格.....	5	9.4 レイアウト	59
6.3 推奨動作条件.....	5	10 デバイスおよびドキュメントのサポート	63
6.4 熱に関する情報.....	6	10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項.....	63
6.5 電気的特性.....	6	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	63
6.6 SNS タイミング特性.....	10	10.3 サポート・リソース.....	63
6.7 スイッチング特性.....	10	10.4 商標.....	63
6.8 代表的特性.....	12	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	63
7 パラメータ測定情報	16	10.6 用語集.....	63
8 詳細説明	17	11 改訂履歴	63
8.1 概要.....	17	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報	64

4 デバイス比較表

TPS1HC03-Q1 は、大電流対応のスマートハイサイドスイッチファミリに属しており、複数のデバイスバージョンが存在します。以下の表は、各バージョンの詳細および各デバイスで提供されているバージョンを示します。

表 4-1. バージョン表

バージョン ⁽¹⁾	スルー レート	開放負荷の検出遅延
P	公称 (0.45V/μs)	0.4ms の遅延
D ⁽²⁾	低速 (0.06V/μs)	0.4ms の遅延
M ⁽²⁾	公称 (0.45V/μs)	2.4ms の遅延

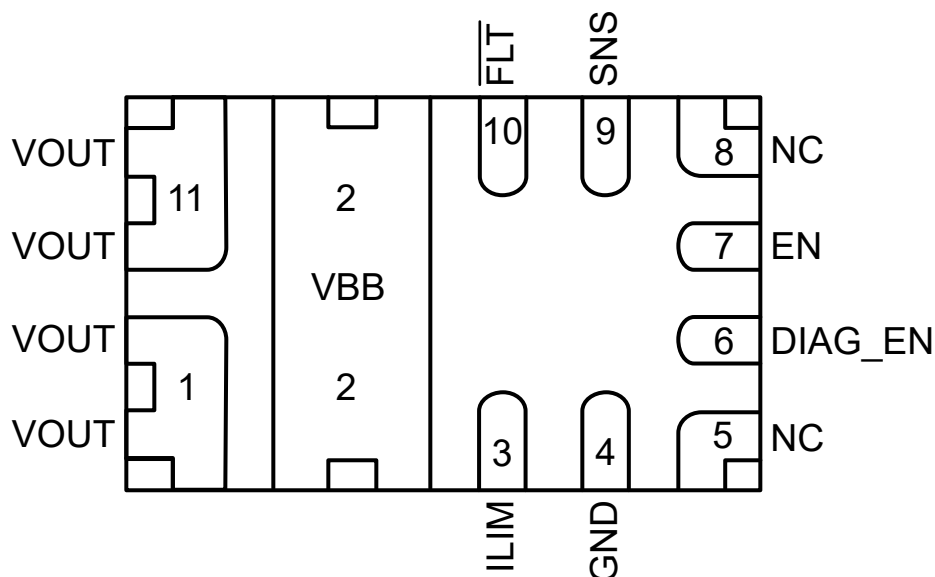
(1) すべてのバージョンは GPIO 制御です。

(2) 開発中製品のデバイス。詳細情報については、TI にお問い合わせください。

表 4-2. デバイス比較表

部品番号	計画バージョン	チャネル数	25°C におけるオン抵抗	調整可能な電流制限範囲	過電流時の動作
TPS2HC08-Q1	P、D	2	9.5mΩ	7.5A～25A	- ILIM ピンに外付け抵抗を使用したときのサーマル レギュレーションによる電流制限 - ILIM ピン= GND のとき、サーマル レギュレーションなしでの電流制限
TPS2HC16-Q1	P、D、M	2	18.7mΩ	5A～15A	
TPS1HC08-Q1	P、D	1	9.8mΩ	10A～25A	
TPS1HC04-Q1	P、D	1	4.9mΩ	15A～45A	
TPS1HC03-Q1	P、D	1	3.2mΩ	20A～57A	
TPS1HC16-Q1	P	1	16mΩ	10A～25A	
TPS2HC30-Q1	P	2	30mΩ	5A～15A	

5 ピン構成および機能



NC - 内部接続なし

図 5-1. VAH パッケージ TPS1HC03-Q1 上面図

表 5-1. ピンの機能

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

ピン		タイプ	説明
番号	名称		
1	VOUT	電源	ハイサイドスイッチの出力、負荷に接続
2	VBB	電源	電源
3	ILIM	入力	調整可能な電流制限。ピンと GND との間に抵抗を接続して、電流制限を設定します。
4	GND	電源	デバイスのグラウンド。抵抗とダイオードのグラウンドネットワークに接続して逆バッテリー保護を実行します
5	NC	該当なし	内部接続なし
6	DIAG_EN	入力	診断用イネーブル/ディスエーブルピン、内部プルダウン
7	EN	入力	チャネルのアクティブ化用入力制御、内部プルダウン
8	NC	該当なし	内部接続なし
9	SNS	出力	負荷電流に対応するアナログ電流センス出力。R _{SNS} をグラウンドに接続して、電圧に変換します。High に移行することで故障状態も示します
10	FLT	出力	オープン ドレインの全体的な故障出力。FAULT、FLT、または故障ピンを基準とします
11	VOUT	電源	ハイサイドスイッチの出力、負荷に接続

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
最大連続電源電圧、V _{BB}			28	V
負荷ダンブ電圧、V _{LD}	ISO16750-2:2010(E)		35	V
逆極性電圧	アプリケーション回路を使用した場合の最大持続時間は 3 分	-18		V
イネーブル・ピン電流、I _{EN}	イネーブル・ピン電流、I _{EN}	-1	7	mA
イネーブル・ピン電圧、V _{EN}		-1	7	V
診断イネーブル・ピンの電流、I _{DIAG_EN}		-1	7	mA
診断イネーブル・ピン電圧、V _{DIAG_EN}		-1	7	V
センス・ピン電流 I _{SNS}		-150	10	mA
FLT ピンの電流、I _{FLT}		-30	10	mA
FLT ピン電圧、V _{FLT}		-0.3	V _{BB}	V
ILIM ピンの電流、I _{ILIM}	ILIM ピンの電流、I _{ILIM}	-30	10	mA
ILIM ピン電圧、V _{ILIM}	ILIM ピン電圧、I _{ILIM}	-0.3	V _{BB}	V
逆グランド電流、I _{GND}	V _{BB} < 0V		-50	mA
ターンオフ時のエネルギー消費、E _{AS}	シングル パルス、V _{BB} = 13.5V、L _{OUT} = 5mH、T _{J,start} = 125°C、公称スルーレート (バージョン P)		360 ⁽²⁾	mJ
ターンオフ時のエネルギー消費、E _{AR}	反復パルス、V _{BB} = 13.5V、I _{OUT} = 19A、T _{J,start} = 125°C、公称スルーレート (バージョン P)		39 ⁽²⁾	mJ
最大接合部温度、T _J			150	°C
保管温度、T _{stg}		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

(2) 詳細については、誘導性負荷のスイッチオフに関するセクションを参照してください。

6.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電 ⁽¹⁾	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002、分類レベル 2 準拠 ⁽²⁾	V _{BB} と V _{OUT} を除くすべてのピン	V
			V _{BB} および V _{OUT}	
		荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 分類レベル C5 準拠	すべてのピン	
			±2000	
			±4000	
			±750	

(1) すべての ESD 衝撃は、GND に接続されたピンの基準電圧によるものです

(2) AEC-Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

6.3 推奨動作条件

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{VBB_NOM}	公称電源電圧 ⁽¹⁾	6	18	V
V _{VBB_EXT}	拡大電源電圧 ⁽²⁾	3	28	V
V _{VBB_SC}	電源電圧への短絡対応能力		24	V

6.3 推奨動作条件 (続き)

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{EN}	イネーブル電圧	-1	5.5	V
V _{DIAG_EN}	診断イネーブル電圧	-1	5.5	V
V _{SNS}	センス電圧	-1	5.5	V
T _A	自由空気での動作温度	-40	125	°C

- (1) すべての動作電圧条件は、デバイスの GND を基準として測定されています。
(2) デバイスは拡張動作範囲内で機能しますが、一部のタイミング パラメータ値は適用されない場合があります。使用する電圧については、対応するセクションを参照してください。詳細については、[セクション 9.3](#) を参照してください。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ^{(1) (2)}		TPS1HC03-Q1	単位
		VAH	
		11 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	41.1	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	34.4	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	8.6	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	1.6	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	8.6	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	8.8	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。
(2) 熱パラメータは、JESD51-5 および JESD51-7 に準拠した 4 層 PCB に基づいています。

6.5 電気的特性

V_{BB} = 6V ~ 18V、T_J = -40°C ~ 150°C (特に記述のない限り)。代表的なアプリケーションは 13.5V、R_{LIM} = 開放 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
入力電圧および電流							
V _{UVLOR}	VBB 低電圧誤動作防止	デバイスの GND ピンに関して測定	VBB 立ち上がりスレッシュヨルド	3.6	3.85	4.1	V
V _{UVLOF}			VBB 立ち下がりスレッシュヨルド	2.8	2.9	3.0	V
V _{DET1}	VBB 検出 1 スレッシュヨルド	ACTIVE、DIAGNOSTIC、または STANDBY 状態	VBB 立ち上がりスレッシュヨルド	19	20.5	22.5	V
			VBB 立ち下がりスレッシュヨルド	18.4	19.5	20.7	V
V _{DET2}	VBB 検出 2 スレッシュヨルド	アクティブ状態	VBB 立ち上がりスレッシュヨルド	24.5	26	28	V
			VBB 立ち下がりスレッシュヨルド	22.5	24	26	V
V _{HV_R}	VBB 高電圧ウェークアップ・スレッシュヨルド	スリープからスタンバイ状態へ遷移するための VBB 電圧	VBB 立ち上がりスレッシュヨルド	17	25	28.1	V
V _{HV_F}		スタンバイからスリープ状態へ遷移するための VBB 電圧	VBB 立ち下がりスレッシュヨルド	18			V

6.5 電気的特性 (続き)

$V_{BB} = 6V \sim 18V$, $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$ (特に記述のない限り)。代表的なアプリケーションは $13.5V$ 、 $R_{LIM} = \text{開放}$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位	
V _{Clamp}	VDS クランプ電圧	V _{BB} ≥ V _{DET1}	T _J = 25℃	35		37	V	
			T _J = −40℃～150℃	31		42	V	
		V _{BB} < V _{DET1}	T _J = −40℃～150℃	24		35	V	
I _{SLEEP}	スリープ状態の電流 (MOSFET チャンネルを含む デバイスの総リーケージ)	V _{EN} = V _{DIAG_EN} = 0V、 V _{OUT} = 0V	T _J = 25℃			1.2	μA	
			T _J = 85℃			1.4	μA	
			T _J = 150℃			12	μA	
I _{OUT(SLEEP)}	出力リーク電流	V _{EN} = V _{DIAG_EN} = 0V、 V _{OUT} = 0V	T _J = 25℃		0.02	0.5	μA	
			T _J = 85℃			0.7	μA	
			T _J = 150℃			6	μA	
I _{DIAG}	DIAGNOSTIC 状態の消費電流	V _{EN} = 0V、V _{DIAG_EN} = 5V、V _{OUT} = 0V、I _{SNS} = 0A			1.7	2.4	mA	
		V _{EN} = 5V、V _{DIAG_EN} = 0V、V _{OUT} = 0V、I _{SNS} = 0A			1.5	2.4	mA	
I _Q	静止時電流	V _{EN} = V _{DIAG_EN} = 5V、I _{OUT} = 0A				3.2	mA	
t _{STBY}	スタンバイモード遅延時間	V _{EN} = V _{DIAG_EN} = 0V、V _{BB} < V _{HV_F} からスタンバイまで			13	16	19	ms
Ron の特性								
R _{ON}	オン抵抗	3V ≤ V _{BB} ≤ 28V、I _{OUT} =1A	T _J = 25℃		3.2	4	mΩ	
			T _J = 150℃			5.7	mΩ	
R _{ON(REV)}	逆極性時のオン抵抗	-18V ≤ V _{BB} ≤ -6V	T _J = 25℃		3.2	4	mΩ	
			T _J = 150℃			5.7	mΩ	
I _{LNOM}	連続負荷電流	T _{AMB} = 85℃				19	A	
V _F	ソースドレイン間ボディダイオード電圧	V _{EN} = 0 V、I _{OUT} = -1A			0.15	0.6	0.8	V
電流センス特性								
V _{BB_FLT}	完全な故障時の機能を動作させるために必要なV _{BB} のヘッドルーム ⁽²⁾	V _{DIAG_EN} = 3.3V			5.3		V	
		V _{DIAG_EN} = 5V			6.5		V	
V _{BB_ISNS}	完全な電流センス機能を動作させるために必要なV _{BB} ヘッドルーム ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	V _{DIAG_EN} = 3.3V、R _{SNS} = 0.5kΩ			5.3		V	
		V _{DIAG_EN} = 5V、R _{SNS} = 0.5kΩ			6.5		V	

6.5 電気的特性 (続き)

$V_{BB} = 6V \sim 18V$, $T_J = -40^{\circ}C \sim 150^{\circ}C$ (特に記述のない限り)。代表的なアプリケーションは $13.5V$ 、 $R_{LIM} = \text{開放}$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
K _{SNS}	電流センス比 I _{OUT} にわたって I _{OUT} / I _{SNS}	V _{BB} > V _{BB_ISNS} 、V _{EN} = V _{DIAG_EN} = 5V	I _{OUT} = 40A	8060			mA
				-7			7
			I _{OUT} = 20A	8060			A/A
				-7			7
			I _{OUT} = 10A	8060			A/A
				-7			7
			I _{OUT} = 5A	8060			A/A
				-7			7
			I _{OUT} = 2A	8060			A/A
				-7			7
			I _{OUT} = 1A	8060			A/A
				-8			8
			I _{OUT} = 500mA	8060			A/A
				-20			20
			I _{OUT} = 200mA	8060			A/A
				-40			55
SNS 特性							
I _{SNSFH}	I _{SNS} フォルト high-レベル	V _{DIAG_EN} > V _{IH} , DIAG_EN		5.5	7.4	9.5	mA
I _{SNSleak_disabled}	I _{SNS} リークエージ (診断無効)	V _{DIAG_EN} = 0V	SNS ピンに 0V を強制	-100	1	100	nA
電流制限特性							
I _{CL_FLT_Trip}	フォルトアサートが発生した電流と実際の電流制限値との比率 ⁽²⁾	T _J = −40℃～150℃	R _{LIM} = 16.67kΩ ～ 50kΩ	74	80		%
R _{LIM}	RLIM 短絡検出範囲			17.5			kΩ
	RLIM 開放検出範囲			50			kΩ
K _{CL}	電流制限比 ⁽¹⁾	T _J = −40℃～150℃	R _{LIM} = 17.5kΩ	810	1000	1270	A * kΩ
			R _{LIM} = 25kΩ	810	1000	1270	A * kΩ
			R _{LIM} = 50kΩ	810	1000	1270	A * kΩ
I _{CL}	I _{CL} 電流制限スレッショルド ⁽²⁾	T _J = −40℃～150℃	R _{LIM} = GND	57			A
			R _{LIM} = オープン	20			A
I _{CB}	スイッチが有効な時に短絡が発生した場合のピーク電流スレッショルド ⁽²⁾	R _{LIM} = 17.5kΩ～50kΩ	T _J = -40℃	66			A
			T _J = 25℃	65			A
			T _J = 150℃	64			A
I _{CL_HV}	高電圧における I _{CL} 電流制限ディレーティング ^{(2) (3)}	T _J = −40℃～150℃	V _{BB} < V _{DET1}	I _{CL}			A
			V _{DET1} ≤ V _{BB} < V _{DET2}	I _{CL} (I _{CB}) / 2			A
			V _{BB} ≥ V _{DET2}	I _{CL} (I _{CB}) / 3			A
I _{CL_LNPK}	線形モードのピーク ⁽²⁾	T _J = −40℃～150℃	R _{LIM} > 26.3kΩ	1.45 × I _{CL}			A
			R _{LIM} ≤ 26.3kΩ ⁽⁵⁾	1.45 × I _{CL} I _{CB}			A
フォルト特性							
V _{OL}	開放負荷検出電圧 (V _{BB} - V _{OUT} 電圧)	V _{EN} = 0V、V _{DIAG_EN} = 5V、診断状態		1.5	2.2	2.9	V

6.5 電気的特性 (続き)

V_{BB} = 6V ~ 18V, T_J = -40°C ~ 150°C (特に記述のない限り)。代表的なアプリケーションは 13.5V、R_{LIM} = 開放 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
R _{PU}	チャンネルごとの開放負荷 (OL) 検出内部プルアップ抵抗	V _{EN} = 0V, V _{DIAG_EN} = 5V, (V _{BB} - V _{OUT} = 2.7V)		90		kΩ
t _{OL}	開放負荷 (OL) およびバツテリ短絡 (STB) 検出のグリッチ除去時間	V _{EN} = 0V, V _{DIAG_EN} = 5V, V _{BB} - V _{OUT} < V _{OL} 時、t _{OL} より長い持続時間。開放負荷が検出されました。	200		550	μs
t _{OL1}	EN 立ち下がりからの OL および STB 表示時間	V _{EN} = 5V ~ 0V, V _{DIAG_EN} = 5V, I _{OUT} = 0mA, V _{OUT} = V _{BB} - V _{OL}	200		550	μs
t _{OL2}	DIA_EN 立ち上がりからの OL および STB 表示時間	V _{EN} = 0V, V _{DIAG_EN} = 0V ~ 5V, I _{OUT} = 0mA, V _{OUT} = V _{BB} - V _{OL}	200		4050	μs
T _{ABS}	サーマル シャットダウン (2)		150	165	180	°C
T _{REL}	相対サーマル シャットダウン			85		°C
T _{HYS}	サーマル シャットダウン ヒステリシス			28		°C
V _{FLT}	FLT low 出力電圧	I _{FLT} = 2.5mA			0.2	V
t _{FAULT_FLT}	故障表示時間(2)	V _{DIAG_EN} = 5V、フォルトと FLT アサート間の時間			20	μs
t _{FAULT_SNS}	故障表示時間(2)	V _{DIAG_EN} = 5V、故障と I _{SNSFH} における I _{SNS} セトリング間の時間			30	μs
t _{RETRY_WIN DOW}	初期再試行時間ウィンドウ			40		ms
t _{RETRY_INT}	初期再試行時間ウィンドウでの再試行時間	サーマル・シャットダウンからスイッチ再イネーブルまでの時間	100	160	300	μs
t _{RETRY_EXT}	拡張された過電流での再試行時間		50	80	150	ms
EN ピンの特性						
V _{IL, EN}	低レベルの入力電圧	GND ネットワークなし			0.8	V
V _{IH, EN}	高レベルの入力電圧。		1.5			V
V _{IHYS, EN}	入力電圧ヒステリシス			320		mV
R _{EN}	内部プルダウン抵抗。		150	200	500	kΩ
I _{IL, EN}	低レベルの入力電流(2)	V _{EN} = 0.8V	1.6	4	5.5	μA
I _{IH, EN}	高レベルの入力電流(2)	V _{EN} = 5V	19	25	35	μA
DIA_EN ピンの特性						
V _{IL, DIAG_EN}	低レベルの入力電圧	GND ネットワークなし			0.8	V
V _{IH, DIAG_EN}	高レベルの入力電圧。		1.5			V
V _{IHYS, DIAG_EN}	入力電圧ヒステリシス			320		mV
R _{DIAG_EN}	内部プルダウン抵抗。		100	200	500	kΩ
I _{IL, DIAG_EN}	低レベルの入力電流(2)	V _{DIAG_EN} = 0.8V	1.6	4	5.5	μA
I _{IH, DIAG_EN}	高レベルの入力電流(2)	V _{DIAG_EN} = 5V	19	25	35	μA

- (1) K_{CL} から I_{CL} を計算するには、式 I_{CL} = K_{CL}/R_{LIM} を使用します
- (2) 設計により規定されたパラメータであり、生産時のテスト対象ではありません
- (3) 電流制限値が高い場合、I_{CL_HV} は標準値と最大値のうちで小さい方の値となります。詳細については、電流制限フォールドバックに関するセクションを参照してください。
- (4) 完全な電流センス機能を動作させるために必要な最小 V_{BB} ヘッドルームは、式 V_{BB} ≥ 1 + (I_{SNSFH} × (R_{SNS} + 0.53)) を使用して求めることができます。ここで、R_{SNS} は kΩ 単位、I_{SNSFH} は mA 単位、V_{BB} はボルト単位です。

(5) より高い I_{CL} 設定の場合、 $I_{CL_LNPk} = \text{minimum}(1.45 \times I_{CL}, I_{CB})$ です

6.6 SNS タイミング特性

VBB = 6V ~ 18V, $V_{EN} = 5V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$, $R_{SNS} = 1k\Omega$, $T_J = -40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
SNS タイミング-電流センス						
$t_{SNSION1}$	DIAG_EN の立ち上がりエッジからのセトリグタイム ⁽¹⁾	$V_{DIAG_EN} = 0V \sim 5V$, $I_{OUTx} = 1A$			20	μs
		$V_{DIAG_EN} = 0V \sim 5V$, $I_{OUTx} = 50mA$			20	μs
$t_{SNSION2}$	EN および DIAG_EN、 V_{DIAG_EN} の 50%、 V_{EN} に対する立ち上がりエッジから I_{SNS} の 90% までのセトリグタイム	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 0V \sim 5V$, $I_{OUT} = 1A$ (バージョン P)			200	μs
		$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 0V \sim 5V$, $I_{OUT} = 50mA$ (バージョン P)			200	μs
$t_{SNSION3}$	DIAG_EN = HI による EN の立ち上がりエッジからのセトリグタイム、 V_{EN} の 50% から I_{SNS} の 90% まで	$V_{EN} = 0V \sim 5V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$, $I_{OUT} = 1A$ (バージョン P)			200	μs
$t_{SNSIOFF}$	DIAG_EN、 V_{DIAG_EN} の 50% の立ち下がりエッジから I_{SNS} の 5% までのセトリグタイム ⁽¹⁾	$V_{EN} = 5V$, $V_{DIAG_EN} = 5V \sim 0V$, $I_{OUT} = 1A$			10	μs
$t_{SETTLEH}$	負荷ステップの立ち上がりエッジのセトリグタイム ⁽¹⁾	$I_{OUT} = 50mA \sim 1A$			20	μs
$t_{SETTLEL}$	負荷ステップの立ち下がりエッジのセトリグタイム ⁽¹⁾	$I_{OUT} = 1A \sim 50mA$			20	μs

(1) 設計により規定されたパラメータであり、生産時のテスト対象ではありません

6.7 スイッチング特性

VBB = 13.5V, $R_L = 10\Omega$, $T_J = -40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$ (特に注記のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t_{DR}	チャンネルターンオン遅延時間	EN の 50% から VOUT の 20%、スタンバイ状態から (バージョン P)	6	12	30	μs
		EN の 50% から VOUT の 20%、スリープ状態から (バージョン P)	10	45	70	μs
t_{DF}	チャンネルターンオフ遅延時間	EN の 50% から VOUT の 80% (バージョン P)	35	80	121	μs
SR_R	VOUT の立ち上がりスルーレート	VOUT の 20% から 80%、0.9 Ω 負荷 (バージョン D) ⁽²⁾	0.02	0.06	0.1	V/ μs
SR_R	VOUT の立ち上がりスルーレート	VOUT の 20% から 80%、0.9 Ω 負荷 (バージョン P)	0.3	0.45	0.65	V/ μs
SR_F	VOUT の立ち下がりスルーレート	VOUT の 80% から 20% (バージョン D) ⁽²⁾	0.02	0.06	0.1	V/ μs
SR_F	VOUT の立ち下がりスルーレート	VOUT の 80% から 20% (バージョン P)	0.3	0.5	0.7	V/ μs
t_{ON}	チャンネルターンオン時間	EN の 50% から VOUT の 80%、スタンバイ状態から (バージョン P)	15	30	90	μs
		EN の 50% から VOUT の 80%、スリープ状態から (バージョン P)	35	60	110	μs
t_{OFF}	チャンネルターンオフ時間	EN の 50% から VOUT の 20% (バージョン P)	50	90	130	μs
$t_{ON} - t_{OFF}$	ターンオン/ターンオフに対応 ⁽¹⁾	1ms のイネーブルパルス	-75		40	μs
		200 μs のイネーブルパルス	-100		40	μs

6.7 スイッチング特性 (続き)

$V_{BB} = 13.5V$, $R_L = 10\Omega$, $T_J = -40^\circ C \sim +150^\circ C$ (特に注記のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
Δ_{PWM}	PWM 精度-平均負荷電流 ⁽¹⁾	200 μs イネーブルパルス (1ms 周期)	-45		25	%
		$\leq 500Hz$, 50% デューティサイクル	-12		12	%
E_{ON}	ターンオン中のスイッチングエネルギー損失	$V_{BB} = 18V$, $R_L = 3.3\Omega$, V_{OUT} の 0% ~ 100%		0.487		mJ
		$V_{BB} = 18V$, $R_L = 3.3\Omega$, V_{OUT} の 10% ~ 90%		0.458		mJ
E_{OFF}	ターンオフ中のスイッチングエネルギー損失	$V_{BB} = 18V$, $R_L = 3.3\Omega$, V_{OUT} の 100% ~ 0%		0.593		mJ
		$V_{BB} = 18V$, $R_L = 3.3\Omega$, V_{OUT} の 90% ~ 10%		0.513		mJ

- (1) 設計により規定されたパラメータであり、生産時のテスト対象ではありません
(2) 開発中製品のデバイス仕様。詳細情報については、TI にお問い合わせください。

6.8 代表的特性

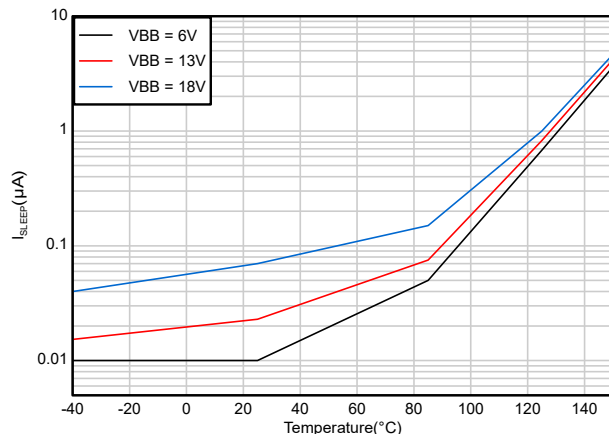


図 6-1. スタンバイ電流 (I_{SLEEP}) と温度との関係

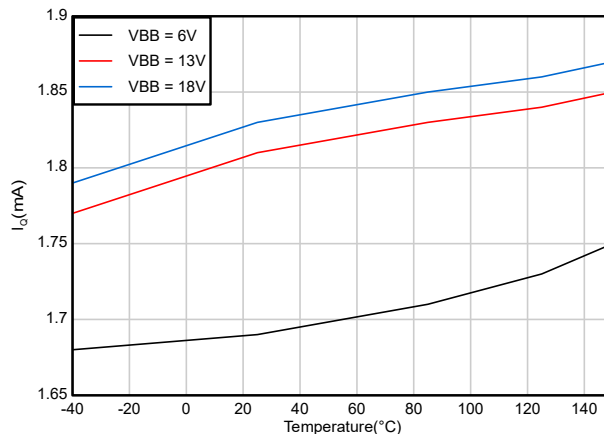


図 6-2. 静止電流 (I_Q) と温度との関係

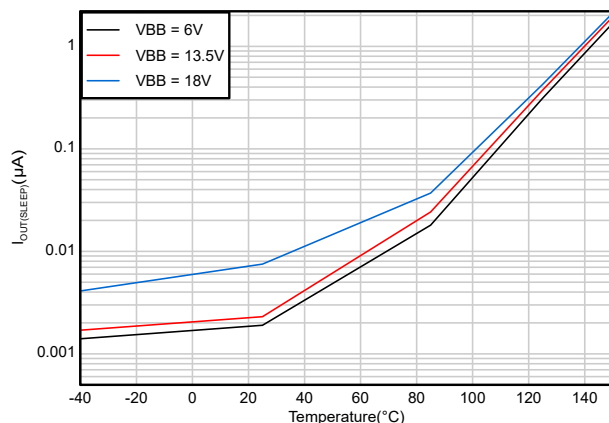


図 6-3. 出力リーク電流 ($I_{OUT(SLEEP)}$) と温度との関係

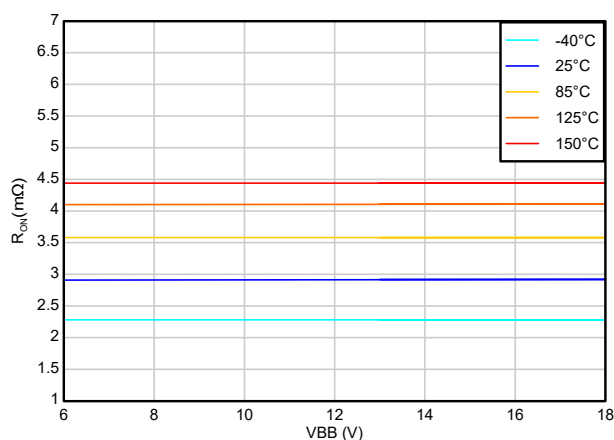


図 6-4. オン抵抗 (R_{ON}) と VBB との関係

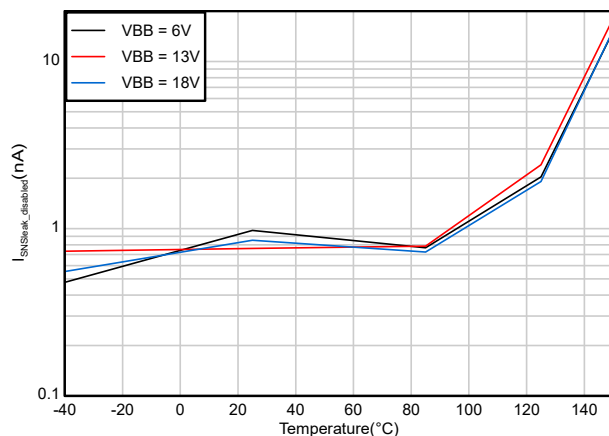


図 6-5. I_{SNS} リーク電流 (Diagnostics 無効時) と温度との関係

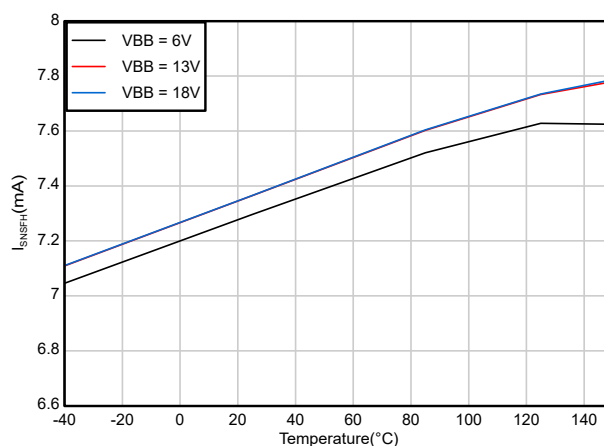


図 6-6. I_{SNS} 故障 High レベル電流と温度との関係

6.8 代表的特性 (続き)

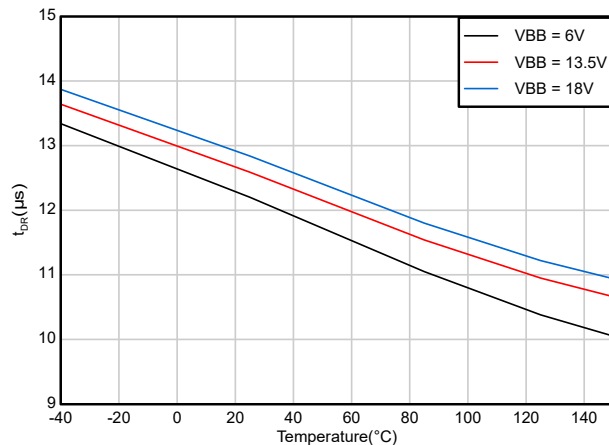


図 6-7. チャネルターンオン遅延時間 (t_{DR}) と温度との関係

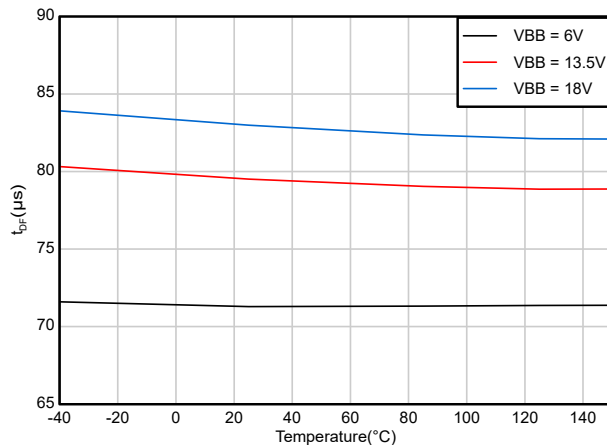


図 6-8. チャネルターンオフ遅延時間 (t_{DF}) と温度との関係

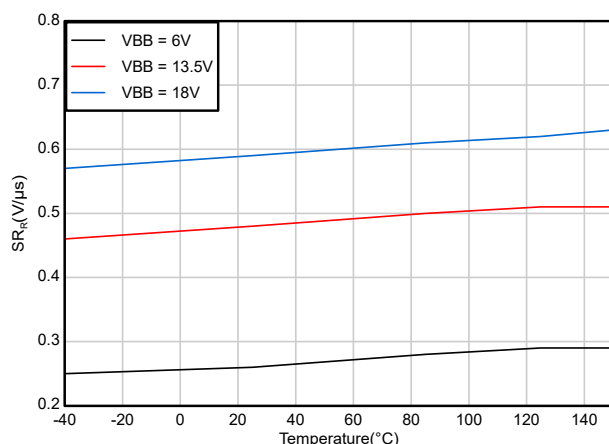


図 6-9. VOUT 立ち上がりスループレート (SR_R) と温度との関係 (P バージョン)

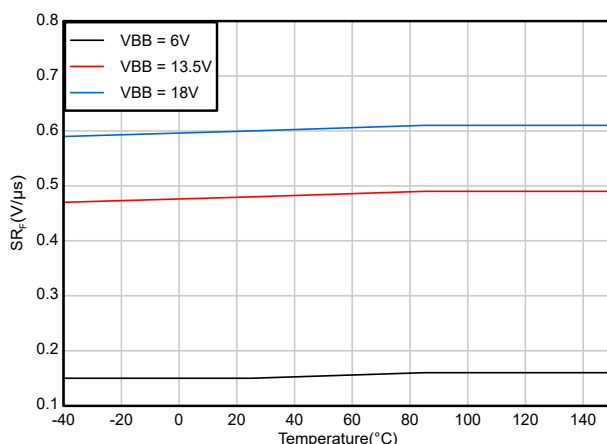


図 6-10. VOUT 立ち下がりスループレート (SR_F) と温度との関係 (P バージョン)

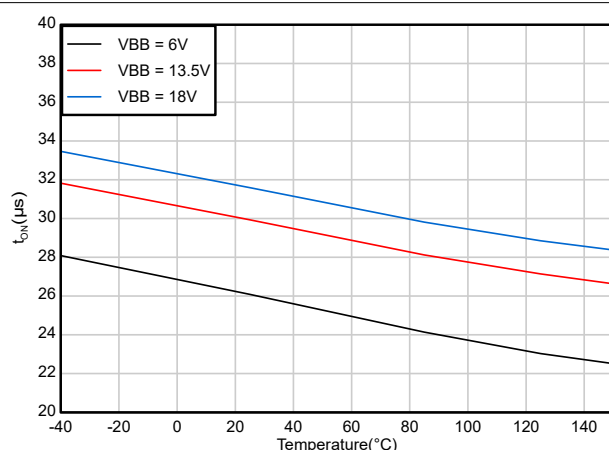


図 6-11. チャネルターンオン時間 (t_{ON}) と温度との関係

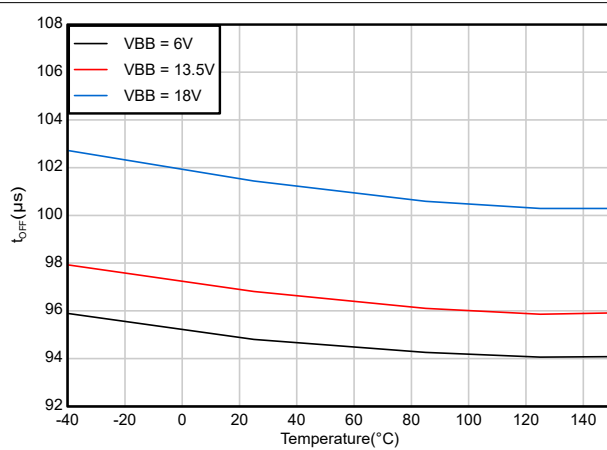


図 6-12. チャネルターンオフ時間 (t_{OFF}) と温度との関係

6.8 代表的特性 (続き)

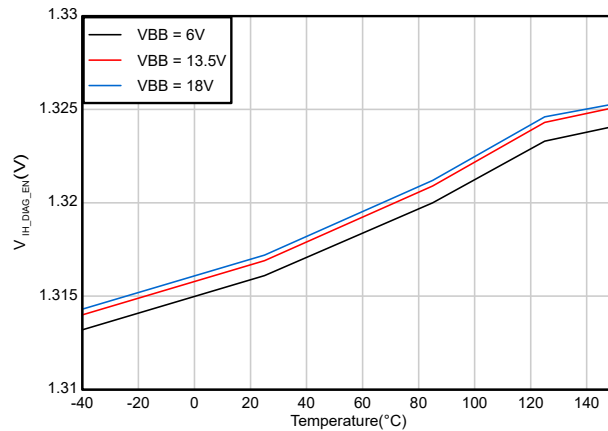


図 6-13. DIAG_EN 入力電圧 High レベルと温度との関係

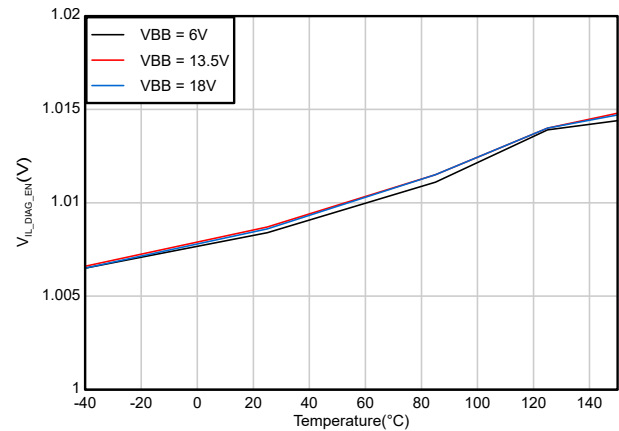


図 6-14. DIAG_EN 入力電圧 Low レベルと温度との関係

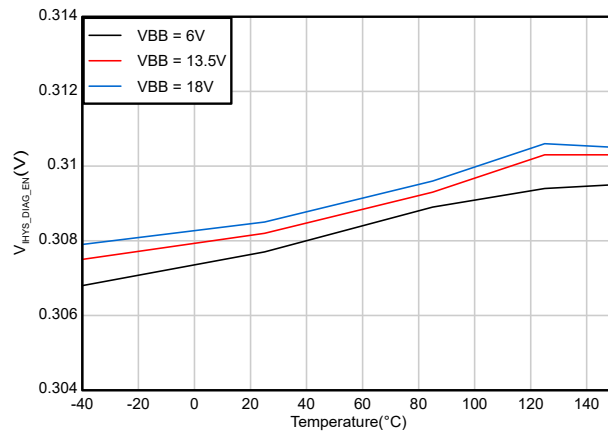


図 6-15. DIAG_EN 入力電圧ヒステリシスと温度との関係

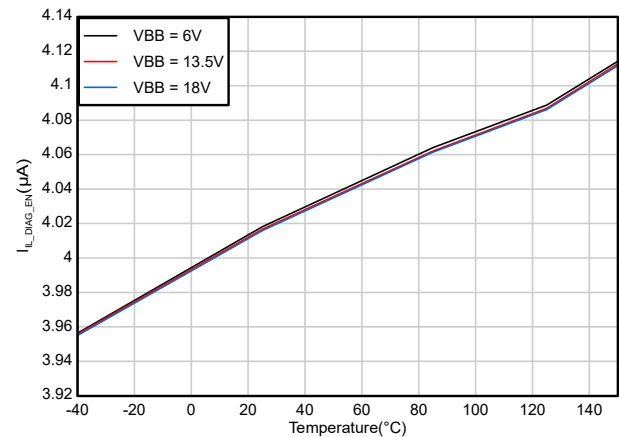


図 6-16. DIAG_EN 入力電流 Low レベルと温度との関係

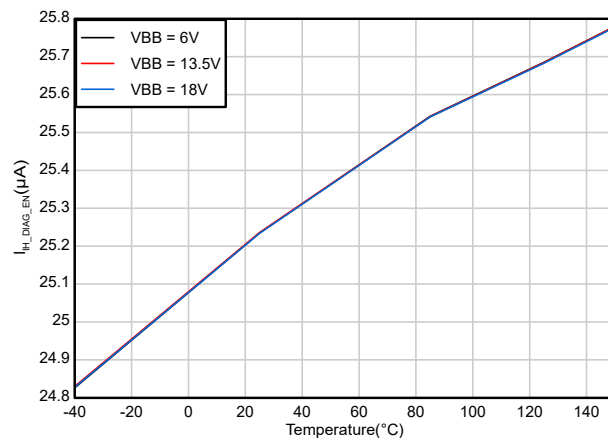


図 6-17. DIAG_EN 入力電流 High レベルと温度との関係

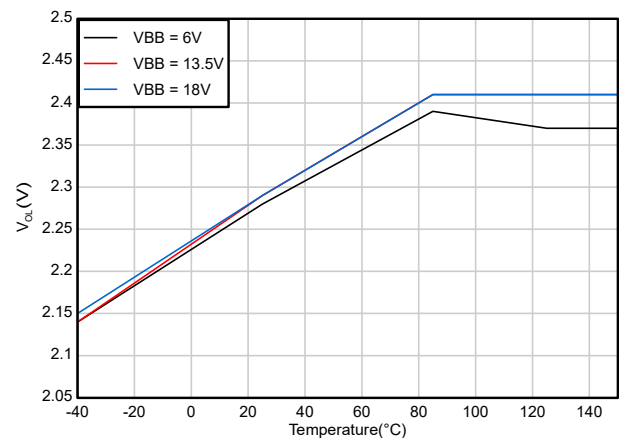


図 6-18. 開放負荷検出電圧 (V_{OL}) と温度との関係

6.8 代表的特性 (続き)

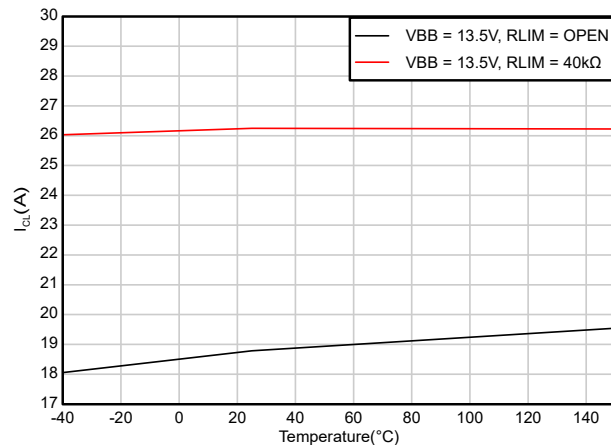


図 6-19. 電流制限レギュレーションレベル (I_{CL}) と温度との関係

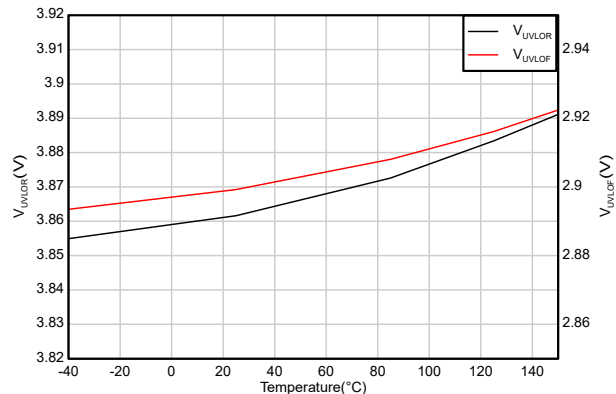


図 6-20. 低電圧誤動作防止スレッショルド (V_{UVLOR} 、 V_{UVLOF}) と温度との関係

7 パラメータ測定情報

データシート全体の参考として、[図 7-1](#) に各ピンの電流の方向を矢印で示します。すべての電圧は、グランド プレーンを基準として測定されます。

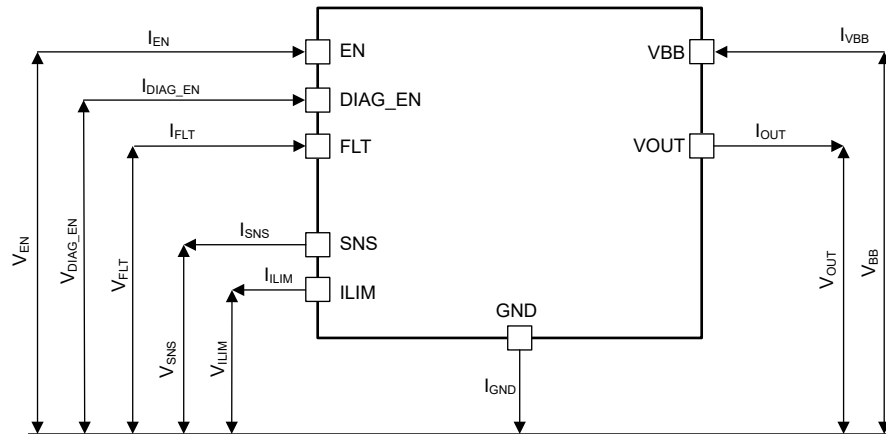
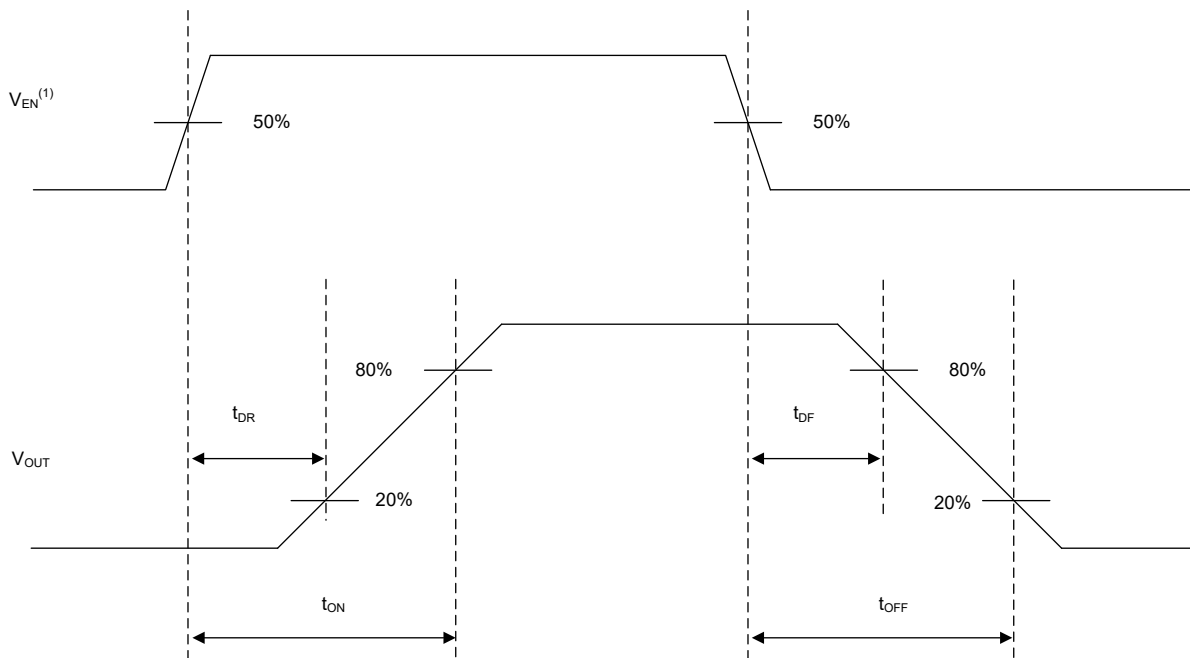


図 7-1. 電圧および電流の規則



Rise and fall time of V_{EN} is 100 ns.

図 7-2. スイッチング特性の定義

8 詳細説明

8.1 概要

TPS1HC03-Q1 は シングル チャネル で、完全に保護されたハイサイドパワースイッチであり、NMOS パワー FET およびチャージポンプが内蔵されています。包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。デバイスは、デジタルとアナログセンス出力の両方をサポートする二つのピンを提供します。診断が無効のときは、電流センス出力を高インピーダンス状態に設定できるため、複数のデバイス間でマイコンアナログ・インターフェイスを多重化できます。

このデバイスは、FET を有効にする専用ロジックピンと、診断出力を有効にする個別の **DIAG_EN** ピンを備えています。診断機能を有効にすると、アナログ電流センスが **SNS** ピンに出力されます。また、デバイスにはマイコンへの割り込みとして使用する、オープンドレイン構造のグローバル **FLT** ピンも実装されています。故障状態が発生した場合、ピンは **GND** にプルダウンされます。マイコンの電源レベルに合わせるのに、外部プルアップが必要です。

高精度の電流検出により、インライン キャリブレーションを追加することなく、さらに優れたリアルタイム監視と高精度の診断ができるようになります。電流ミラーを使用して、負荷電流の $1/K_{SNS}$ がソースされ、これは **SNS** ピンの抵抗にわたる電圧として反映されます。**SNS** ピンから I_{SNSFH} の電流を供給することにより、**SNS** ピンは故障を通知することも可能です。故障時の **SNS** ピンの電圧は $I_{SNSFH} \times R_{SNS}$ で表されます。この電圧が **MCU** の **ADC** 許容電圧範囲を外れる場合、**SNS** ピンに外部ツェナー ダイオードまたは抵抗デバイダを接続します。

デバイスにはプログラマブル電流制限機能が搭載されており、スタートアップの際の大容量充電時や短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性が大きく向上されます。デバイスの高精度電流制限値は、**20A** ～ **57A** の外付け抵抗を使用して設定できます。このデバイスには、サーマルレギュレーションあり/なしによる電流制限設定も用意されています。サーマルレギュレーションされた電流制限は、スタートアップ時に大容量のコンデンサを充電する際に役立ちます。サーマル・レギュレーションなしの電流制限設定は、大きなモータのストール電流や電球負荷などの負荷に対して有効です。

リレー、ソレノイド、ポンプ、モーターなどの誘導性負荷のエネルギーをスイッチオフするため、電圧クランプが組み込まれています。プロセス技術と優れた **IC** レイアウトによって **TPS1HC03-Q1** デバイスは、優れた消費電力容量を実現でき、これによりほとんどの場合に外部のフリーホイール回路が不要になります。詳細については、「誘導性負荷のスイッチオフ・クランプ」を参照してください。

TPS1HC03-Q1 デバイスを、バルブ、**LED**、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド パワー スイッチとして使用します。

8.2 機能ブロック図

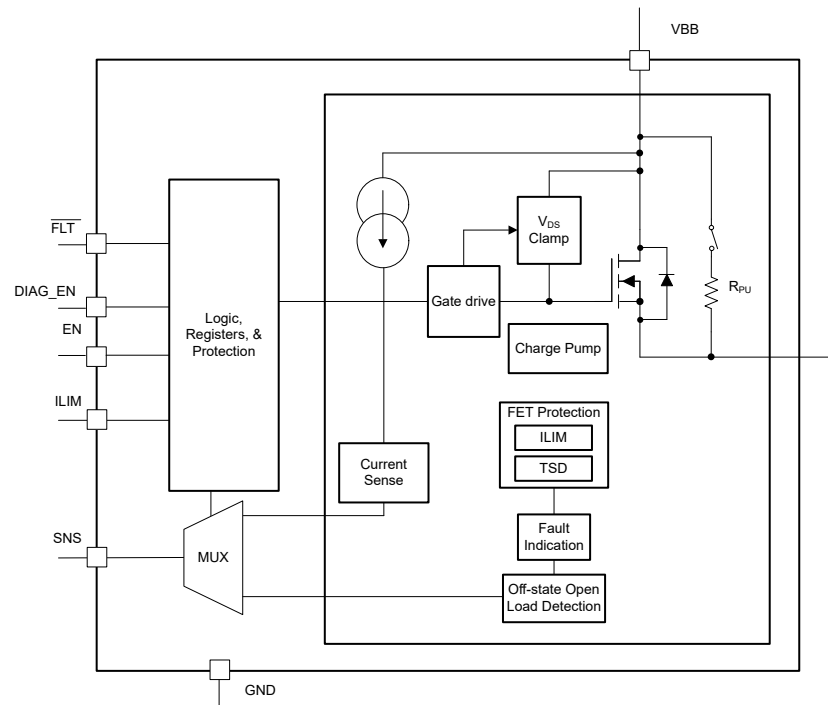


図 8-1. 機能ブロック図

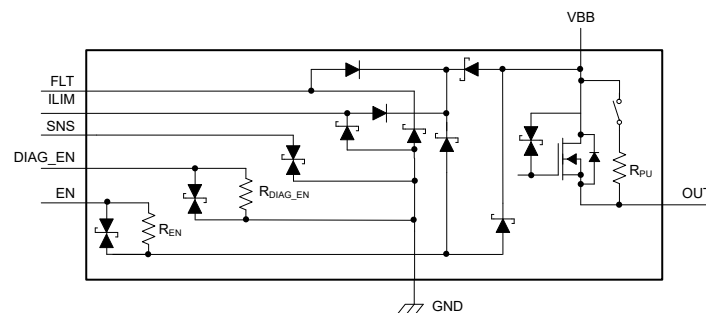


図 8-2. 内部ダイオード構成図

上図は、デバイス内部のダイオード構成を示しています。GND ピンと低電圧 IO ピンの間には双方向ダイオードが配置されており、内部プルダウン抵抗とともに電圧クランプを提供し、ピンを既知の状態に保ちます。FLT ピンおよび ILIM ピンには、VBB までの電圧に耐える内部保護構造が実装されており、隣接ピン短絡に対して高い堅牢性を備えています。また、パワー スイッチ両端には、双方向のツェナーダイオードとダイオードで構成されるドレイン–ソースクランプ構造が実装されており、誘導性エネルギーの消磁からデバイスを保護します。

8.3 機能説明

8.3.1 入力電圧スレッシュホールド

デバイスには以下の入力電圧スレッシュホールドがあります：

- VBB 低電圧誤動作防止スレッシュホールド (V_{UVLOR} 、 V_{UVLOF}) によってデバイスのターンオン/オフ電圧が決まります。
- VBB 検出 1 スレッシュホールド (V_{DET1}) によって、デバイスの VDS クランプ電圧 (V_{clamp}) スイッチング、および VBB 全体の I_{CL} と I_{CB} フォールドバックが決まります。
- VBB 検出 2 スレッシュホールド (V_{DET2}) によって、VBB 全体の I_{CL} と I_{CB} フォールドバックが決まります。

- VBB の高電圧ウェークアップスレッシュホールド (V_{HV_R} , V_{HV_F}) によって、スタンバイ状態からスリープ状態へのデバイス遷移が決まります。 V_{HV_R} スレッシュホールド値が (V_{DET1} または V_{DET2}) の立ち上がりスレッシュホールドを上回る場合、 V_{HV_R} スレッシュホールドによって VDS クランプ電圧 (V_{clamp}) スイッチングも決まります。

8.3.2 高精度電流センス

高精度の電流センス機能により、キャリブレーションを追加することなく、より優れたリアルタイム監視効果と高精度の診断機能を得ることができます。電流ミラーを使用して負荷電流の $1/K_{SNS}$ を調達し、SNS ピンと GND の間の外付け抵抗に流して、SNS ピンの電圧として反映させます。

K_{SNS} は、出力電流とセンス電流との比です。電気的特性に記載されている K_{SNS} の精度は、温度と電源電圧を考慮した値です。各デバイスは製造時に内部で校正されているため、ユーザーによる後校正は必要ありません。

センス抵抗値、 R_{SNS} を選択して、システムで測定すべき電流範囲を最大化します。 R_{SNS} の値は、アプリケーションの必要性に基づいて選択します。システムが最小負荷電流 $I_{LOAD, min}$ を測定する必要がある場合、 R_{SNS} の最小値は、ADC の最小許容電圧 $V_{ADC, min}$ によって制限されます。 I_{SNSFH} (電気的特性 で、最低仕様を確認ください) が故障状態時にある場合、 R_{SNS} の最大値は ADC の最大許容電圧 $V_{ADC, max}$ で制限されます。故障状態時の SNS ピン電流、 I_{SNSFH} は、最大読み取り可能電流と故障状態時の差を判定するのに十分なヘッドルーム電圧 (V_{HR}) を確保するため、最大負荷電流 ($I_{LOAD, max}$) における SNS ピン電流よりも大幅に大きくする必要があります。SNS ピンに外付けツェナーダイオードや分圧抵抗を使用せず、式 1 を使用して R_{SNS} の値を計算します。

$$\frac{V_{ADC, min} \times K_{SNS}}{I_{LOAD, min}} \leq R_{SNS} \leq \frac{V_{ADC, max}}{I_{SNSFH}} \quad (1)$$

電流センス電圧の分解能を向上させるため、外付けのツェナーダイオードまたは抵抗分圧器を SNS ピンに接続して、故障状態時に SNS ピンの電圧を ADC の最大許容電圧 $V_{ADC, max}$ にクランプできます。この場合、 R_{SNS} 抵抗を選択して、最大読み取り可能電流と故障状態の間に必要なヘッドルーム電圧 (V_{HR}) を確保する必要があります。このシナリオの R_{SNS} の値を計算するには、式 2 を使用します。

$$\frac{V_{ADC, min} \times K_{SNS}}{I_{LOAD, min}} \leq R_{SNS} \leq \frac{[V_{ADC, max} - V_{HR}] \times K_{SNS}}{I_{LOAD, max}} \quad (2)$$

一部のアプリケーションでは、負荷電流範囲が大きい場合、上記の適用可能な境界式は下限と上限のいずれかしか満たすことができません。このような場合、 R_{SNS} を大きくする測定可能な低い電流値を強調できます。同様に、より高い電流を測定したい場合、 R_{SNS} の値を小さくしてください。逆極性保護用に GND ネットワークを使用する場合、SNS ピンの電圧が許容される最大 ADC 電圧を超えないように、GND ネットワークでの電圧降下を考慮する必要があります。

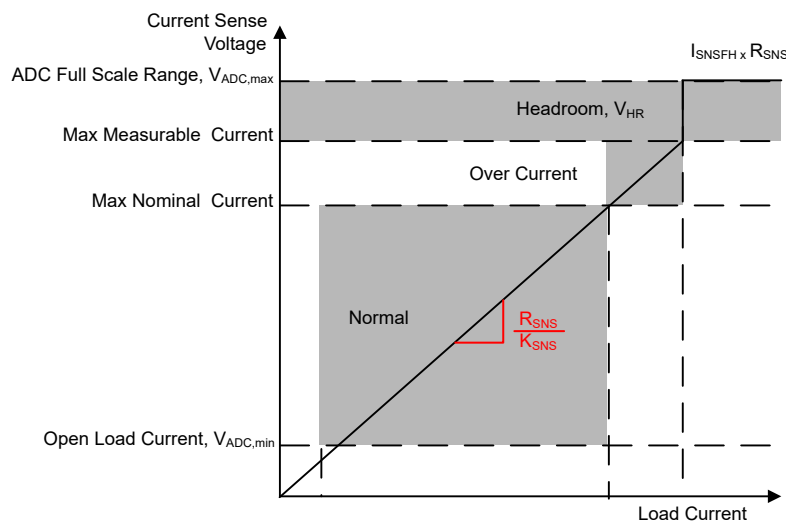


図 8-3. 電流センスピンの電圧表示

システムが読み取る最大電流 $I_{LOAD,max}$ は、電流制限スレッシュホールド以下にする必要があります。これは、電流制限スレッシュホールドをトリップすると SNS ピン電流が I_{SNSFH} になるためです。負荷電流が電流制限スレッシュホールドより小さく、かつ I_{LOAD,max_KSNS} ($KSNS$ に規定されている最大負荷電流) を超えていて、他の故障状態がない場合、センス電流は $I_{LOAD,max_KSNS} / K_{SNS}$ にクランプされます。以下の図は、 $1k\Omega$ の R_{SNS} を使用するデバイスのチャンネル 1 での負荷ステップにおける SNS ピンの動作を示します。



図 8-4. 負荷電流変化時の SNS ピン電圧 ($R_{SNS} = 1k\Omega$)

8.3.2.1 SNS 応答時間

いくつかのアプリケーションでは、高周波数、低デューティサイクルの PWM で動作する場合があります。このようなアプリケーションでは、 SNS 出力の高速な立ち上がりが必要となります。たとえば、 $250Hz$ で 5% のデューティサイクルの PWM では、オン時間はわずか $200\mu s$ です。マイコンの ADC は、規定された立ち上がり時間経過後に SNS 信号をサンプリングできます。以下の図は、 EN および $DIAG_EN$ がそれぞれ "High" にプルされた場合の SNS 信号の応答時間を示しています。デバイスの SNS 信号は応答が速いため、このようなアプリケーションにおいて ADC による電流検出を容易に行うことができます。



図 8-5. DIAG_EN による SNS 応答時間 (t_{SNSION1})



図 8-6. EN による SNS 応答時間 (t_{SNSION3})

注

制御信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間は 100ns です。制御信号には以下が含まれます。EN、DIAG_EN。

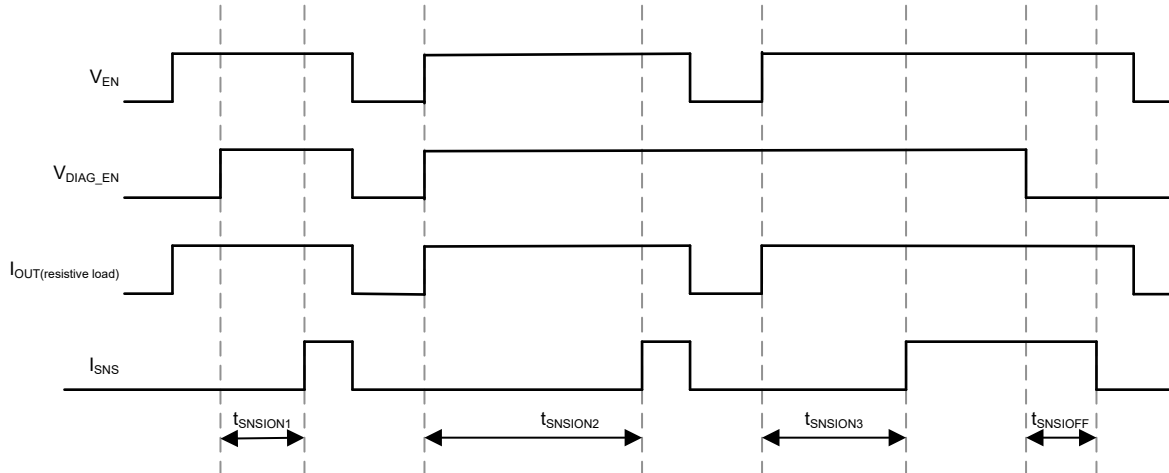


図 8-7. EN または DIAG_EN からの SNS 立ち上がり時間

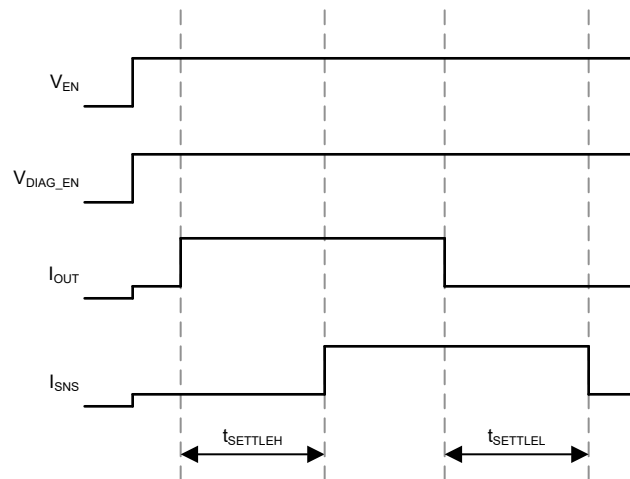


図 8-8. 負荷ステップからの SNS 立ち上がり時間

8.3.2.2 SNS 出力フィルタ

内部アーキテクチャの特性により、SNS ピン信号には約 1.6MHz の周波数成分を持つリップルが含まれます。R_{SNS} の値に基づき、SNS ピンに適切な C_{SNS} を接続することで、このリップル成分を除去し、SNS ピン電圧のピークツーピークのリップルを低減できます。公称負荷電流時に 13.5V V_{BB} で観測される標準的なピークツーピークの SNS リップル電圧は 85mV です。このリップル電圧は、150pF の C_{SNS} を 1kΩ の R_{SNS} 抵抗と並列に接続したローパスフィルタを使用することで、50mVp-p に低減できます。設計者は、システム要件に基づいて C_{SNS} コンデンサの値を選択できます。大きな値を選択すると、フィルタリング特性を向上させることができます。小さな値を選択すると、より高速な過渡応答が可能になります。たとえば、1kΩ の R_{SNS} に 150pF の C_{SNS} を組み合わせた場合、SNS 電圧の整定時間に 750ns (5RC) が追加されます。

基板設計では、複数のデバイスで SNS リップルをフィルタリングするために共通の C_{SNS} を使用することで、基板面積を削減できます。以下の図に、150pF の C_{SNS} を 1kΩ R_{SNS} 抵抗と並列に接続した場合と接続しない場合の SNS リップル動作を示します。

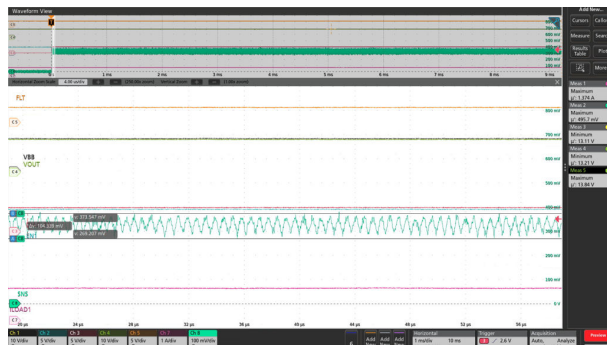


図 8-9. C_{SNS} なしの場合の SNS ピンのリップル、 $V_{BB} = 13.5V$ 、 $I_{LIM} =$ 開放、 $R_L = 10\Omega$ 、 $R_{SNS} = 1k\Omega$ 、 $T_A = 25^\circ C$ にて



図 8-10. 150pF の C_{SNS} ありの場合の SNS ピン リップル、 $V_{BB} = 13.5V$ 、 $I_{LIM} =$ 開放、 $R_L = 10\Omega$ 、 $R_{SNS} = 1k\Omega$ 、 $T_A = 25^\circ C$ にて

8.3.2.3 デバイス間での電流検出多重化

図 8-11 は、共通の R_{SNS} 抵抗を用いて 2 つのデバイス間で SNS ピンを共有する構成を示しています。同様に、複数のデバイスを構成して SNS ピンを共有します。DIAG_EN を "High" に設定すると、対応する EN 信号により、選択されたデバイスの電流センス出力が有効になり、負荷電流に比例した電流 (I_{LOAD} / K_{SNS}) が外付けセンス抵抗を介して SNS ピンからグラウンドへ流れます。この電流は、MCU の ADC 入力で測定可能な電圧として現れます。DIAG_EN を Low に設定すると、SNS ピンは高インピーダンス (トリステスト) 状態になります。この機能により、複数の TPS1HC03-Q1 デバイスが同一の検出抵抗および ADC 入力ピンを共有でき、任意の時点で SNS ピンを駆動するデバイスは 1 つだけとなるよう制御できます。

K_{SNS} は、デバイス ファミリ内で最大定格負荷電流時の SNS ピン電流が同一となるように設計されています。これにより、異なる電流定格を持つデバイス同士でも、同一の R_{SNS} 抵抗値および ADC フルスケール範囲を用いて電流検出の多重化が可能になります。

複数デバイス間で電流検出の多重化を行う場合、DIAG_EN を Low に設定した無効状態のデバイスから流れ込む SNS ピンリーク電流 ($I_{SNSleak_disabled}$) が、アクティブなデバイスの電流測定に誤差を生じさせる要因となります。TPS1HC03-Q1 デバイスでは、無効状態の SNS ピンリーク電流が非常に小さく (典型値: 数 nA)、より多くのデバイスを多重化構成に組み込むことが可能です。

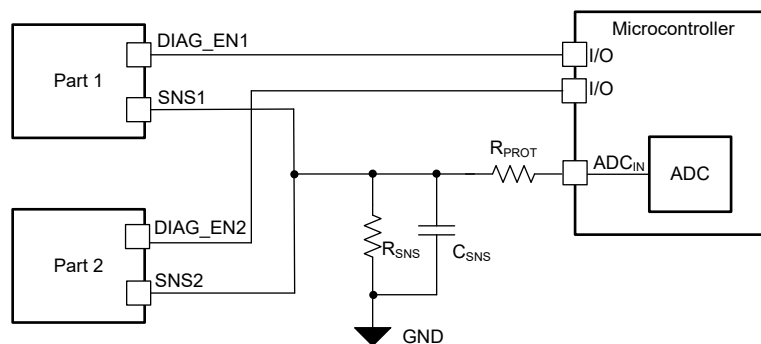


図 8-11. 複数デバイス間での SNS 多重化

8.3.3 過電流保護

TPS1HC03-Q1 は、過電流イベント時のサーマル・シャットダウンおよび電流制限保護機能を備えており、内部パワー MOSFET を保護します。これらの保護機能は、デバイスが ACTIVE 状態のときイネーブルされます。電流制限フォルトは、設定された電流制限値の約 80% ($I_{CL_FLT_Trip}$) に到達した時点でアサートされます。

8.3.3.1 調整可能な電流制限

TPS1HC03-Q1 は高精度で調整可能な電流を提供し、より高い信頼性を実現し、短絡時や大容量のパワーアップ時に電源を保護します。調整可能な電流制限は、電流制限値をより低いレベルに設定することで PCB パターン、コネクタ サイズ、および前の電力段のキャパシティを削減し、システムのコストを節減することができます。

デバイスの電流制限値は、ILIM ピンの外付け抵抗により調整可能です。デバイスは、FET とコントローラの相対温度に基づいて電流制限値を調整する、サーマルレギュレーション付き電流制限を備えた ILIM 設定を提供します。これにより FET の急速な発熱を防ぎ、相対的なサーマルシャットダウンの発生が遅延するため、起動時に大容量コンデンサを充電することが可能になります。ILIM ピンを GND に短絡した場合、サーマルレギュレーションなしで電流制限を構成でき、デバイスは設定された ILIM 値で電流を制限します。表 8-1 に、ILIM ピンの構成に基づいて可能な各種の設定を示します。電流制限値を決定するには、 R_{LIM} の実効抵抗値 (許容誤差、経年劣化などのその他の誤差を含む) を考慮する必要があります。

異なる突入電流制限値と定常電流制限値を設定するときは、デバイスがオンのときに、ILIM ピンの外付け抵抗値 (R_{LIM}) を動的に変更することができます。MOSFET ベースの制御方式を採用すると、電流制限値が簡単に変更できるようになります。ただし、ILIM ピンの部品とレイアウトを慎重に考慮し、ピンの静電容量を最小限に抑える必要があります。ILIM ピンに 100pF 以上の静電容量があると、電流制限機能に影響を与える可能性があります。動的電流制限には、低入力静電容量を持つ MOSFET を選択してください。

表 8-1. ILIM ピンによる電流制限設定

ILIM ピン上の R_{LIM} 値	TYP $I_{CL} = K_{CL}/R_{LIM}$	サーマルレギュレーション
ILIM = GND または $R_{LIM} < 17.5k\Omega$	最大設定値: 57A	無効
$R_{LIM} = 17.5k\Omega$	57A	有効
$17.5k\Omega < R_{LIM} < 50k\Omega$	$I_{CL} = K_{CL}/R_{LIM}$	有効
$R_{LIM} = 50k\Omega$	20A	有効
ILIM = オープンまたは $R_{LIM} > 50k\Omega$	最小設定値: 20A	有効

このデバイスは、高速トリップのサーキット・ブレーカ機能も備えており、ホット短絡とも呼ばれるチャネルがイネーブルになっている間に短絡が発生した場合に使用されます。 I_{CB} スレッショルドに達すると、デバイスは迅速にチャネルをオフにし、内部 MOSFET を保護します。さらに、このデバイスは高電圧で電流制限フォールドバック機能を備えているため、高 V_{DS} イベント時に内部パワー MOSFET を保護できます。

システムで発生する可能性があるさまざまな過電流イベントは次のとおりです。

- ホットショート
- ショートへのイネーブル
- 過電流 (低速クリープ)

デバイスが有効にされ、デバイス出力に短絡状態が生じたときに、ホット ショートが発生します。MOSFET の出力がすでに短絡状態にあり、デバイスが短絡状態にイネーブルされたときに、短絡へのイネーブルが発生します。出力にゆっくりと立ち上がり過電流イベントが発生すると、「低速クリープ」とも呼ばれる電流過負荷が発生することがあります。

次のセクションでは、サーマル シャットダウンありおよびサーマル レギュレーションなしの電流制限機能、さらにサーキットブレーカおよびサーマル シャットダウン機能によって、発生する可能性のあるさまざまな過電流条件からの保護を実現する方法について説明します。

8.3.3.1.1 サーマル レギュレーションによる電流制限

ILIM の設定に基づいて、サーマル レギュレーションで電流を制限するようにデバイスを構成します。サーマル レギュレーションは、MOSFET の相対温度 ($T_{J,FET}$) とコントローラの温度 ($T_{J,CONTROLLER}$) を監視し、相対的な温度に基づいて電流制限を下げることで機能します。

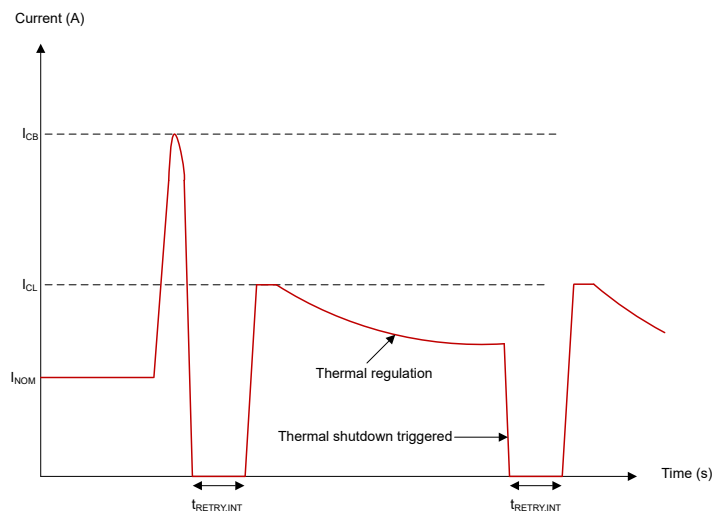


図 8-12. サーマル レギュレーションによるオン状態短絡動作

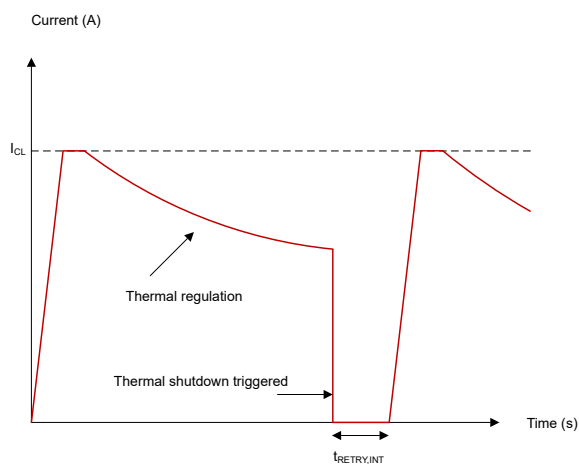


図 8-13. サーマル レギュレーションによる短絡へのイネーブル

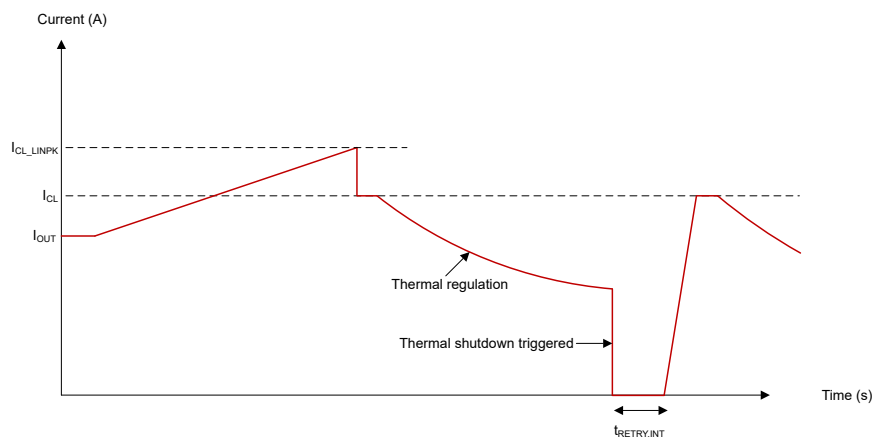


図 8-14. サーマル レギュレーションによる過負荷動作 (電流のクリープ)

8.3.3.1.2 サーマル レギュレーションなしでの電流制限

ILIM の設定に基づいて、サーマル レギュレーションなしで電流を制限するようにデバイスを構成します。デバイスは、ILIM ピンの設定に基づいて電流を制限します。本デバイスの適用アプリケーションとしては、大きな突入電流を伴うパルス負荷およびモーター負荷が挙げられます。

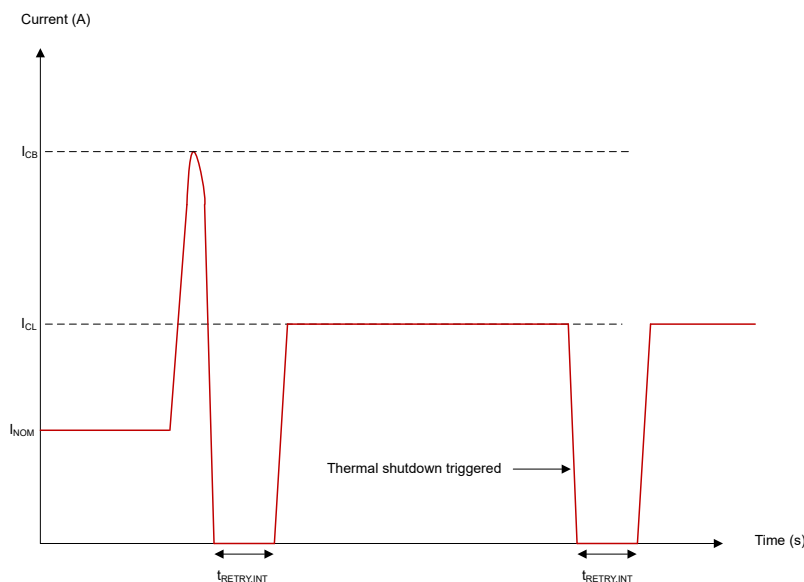


図 8-15. サーマル レギュレーションなしのオン状態短絡動作

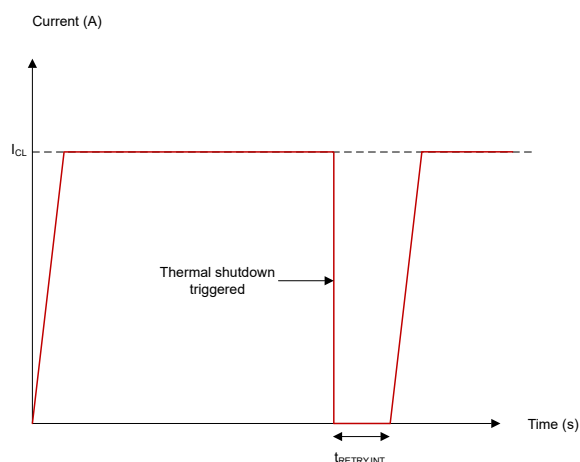


図 8-16. サーマル レギュレーションなしでの短絡へのイネーブル

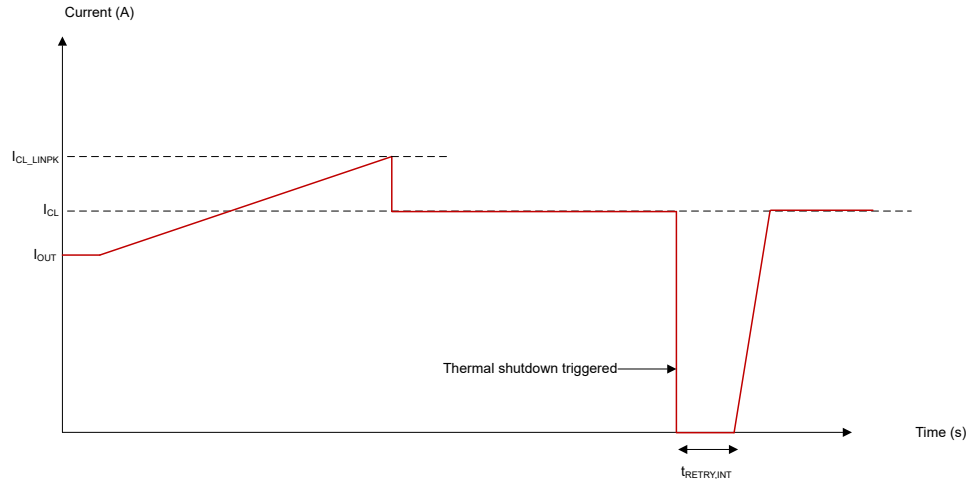


図 8-17. サーマル レギュレーションなしでの過負荷動作 (電流クリープ)

8.3.3.1.3 電流制限フォールドバック

高 V_{DS} 電圧時に MOSFET を過電流から保護するために、デバイスは、より高い電流に対する I_{CL} および I_{CB} フォールドバック メカニズムを備えています。 V_{BB} 電圧が V_{DET1} を上回る場合、サーキット ブレーカ スレッシュホールドは I_{CB} の $1/2$ にフォールド バックします。 V_{BB} 電圧が V_{DET2} を上回る場合、 I_{CB} は I_{CB} の $1/3$ にフォールド バックします。 $V_{BB} > V_{DET1}$ スレッシュホールドの場合、 I_{CB} の $1/2$ のフォールドバック サーキット ブレーカ スレッシュホールドに達すると、デバイスはチャネルを迅速にオフにして内部 MOSFET を保護します。 $V_{BB} > V_{DET2}$ スレッシュホールドの場合、 I_{CB} の $1/3$ のフォールドバック サーキット ブレーカ スレッシュホールドに達すると、デバイスはチャネルを迅速にオフにして内部 MOSFET を保護します。

同様に、デバイスの電流制限も V_{BB} の増加に伴ってフォールド バックされます。以下の図に、 I_{CB} と設定した I_{CL} 値に基づくデバイスの電流制限フォールドバック動作を示します。 $I_{CL} > I_{CB} / 3$ に設定されている場合、デバイスの電流制限値は V_{BB} 全体にわたって $I_{CB} / 3$ 未満にフォールド バックされません。フォールドバック状態でのデバイスの電流制限の変動は、公称電流制限の変動と同じです。

- **Case1:** 設定した $I_{CL} \leq I_{CB} / 3$: デバイスはフォールドバックを行わず、 V_{BB} 全体にわたって設定された I_{CL} 値を維持します。
- **Case2:** $I_{CB} / 2 \geq$ 設定した $I_{CL} > I_{CB} / 3$: デバイスは V_{DET2} まで設定した I_{CL} 値を維持し、 V_{DET2} で $I_{CB} / 3$ 値にフォールド バックします。
- **Case3:** 設定した $I_{CL} > I_{CB} / 2$: デバイスは V_{DET1} まで設定された I_{CL} 値を維持し、 V_{DET1} で $I_{CB} / 2$ 値にフォールド バックします。その後、 V_{DET2} で $I_{CB} / 3$ 値に再度フォールド バックします。

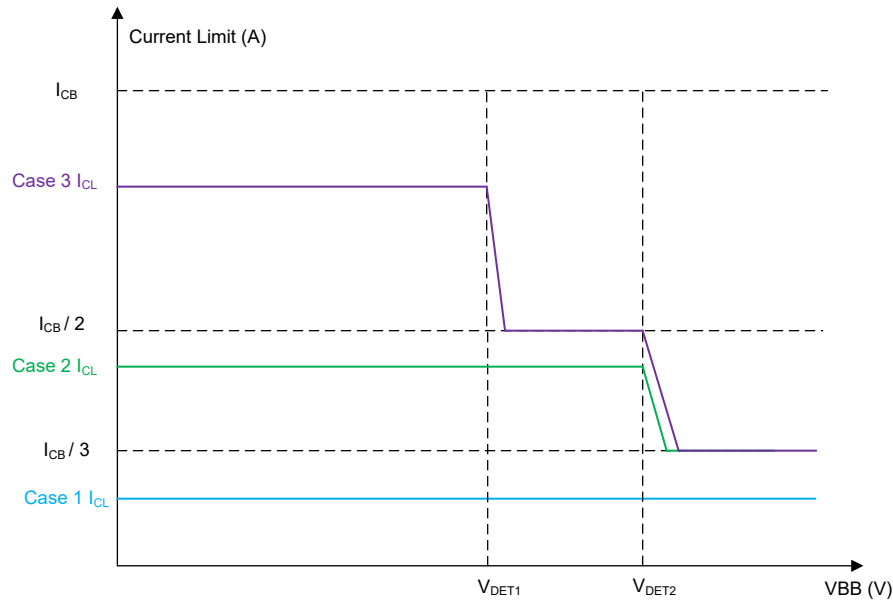


図 8-18. VBB による電流制限フォールドバック

以下の図に、VBB 電圧が上昇した場合のデバイスの電流制限フォールドバック動作を示します。

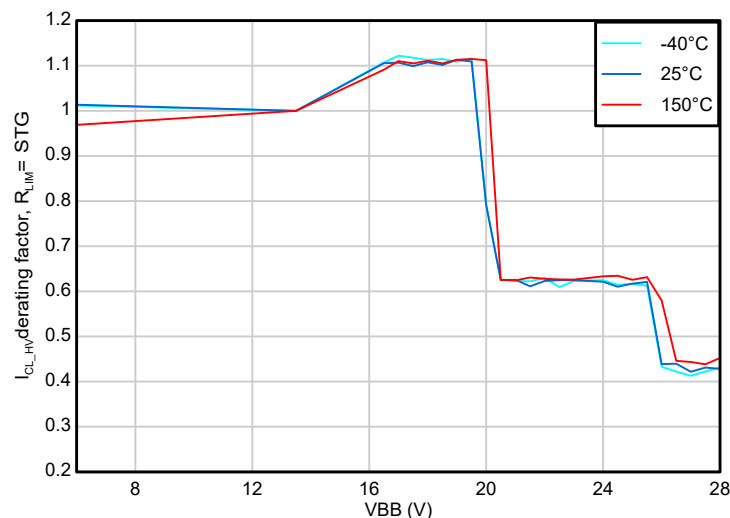


図 8-19. 両チャンネルでの電流制限ディレーティング係数 (I_{CL_HV}) と VBB との関係、 $R_{LIM} = GND$ にて

8.3.3.1.4 電流制限精度

デバイスの可変電流制限値を、表 8-1 に記載された R_{LIM} 抵抗の有効範囲に対して 式 3 を用いて設定します。

$$R_{LIM} = \frac{K_{CL}}{I_{CL}} \quad (3)$$

電流制限の精度は、 R_{LIM} 抵抗の許容差および 電氣的特性 に記載されている K_{CL} パラメータのばらつき (K_{CL_min} 、 K_{CL_max}) に依存します。 R_{LIM} 抵抗の許容誤差が 1% であることを考慮して、以下の式は I_{CL} の最小値および最大値の計算を示しています。

$$I_{CL} (max) = \frac{K_{CL_max}}{R_{LIM_min}}, \text{ where } R_{LIM_min} = 0.99 \times R_{LIM} \quad (4)$$

$$I_{CL}(\min) = \frac{K_{CL_min}}{R_{LIM_max}}, \text{ where } R_{LIM_max} = 1.01 \times R_{LIM} \quad (5)$$

R_{LIM} を GND 接続またはオープンとした場合、 K_{CL} パラメータのばらつきが I_{CL} のばらつきに寄与します。

8.3.3.2 サーマル シャットダウン

デバイスにはパワー FET に温度センサが搭載されており、デバイスのコントローラ部分には、FET の温度 ($T_{J, FET}$) およびコントローラの温度 ($T_{J, CONTROLLER}$) を監視します。デバイスがサーマル シャットダウン障害と見なされる場合は 2 つあります。

- 相対サーマル・シャットダウン (T_{REL}): $T_{J, FET} - T_{J, CONTROLLER} > T_{REL}$
- 絶対サーマル・シャットダウン (T_{ABS}): $T_{J, FET} > T_{ABS}$

上記のいずれかの故障が発生すると、スイッチはオフになります。

8.3.3.2.1 相対サーマル・シャットダウン

相対的なサーマル・シャットダウンイベントは、グラウンドへの短絡イベントなど、コントローラ温度 ($T_{J, FET}$) に対して FET 温度 ($T_{J, CONTROLLER}$) が急速に上昇する、大きなピーク電力イベントが発生する場合に発生することがあります。相対温度 ($T_{J, FET} - T_{J, CONTROLLER}$) が T_{REL} を超えると、チャンネルがオフになります。

8.3.3.2.2 絶対サーマル・シャットダウン

絶対的なサーマル・シャットダウンは、FET 温度 ($T_{J, FET}$) が T_{ABS} を上回ると発生します。これは、チャンネルが永続的な短絡使用事例など、長い期間にわたって過電流にさらされた場合に発生する可能性があります。FET 温度 ($T_{J, FET}$) が T_{ABS} を超えると、チャンネルがオフになります。

8.3.4 サーマルシャットダウンからの再試行保護メカニズム

サーマル シャットダウンが発生した場合、デバイスはオフになり、システム信頼性を高めるために再試行保護メカニズムを動作させます。図 8-20 は、過電流イベントにおける負荷電流およびその継続時間に応じたデバイスの動作を示します。

負荷電流が電流リミット未満の場合、デバイスはサーマルシャットダウン故障から回復するまで、無限にサーマルシャットダウンの再試行サイクルに入ります。この場合、デバイスのターン オフ時間は、 T_{ABS} または T_{REL} が T_{HYS} レベルを下回るのに必要な冷却時間 (固有の 200μs 遅延あり) で決まります。デバイスが約 500ms の間再試行しない場合、デバイスはラッチ オフできます。これは、PCB 全体が高い周囲温度と同じ温度まで加熱された場合に発生することがあります。この場合、周囲の PCB も高温になるため、デバイスの冷却が遅くなることで、冷却時間が 500ms を超え、デバイスがラッチ オフ状態に移行する場合があります。

デバイスがラッチ オフした場合、EN ピンを "High" から "Low" へ遷移させることで (パルス幅は最小約 20μs) FLT および SNS 信号をリセットできます。その後、チャンネルの出力は最初に High から Low にトグルした後、EN ピンに従います。

電流制限を超える負荷電流の場合、デバイスは過電流イベントの継続時間に基づいた有限回数の再試行サイクルフェーズによる保護メカニズムを実装し、以下のいずれかの故障条件が発生した際にトリガされます:

1. 絶対サーマル・シャットダウン (T_{ABS}): $T_{J, FET} > T_{ABS}$
2. 相対サーマル・シャットダウン (T_{REL}): $T_{J, FET} - T_{J, CONTROLLER} > T_{REL}$
3. 過電流イベント: I_{CB} または I_{CL}

有限となる回数の再試行サイクルフェーズの保護メカニズムは、以下の時間区分で構成されます:

1. 初期の再試行ウィンドウ ($t < t_{RETRY_WINDOW}$):
 - I_{CB} またはサーマルシャットダウンがトリガされた後の期間。
 - 再試行は、最小間隔 $t_{RETRY, INT}$ ごとに実行されます。
 - 各再試行は I_{CB} ピークから始まり、その後、 I_{LIM} 設定に基づくサーマル レギュレーションによる電流制限 (I_{CL}) ピークが続く場合があります。
2. 拡張過電流ウィンドウ ($t > t_{RETRY_WINDOW}$):

- 再試行回数は 6 回に制限されます。
- 最初の再試行サイクルは、最小 $t_{\text{RETRY, EXT}}/2$ の期間で実行されます。
- 続く 5 回の再試行サイクルは、最小 $t_{\text{RETRY, EXT}}$ の期間で実行されます。
- 電流ピークは通常、サーマル レギュレーションがない場合 I_{CL} に制限されます。

3. ラッチオフ条件:

- 6 回の再試行がいずれも不成功となった後に発生します。
- EN ピンのトグル操作によるリセットが必要です。

表 8-2. サーマル・シャットダウン (TSD) への応答

負荷電流	条件		最小の再試行時間
$I_{\text{LOAD}} < I_{\text{CL}}$	-		無制限の再試行。 約 500ms にわたって再試行しない場合、デバイスはラッチオフされます。
$I_{\text{LOAD}} > I_{\text{CL}}$	$t < t_{\text{RETRY_WINDOW}}$		$t_{\text{RETRY, INT}} = 160\mu\text{s}$ (代表値)
	$t > t_{\text{RETRY_WINDOW}}$	$n_{\text{RETRY, EXT}} < 6$	$t_{\text{RETRY, EXT}} = 80\text{ms}$ (代表値)
		$n_{\text{RETRY, EXT}} > 6$	ラッチオフ

上記いずれの再試行条件においても、以下の「再起動」条件が満たされたときに、デバイスが再起動されます。

- 温度復帰: $T_{\text{J, FET}} < (T_{\text{ABS}} - T_{\text{HYS}})$ および $(T_{\text{J, FET}} - T_{\text{J, CONTROLLER}}) < (T_{\text{REL}} - T_{\text{HYS}})$ の場合
- 再試行ウィンドウ: $I_{\text{LOAD}} > I_{\text{CL}}$ の場合、適切な $t_{\text{RETRY_WINDOW}}$ 間隔が経過する必要があります。

$I_{\text{LOAD}} > I_{\text{CL}}$ の場合、再試行タイマが満了し、 T_{ABS} または T_{REL} の温度が T_{HYS} レベルを下回って回復しない場合、温度が T_{HYS} レベルを下回るまでチャネルは再試行を行いません。同様に、過電流が一定時間継続したことによりチャネルがラッチオフした場合、EN ピンを High から Low へ遷移させることで $\overline{\text{FLT}}$ および SNS 信号をリセットできます (パルス幅は最小約 20us)。その後、チャネルの出力は最初に High から Low にトグルした後、EN ピンに従います。

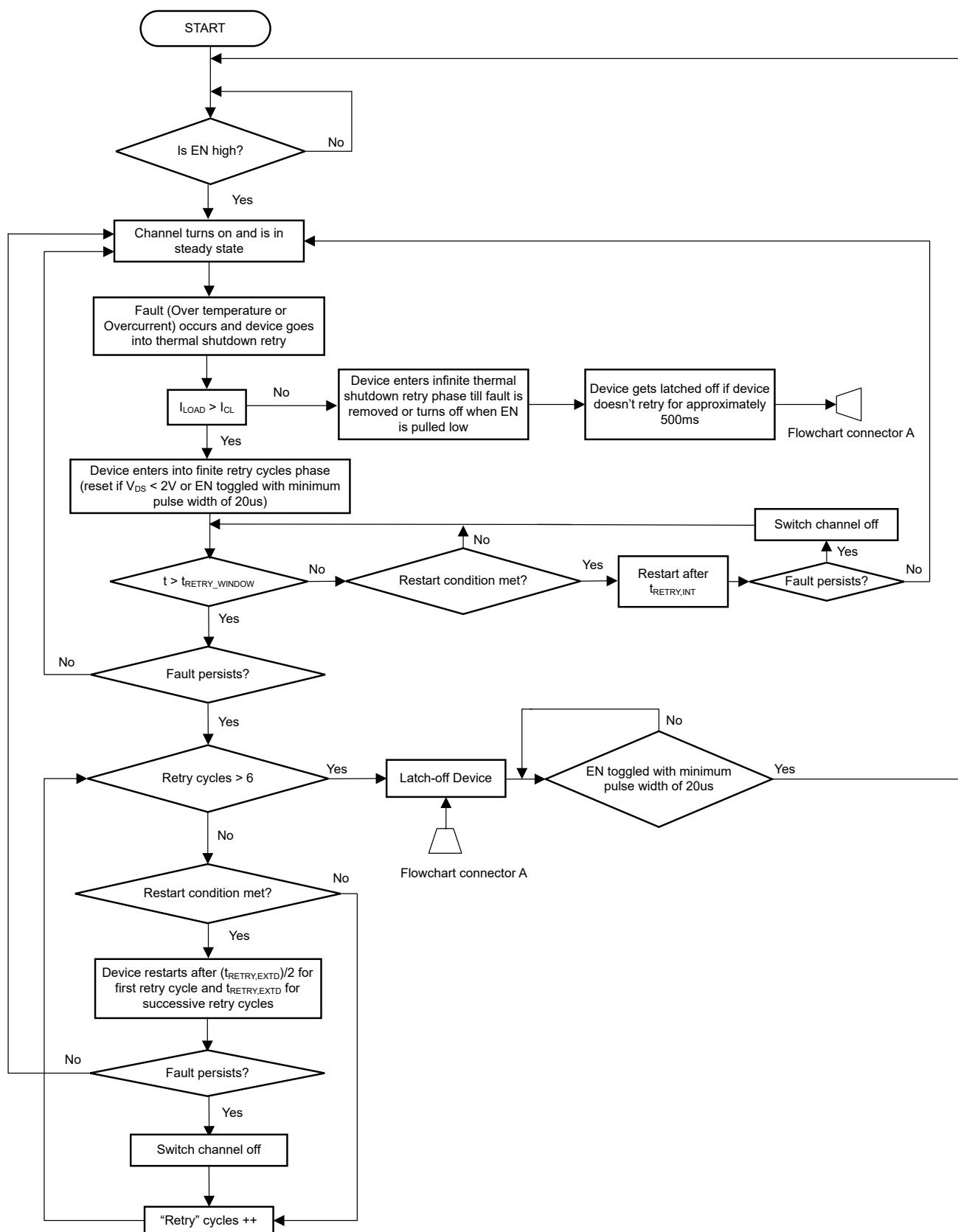


図 8-20. 再試行保護メカニズム

以下の図に、ホット短絡後にサーマルレギュレーションありとなしでそれぞれデバイスが再試行する方法を示します。デバイスが熱障害を検出して再試行動作に入ると、初回の再試行ウィンドウ内で発生する最初の電流ピークが I_{CB} スレッショルドに到達し、ファストトリップ回路ブレーカが動作します。その後が発生する電流ピークはより低くなり、設定された電流制限値 (I_{CL}) に対応します。

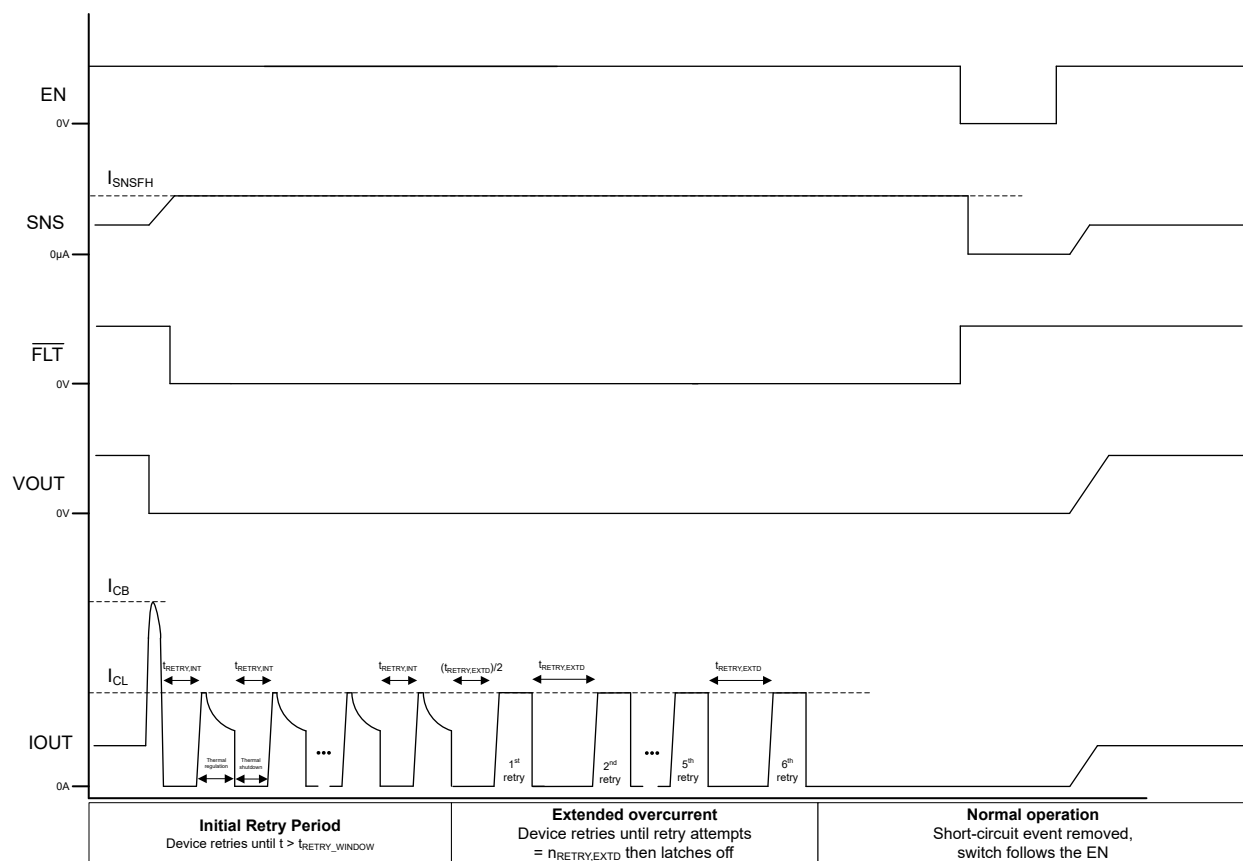


図 8-21. サーマルレギュレーションによるホット短絡後の再試行動作

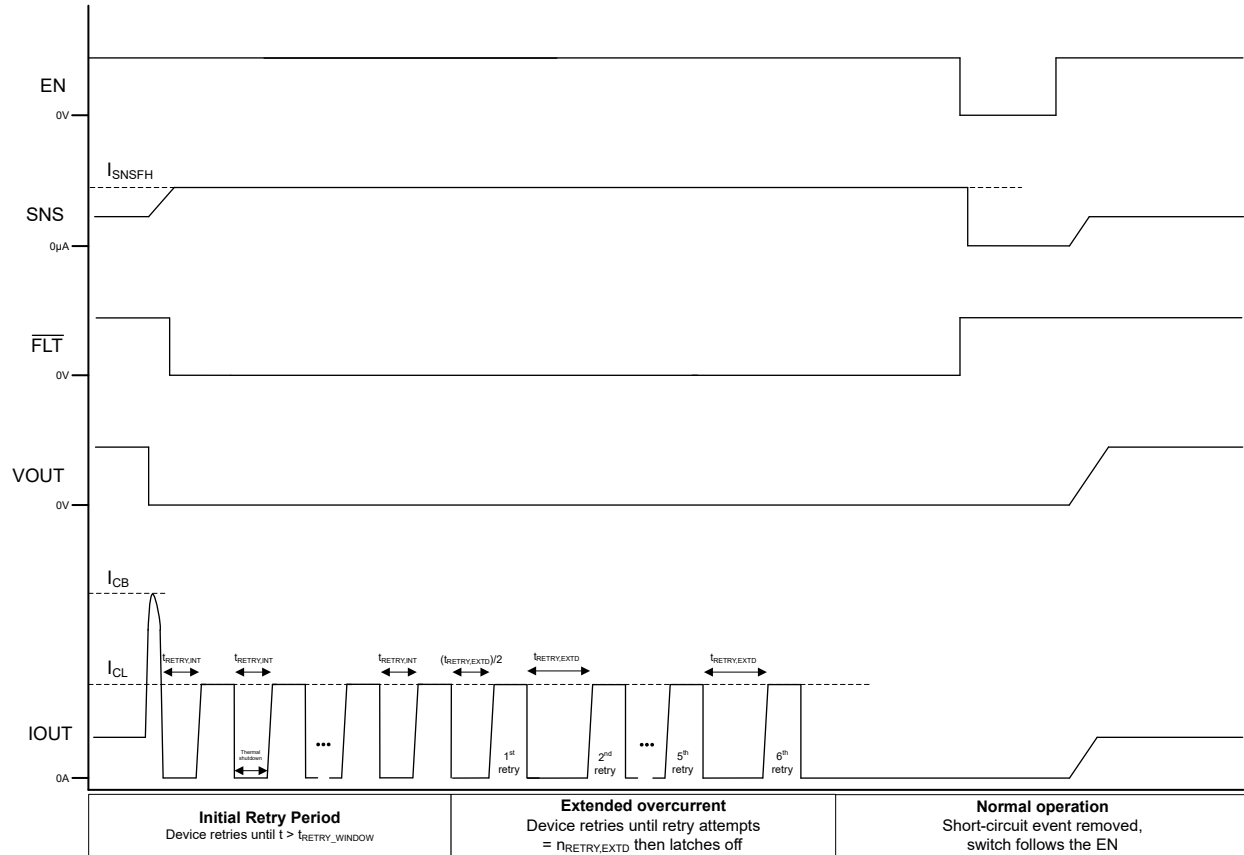


図 8-22. サーマルレギュレーションなしでのホット短絡後の再試行動作

電流制限故障が原因で、デバイスが有限の再試行サイクル フェーズの保護メカニズムに移行した場合、デバイスはサーマル シャットダウンに達するまで、最初の再試行ウィンドウの間、電流制限故障の状態に留まることがあります。サーマル シャットダウンがトリガされていない場合、拡張過電流ウィンドウでサーマル シャットダウンの再試行動作に直接移行します。

8.3.5 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ

誘導性負荷をオフに切り替えると、誘導性リアクタンスによって負の出力電圧を引き寄せる傾向があります。過度の負電圧があると、パワー FET が機能しなくなる可能性があります。パワー FET を保護するために、ドレインとソースの間に内部クランプ、すなわち $V_{DS(clamp)}$ を実装してください。

$$V_{DS(clamp)} = V_{VS} - V_{OUT} \quad (6)$$

消磁期間 (t_{decay}) 中、インダクタンス エネルギーを消費するためにパワー FET がオンになります。総エネルギーは、ハイ サイド スイッチで消費されます。総エネルギーには、電源のエネルギー ($E_{(VS)}$) と負荷のエネルギー ($E_{(LOAD)}$) が含まれます。抵抗がインダクタンスと直列になっている場合は、負荷エネルギーの一部が抵抗で消費されます。

$$E_{HSS} = E_{VS} + E_{load} = E_{VS} + E_L - E_R \quad (7)$$

誘導性負荷がオフになると、 $E_{(HSS)}$ によりデバイスに高い熱ストレスが加わります。消費電力の上限は、そのデバイスに固有の容量、周囲温度、および基板の消費電力条件によって異なります。

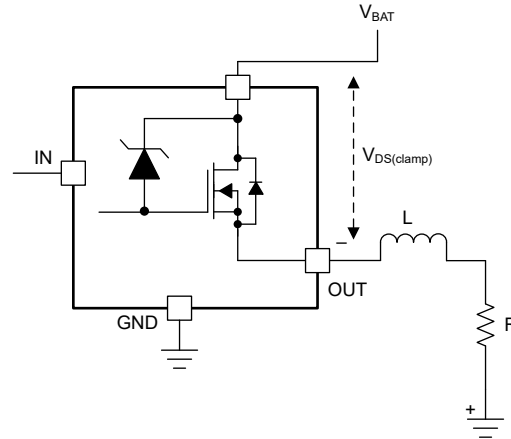


図 8-23. ドレイン-ソース間クランプ構造

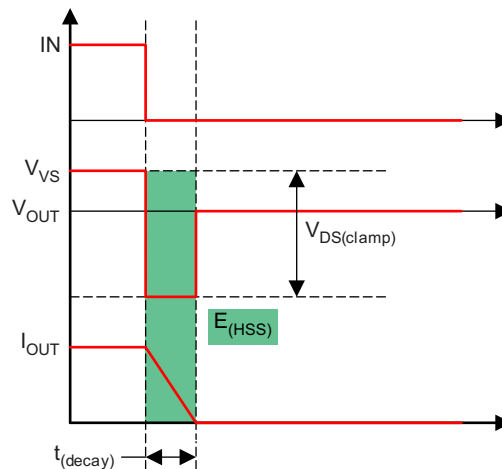


図 8-24. 誘導性負荷のスイッチングオフ図

ハイサイドスイッチの観点から、 E_{HSS} は、消磁時間中の積分値に等しくなります。

$$E_{HSS} = \int_0^{t_{decay}} V_{DS(clamp)} \times I_{OUT}(t) dt \quad (8)$$

$$t_{decay} = \frac{L}{R} \times \ln \left[\frac{R \times I_{OUT(max)} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|} \right] \quad (9)$$

$$E_{HSS} = L \times \frac{V_{VS} + |V_{OUT}|}{R^2} \times \left(R \times I_{OUT(max)} - |V_{OUT}| \times \ln \left[\frac{R \times I_{OUT(max)} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|} \right] \right) \quad (10)$$

R がほぼ 0 に等しいとき、 E_{HSD} は以下で求められます。

$$E_{HSS} = \frac{1}{2} \times L \times I_{OUT(max)}^2 \times \frac{V_{VS} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|} \quad (11)$$

PWM 制御の誘導性負荷の場合、デバイスが繰り返し発生するパワー ストレスを受けるのを防ぐため、下図に示す外付けのフリーホイール回路を追加することを推奨します。TVS は、高速減衰を実現するために使用されます。

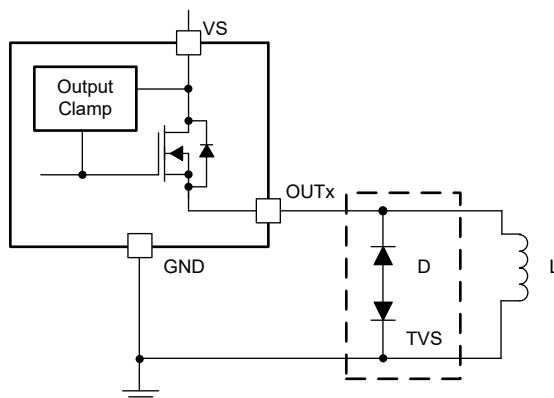


図 8-25. 外部回路による保護

下図は、5mH の誘導性負荷放電中に VDS クランプが動作している様子を示しています。

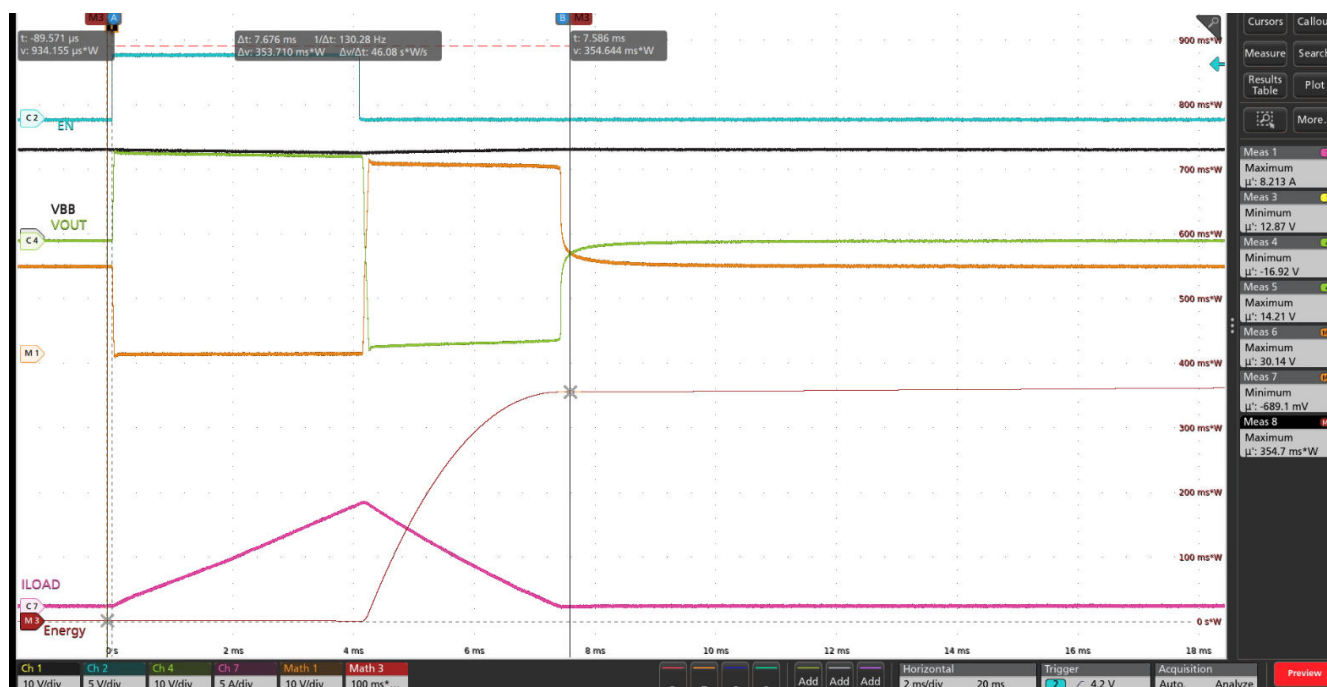


図 8-26. 5mH 誘導性負荷ドライブ (VBB = 13.5V、 T_{AMB} = 125°C)

以下のグラフは、誘導性負荷オフ時におけるデバイスの最大エネルギー消費能力を示しています。

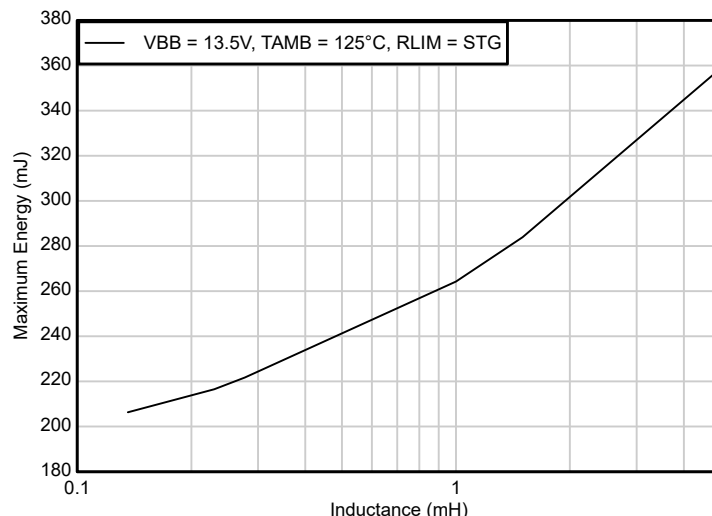


図 8-27. 誘導性スイッチオフ時の最大エネルギー吸収量とインダクタンスとの関係 (シングルパルス、VBB = 13.5V、T_{AMB} = 125°C)

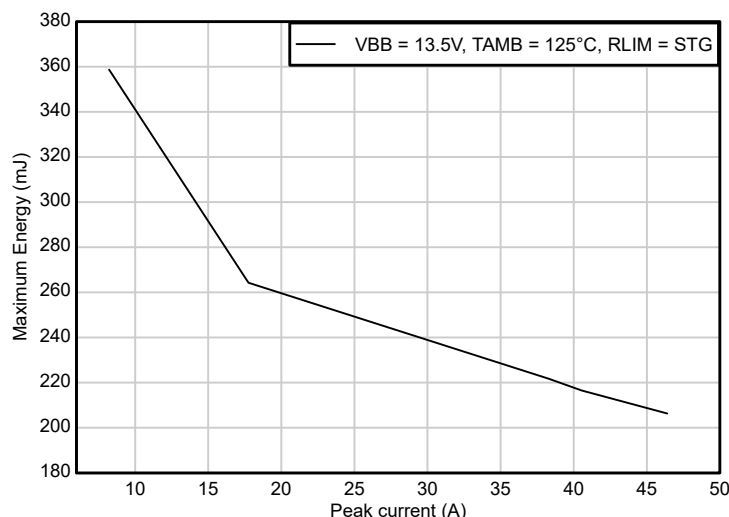


図 8-28. 誘導性スイッチオフ時の最大エネルギー吸収量とピーク電流との関係 (シングルパルス、VBB = 13.5V、T_{AMB} = 125°C)

8.3.6 スルー レート低速化オプション

TPS1HC03-Q1 は、車載シートヒータアプリケーション向けに、立ち上がりおよび立ち下りのスルーレートを低減したデバイス バージョン (D) を提供しています。この種のアプリケーションでは、PWM 電流の 10% ~ 90% の立ち上がり / 立ち下り時間を 80A/ms 以下に抑える必要があります。スルーレートを低減することで、車両の電気システムにおける電磁干渉の低減に寄与します。適切なスルー レート制御が行われない場合、シートヒータ アプリケーションにおける電流の高速スイッチングにより、システムで EMC 問題を引き起こす可能性があります。

8.3.7 容量性負荷の充電

TPS1HC03-Q1 は、高度な可変電流制限回路とサーマル レギュレーション機能を統合しており、大容量コンデンサの充電時に発生する突入電流を効果的に制御することで、システムの信頼性を大幅に向上させます。本デバイスは、スマート ハイ サイド スイッチをオフにすることで、電流制限フォルトおよび過電流フォルトに対する保護も提供します。保護機能がない場合、大容量コンデンサの充電では大きな突入電流が発生し、電源電圧の降下を引き起こす可能性があります。

かし、低サーマル レギュレーション型の電流制限デバイス オプションを使用することで、コンデンサ負荷を安全に充電することが可能になります。

8.3.7.1 突入電流制御のための可変電流制限

デバイスの可変電流制限機能により、容量性負荷の充電時に発生する突入電流を精密に制御できます。ILIM ピンに適切な外付け抵抗値を選択することで、設計者は以下を実現できます。

- 特定の容量性負荷要件に合わせて最大充電電流を調整します。
- 起動時の過大な電流引き込みから上流の電源を保護します。
- ピーク電流を制限することで、PCB 配線幅やコネクタサイズの要求を低減できます。
- 容量性負荷の充電時に電源レールの電圧降下を最小限に抑えることができます。
- システム全体で、より小型でコスト効率の高い部品の採用を可能にします。

以下の図は、同一条件下における 680 μ F 容量性負荷の充電動作を、デバイスをそれぞれ最大電流制限 (ILIM ピンをグランド (STG) に短絡) と最小電流制限 (ILIM ピンを開放) に設定した場合で比較しています。低い電流制限値により、容量性負荷を充電する際の突入電流が抑制され、サーマルシャットダウンを引き起こすことなくクリーンな起動を実現できます。



図 8-29. VBB = 13.5V、ILIM ピンをグランドに短絡し、周囲温度 125°C の条件で TPS1HC03-Q1 デバイスを用いた 680 μ F の容量性負荷充電

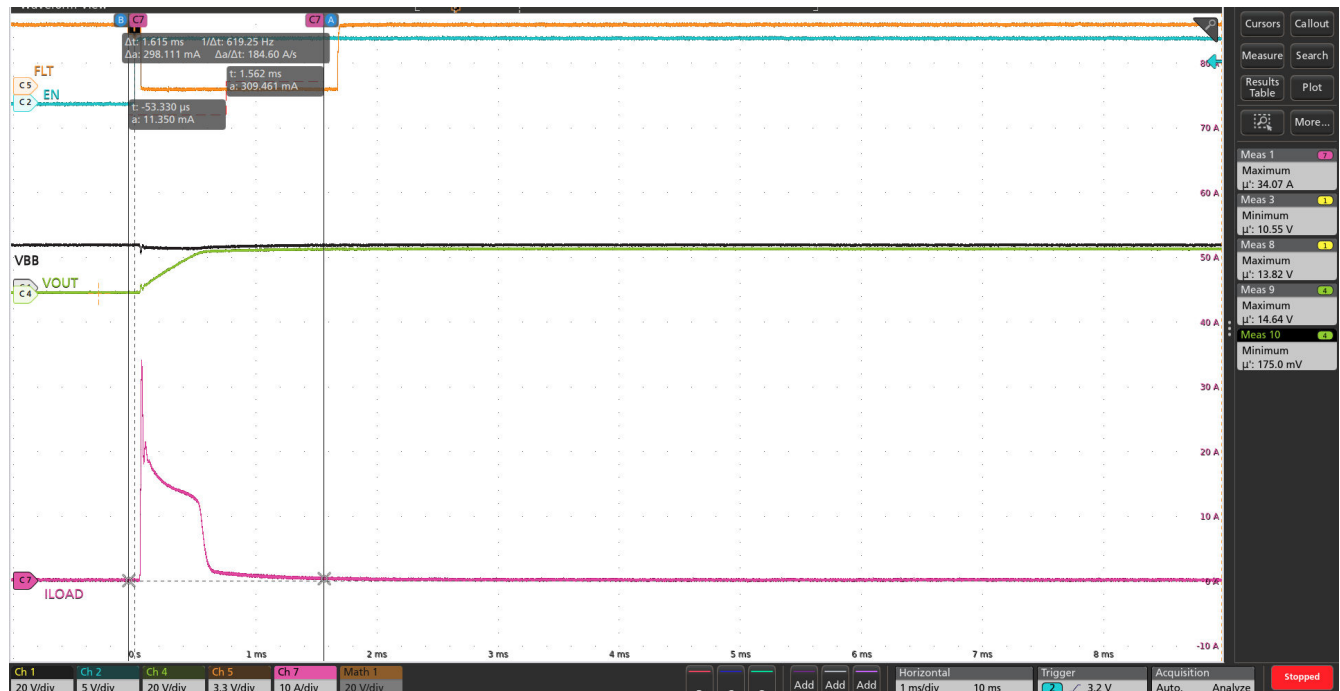


図 8-30. VBB = 13.5V、ILIM ピンをオープン、周囲温度 125°C の条件で TPS1HC03-Q1 デバイスを用いた 680uF の容量性負荷充電

8.3.7.2 容量性負荷に対するサーマルレギュレーション付き電流制限

ILIM ピンに外付け抵抗を接続して構成した場合、TPS1HC03-Q1 はサーマルレギュレーション付き電流制限を有効にします。サーマルレギュレーションは、パワー FET の温度 ($T_{J, FET}$) をコントローラ温度 ($T_{J, CONTROLLER}$) と比較しながら連続的に監視することで動作する負帰還機構によって実現されています。高電流イベント時に温度差が大きくなると、デバイスは安全動作を維持しつつ最大限の充電電流を確保するために、自動的に電流制限値を低減します。この機能は、容量性負荷の充電に対して以下の利点を提供します。

- **容量性負荷範囲の拡大:** サーマルレギュレーション付き電流制限により、図 8-31 に示すように、サーマルシャットダウンを引き起こすことなく安全に充電可能な容量性負荷の範囲が大幅に拡大します。温度条件に応じて電流を動的に調整することで、本デバイスは従来のハイサイドスイッチよりもはるかに大きな容量値を扱うことができます。
- **手動パルス動作の不要化:** 従来、電流制限にサーマルレギュレーション機能がない場合、大容量コンデンサを充電するためにスイッチを手動でオン・オフさせる方法が用いられることがありました。従来の手動パルス方式では、システムに大きなノイズや EMI の問題が発生していましたが、本方式ではそれらを排除できます。本デバイスのサーマルレギュレーション機能により、このような運用は不要になります。
- **サーマルランナウェイの防止:** サーマルレギュレーションは負帰還ループを形成し、コンデンサ充電時のシステム安定性を確保します。温度が上昇すると電流が自動的に低減されるため、従来型スイッチで見られるような制御不能な熱上昇を防ぐことができます。

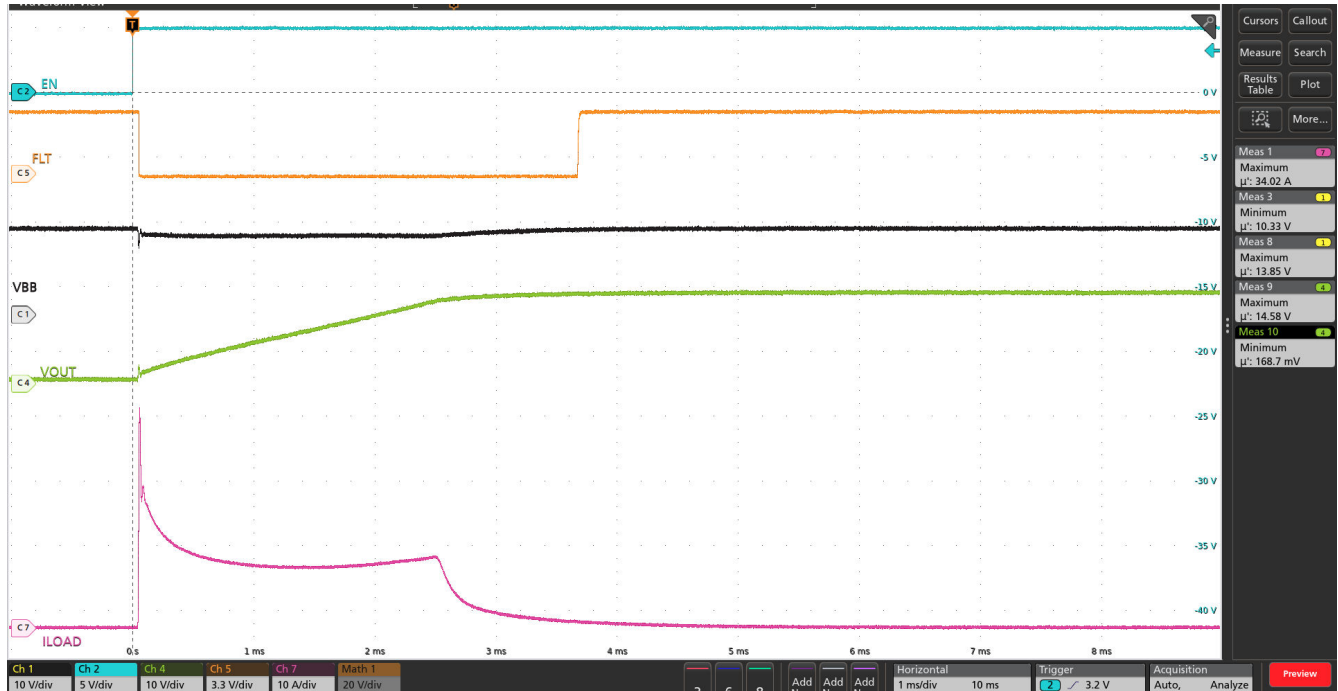


図 8-31. VBB = 13.5V、ILIM ピンをオープン、周囲温度 125°C の条件で TPS1HC03-Q1 デバイスを用いた 2.67mF の容量性負荷充電

8.3.7.3 容量性負荷における再試行サーマルシャットダウン動作

大容量の容量性負荷に対しては、デバイスがサーマルシャットダウンフォルトをトリガし、再試行サーマルシャットダウンフローに移行する場合があります。この場合、デバイスに実装された再試行保護メカニズム (セクション 8.3.4) により、複数の再試行サイクルを通じて負荷を確実にオンにすることが可能です。適切に容量が設定された多くの容量性負荷では、サーマルレギュレーションによりサーマルシャットダウン条件への到達が防止され、動作の中断を伴うことなく、スムーズな容量性充電が実現されます。複数のサーマル シャットダウン再試行サイクルにより、より高い値の容量性負荷を充電します。この動作は、容量性負荷に十分に高い負荷インピーダンスが並列接続されており、サーマル シャットダウン中にデバイスがオフとなってもコンデンサが大きく放電しないアプリケーションにおいては、許容可能です。図 8-29 に、ILIM からグラウンドへの短絡による電流制限設定に対して、複数のサーマル シャットダウン再試行サイクルでの 680μF 容量性負荷の充電を示します。

8.3.7.4 DC 負荷がコンデンサ充電能力に与える影響

同一チャネル上で容量性負荷と DC 負荷を併用するシステムを設計する場合、両者がもたらす複合的な熱的影響を考慮することが重要です。

- **サーマル バジレットの消費:** 容量性負荷と並列に接続された DC 負荷は、デバイスのサーマル バジレットの一部を消費します。DC 負荷による電力損失 (I^2R) は熱を発生させ、パワー FET の基準温度を上昇させます。
- **コンデンサ充電能力の低下:** FET と DC 負荷間の電力消費が発生すると、動作温度とサーマル シャットダウン スレッショルド間のマージンが減少します。その結果、サーマル シャットダウンを引き起こすことなく安全に充電できる最大コンデンサ容量が実質的に低下します。
- **加速されるサーマル シャットダウン:** DC 負荷電流とコンデンサ充電電流が同時に発生すると、その合算された発熱によりサーマル シャットダウンの発生が早まる可能性があります。これにより、コンデンサ充電中にデバイスが通常より早い段階で、かつ高い頻度で再試行メカニズムに入る可能性があります。
- **設計上の考慮事項:** 両方の負荷タイプで同時に対応することが必要な場合:
 - 電流制限を低減するため、より控えめな (高い) R_{LIM} 値を選択する
 - 熱放散を改善するため、十分な PCB 銅面積を確保する
 - 重要度の高いアプリケーションでは、DC 負荷と容量性負荷を個別チャネルで駆動することを検討する

誘導性負荷や容量性負荷の駆動に関する詳細については、TI の『[抵抗性、誘導性、容量性、および照明負荷の駆動方法](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

8.3.7.5 デバイス機能

VBB = 18V、 $T_A = 125^\circ\text{C}$ におけるデバイスファミリ全体の容量性負荷充電に関するデータを、下表に示します。TPS2HC08-Q1 および TPS2HC16-Q1 デバイスでは、単一チャネルのみが有効化されています。

表 8-3. デバイスファミリ全体における容量性負荷充電の結果

部品番号	ILIM	容量性負荷	充電時間 (標準値)	サーマルシャットダウンのトリガ
TPS2HC08-Q1	オープン	2mF	> 10ms	なし
	GND	1mF	<10ms	あり
TPS2HC16-Q1	オープン	47 μ F	<10ms	なし
	GND	220 μ F	<10ms	あり
TPS1HC08-Q1	オープン	470 μ F	<10ms	なし
	GND	1mF	<10ms	あり
TPS1HC04-Q1	オープン	680 μ F	<10ms	なし
	GND	470 μ F	<10ms	あり
TPS1HC03-Q1	オープン	680 μ F	<10ms	なし
	オープン	1mF	<10ms	あり

8.3.8 バルブ充電

図 8-32 は、起動時および定常動作時の特性を規定する、容量性要素と抵抗性要素を組み合わせたシンプルなバルブモデルを示しています。

- R_{inrush} : 起動時のピーク突入電流を制限する初期のコールド フィラメント抵抗。
- C_{inrush} : フィラメントが適切に発光するために十分な熱を生成するために必要なエネルギー蓄積を表す容量性要素。
- R_{dc} : 定常動作電流 ($V_{\text{battery}} / R_{\text{dc}}$) を決定するホット フィラメント抵抗。

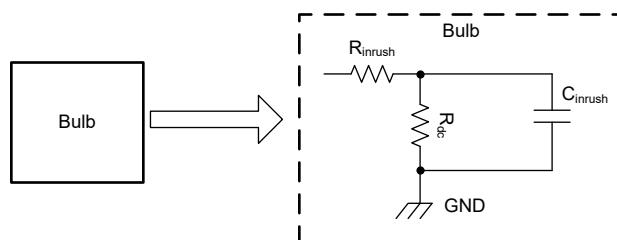


図 8-32. シンプルなバルブ モデル

コールド スタート時、フィラメント抵抗 (R_{inrush}) は定常状態の抵抗値 (R_{dc}) より 7～10 倍低くなるため、大きな突入電流が発生し、低 R_{ON} (オン抵抗) のスイッチが必要となります。

実際の環境では、バルブは車両に搭載されることで多くのインダクタンスや抵抗成分の影響を受けます。図 8-33 は、バルブのターンオン動作およびピーク電流に大きく影響する、以下のような複雑な電気ネットワークで構成される実環境の簡略化車両アーキテクチャ モデルを示しています。

- R_{vehicle} : バッテリからシャーシ グランドまでの経路におけるワイヤ ハーネスおよびコネクタの総抵抗は、 $R_{\text{ds,on switch}}$ (スイッチの R_{ON}) を除いて、量産車では一般的に 45m Ω ～ 130m Ω の範囲になります。短いケーブル ハーネスでは R_{vehicle} は約 50m Ω 、長いケーブル ハーネスでは約 100m Ω となります。
- L_{vehicle} : ワイヤ ハーネスのインダクタンスは、電流のスルー レートおよびターンオン タイミングに影響を与えます。

- **システム抵抗**: コネクタ接触抵抗およびグラウンド経路抵抗が、回路全体の動作に寄与します。

バルブ充電時のピーク突入電流を決定する主な 3 つの要素は以下のとおりです。

- **R_{vehicle}** : 車両側の抵抗が大きいほどピーク電流は低減されます。
- **$R_{\text{ds,on switch}}$** : スイッチのオン抵抗 (R_{ON}) は電流制限に寄与します。
- **R_{inrush}** : 特定バルブのコールド フィラメント抵抗。

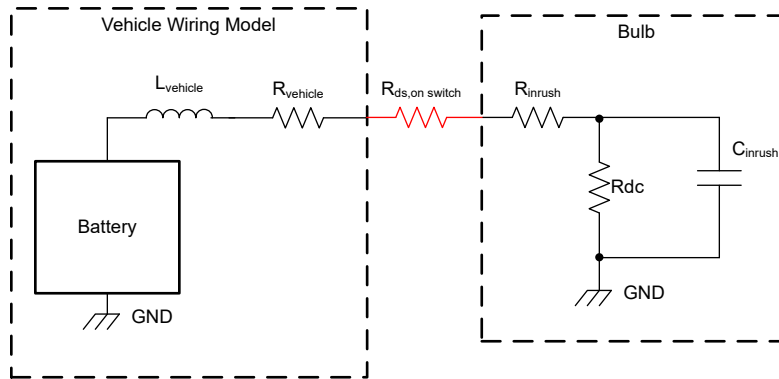


図 8-33. 簡略化した車両アーキテクチャ モデル

8.3.8.1 バルブ負荷向け非サーマルレギュレーションモード

高い突入電流を伴うバルブ負荷に対して、TPS1HC03-Q1 は ILIM ピンを GND に直接接続することで有効化できる、非サーマルレギュレーション型の電流制限モードを提供します。本モードは、以下のデバイス特性により、温度条件に依存しない一貫性のある予測可能な電流制限動作を実現します。

- 温度に関わらず、55A の固定電流制限値を維持します。
- デバイスが初期の大きな電流需要に対応できるようにします。

以下の図は、ILIM ピンをグラウンドに接続して設定したサーマルレギュレートされていない電流制限モードにおける、デバイスの 65W バルブ充電動作を示しています。サーマルレギュレートされていないモードでは、デバイスはバルブ負荷が要求する高い突入電流に対応でき、ターンオンします。

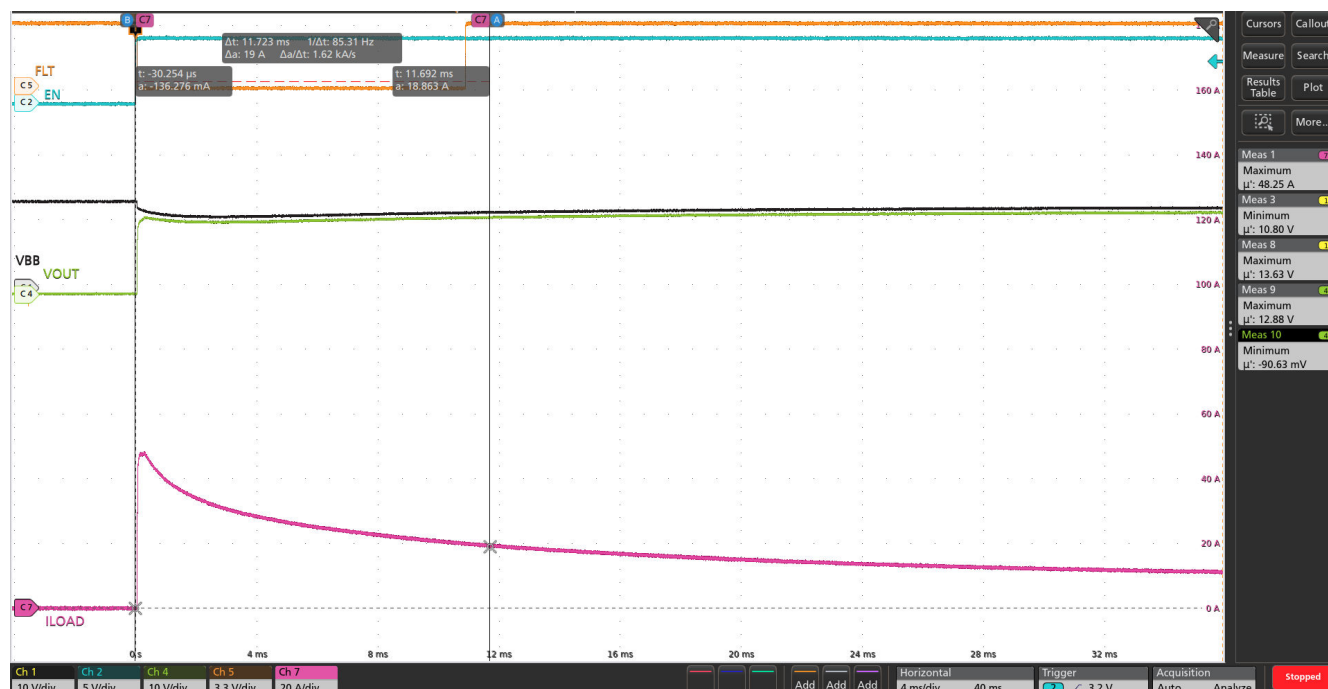


図 8-34. 13.5V VBB 条件下における TPS1HC03-Q1 シングルチャネル使用時の 65W バルブ充電特性、 T_A (device) = 25°C、 T_A (bulb) = -40°C、ILIM = GND

8.3.8.2 バルブ突入電流時の熱管理

高ワット数のバルブ負荷、低温起動時、または VBB 電圧が高く突入電流要求が大きい条件下では、本デバイスは高度な熱保護メカニズムを採用しています。

- 相対サーマル シャットダウン: 高突入電流イベント時には、FET が急速に発熱することにより、スイッチ出力のトルグル現象が観測されます。この状態が発生すると、デバイスは相対サーマル シャットダウン ($T_{J,FET} - T_{J,CONTROLLER} > T_{REL}$) 状態に移行し、 t_{RETRY_INT} 以内にこのイベントから自動的に復帰します。この迅速な復帰により、デバイスに過度な熱ストレスを与えることなく、バルブの充電を継続できます。
- 絶対サーマル シャットダウン: 相対的なサーマル保護が動作しているにもかかわらず接合部温度が上昇し続ける場合、FET 温度が T_{ABS} を超えた時点で絶対サーマル シャットダウン イベントが発生します。この場合、デバイス保護のためにスイッチがオフされ、温度が十分に低下すると t_{RETRY_EXT} 以内に自動的に復帰し、バルブの充電を再開します。

以下の図は、ILIM ピンをグランドに接続して設定したサーマル レギュレートされていない電流制限モードにおける、デバイスの 140W バルブ充電動作を示しています。デバイスは再試行保護メカニズムを動作させ、数回の試行サイクル後にバルブをオンにします。

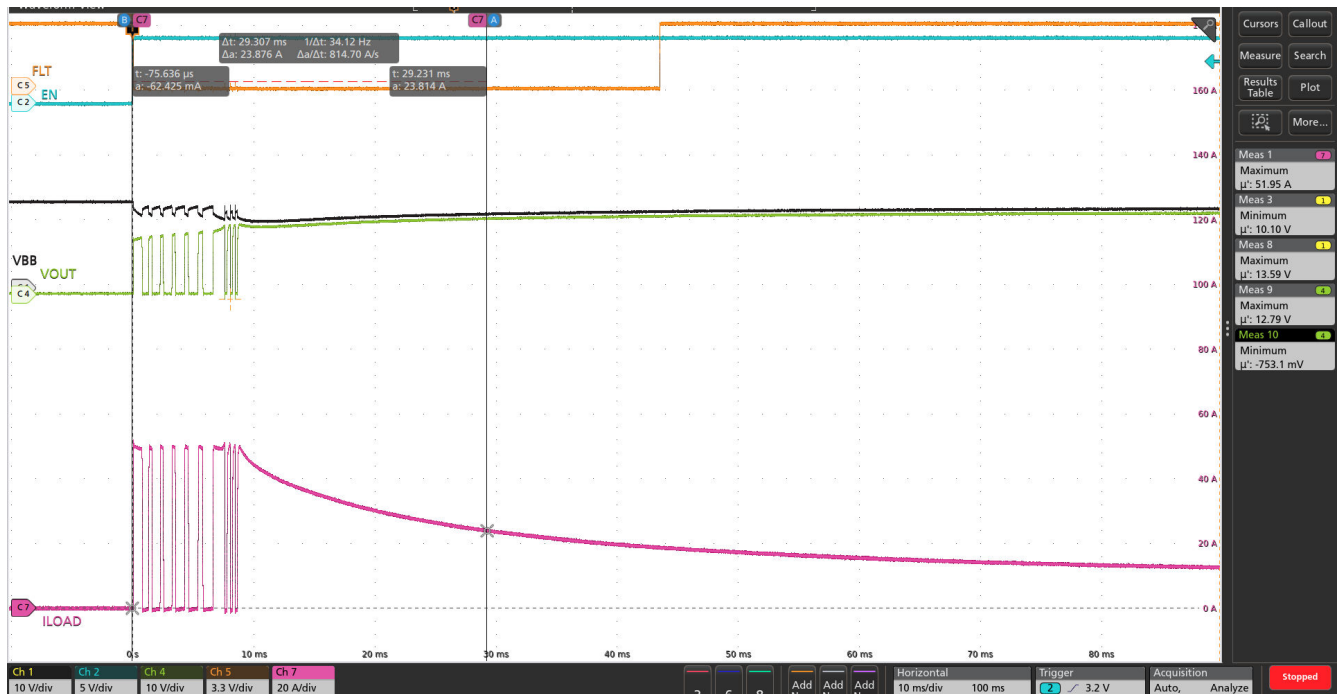


図 8-35. TPS1HC03-Q1 使用時の 140W パルブ充電特性、13.5V VBB、 T_A (device) = 25°C、 T_A (bulb) = 25°C、ILIM = GND にて

8.3.8.3 デバイス機能

VBB = 13.5V、 T_A = -40°C におけるデバイスファミリ全体のバルブ負荷充電に関するデータを、下表に示します。TPS2HC08-Q1 および TPS2HC16-Q1 デバイスでは、単一チャネルのみが有効化されています。

表 8-4. デバイス ファミリ全体におけるバルブ負荷充電の結果 (短いケーブル長、 $R_{\text{vehicle}} = 50\text{m}\Omega$ にて)

部品番号	ILIM	バルブ負荷	充電時間 (標準値)	サーマルシャットダウンのトリガ
TPS1HC08-Q1	GND	20W	<10ms	あり
TPS2HC08-Q1	GND	35W	<10ms	あり
TPS2HC16-Q1	GND	15W	<10ms	あり
		27W	> 10ms	あり
TPS1HC04-Q1	GND	35W	<10ms	なし
	GND	60W	<10ms	あり
	GND	100W	> 10ms	あり
TPS1HC03-Q1	GND	4 x 27W (長いケーブルハーネス付き)	> 10ms	あり
	GND	2 x 27W	<10ms	あり
	GND	35W	<10ms	なし

8.3.9 フォルト検出および通知

8.3.9.1 診断イネーブル機能

DIAG_EN ピンは診断機能をイネーブルまたはディスエーブルします。複数のデバイスを使用しても、マイコン内の ADC リソースが制限されている場合、マイコンは GPIO を使用して DIAG_EN を High に設定して一方のデバイスの診断をイネーブルにし、DIAG_EN を Low に設定することで他のデバイスの診断をディスエーブルにできます。また、DIAG_EN と EN を Low に設定することで、デバイスは消費電力を最小限に抑えることができます。

表 8-5. 診断設定表

DIAG_EN	EN	SNS	FLT	保護および診断
L	H	高インピーダンス	表 8-7 を参照	SNS 無効、FLT 通知、完全保護
	L		高インピーダンス	診断無効、保護なし
H	-	表 8-7 を参照	表 8-7 を参照	表 8-7 を参照

8.3.9.2 FLT 通知

EN が High のアクティブ状態では、DIAG_EN の状態に関係なく、FLT ピンはデバイスのフォルト状態を監視するために使用されます。EN が "Low" の時のオフ状態診断では、DIAG_EN が "High" のとき、FLT ピンは開放負荷とバッテリーへの短絡故障を監視します。デバイスで故障状態が発生した場合、FLT ピンは GND にプルダウンされます。マイコンの電源レベルに合わせて、3.3V または 5V 外部プルアップが必要です。SNS ピンも、DIAG_EN が High の場合に I_{SNSFH} 電流を出力することでフォルト報告として機能します。

8.3.9.3 FLT タイミング

表 8-6 に、FLT ピンのタイミングを示します。

表 8-6. FLT タイミング

条件	TIMING
DIAGNOSTIC 状態における開放負荷または STB フォルト発生から FLT アサートまでの時間。	セクション 8.3.10.1.2(t_{OL} 、 t_{OL1} 、 t_{OL2}) を参照
その他の故障発生から FLT アサートまで	t_{FAULT_FLT} を参照
故障解消から FLT リセットまで (電流制限故障用)	デバイスが他の故障状態なく電流制限故障になった場合、FLT 信号は、デバイスが電流制限故障から回復してから 2ms 以内にリセットされると期待されます。容量性負荷およびバルブ負荷では、Vout が VBB まで充電されたときに、電流制限故障から復帰するデバイスを表示することができます。

8.3.9.4 フォルト表

以下の表は、さまざまな条件下における FLT ピン (DIAG_EN が High かどうかに関係なく) と SNS ピン (DIAG_EN が High の場合) の応答を示しています。

表 8-7. フォルト表

条件	EN	OUT	条件	SNS (DIAG_EN High 時)	FLT (外部プルアップ使用時)	動作	FAULT 回復
通常	L	L	—	高インピーダンス	H	通常	—
	H	$V_{BB} - I_{LOAD} \times R_{ON}$	—	I_{LOAD}/K_{SNS}	H	通常	—
過電流	H	$V_{BB} - I_{LIM} \times R_{ON}$	電流制限がトリガされました	I_{SNSFH}	L	サーマル シャットダウンまで、または過電流イベントが解消したとき、電流制限の電流を保持	自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4 を参照してください
ホットショート	H	L	出力はグラウンドへ短絡	I_{SNSFH}	L	デバイスは直ちにシャットダウンし、電流制限が再度有効になります。	自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4 を参照してください
永久短絡の有効化	L ~ H	L	出力はグラウンドへ短絡	I_{SNSFH}	L	サーマルシャットダウンになるまで、デバイスは電流制限を有効化しています。	自動リトライまたはラッチ、セクション 8.3.4 を参照してください

表 8-7. フォルト表 (続き)

条件	EN	OUT	条件	SNS (DIAG_EN High 時)	FLT (外部プルアップ使用時)	動作	FAULT 回復
開放負荷、バッテリーへの短絡 (STB)	L	H	$V_{BB} - V_{OUT} < V_{OL}$	I_{SNSFH}	L (DIAG_EN が High の場合)	開放負荷のフォルトを検出するため、内部プルアップ抵抗が有効になります。	車載
	H	H		I_{LOAD}/K_{SNS}	H	通常の動作。ユーザーは、SNS ピン出力に基づいて判定できます。	—
絶対サーマル・シャットダウン	H	—	T_{ABS} がトリガされました	I_{SNSFH}	L	デバイスが絶対的なサーマルシャットダウンに達するとシャットダウンします。	自動リトライまたはラッチ、 セクション 8.3.4 を参照してください
相対サーマル・シャットダウン	H	—	T_{REL} がトリガされました	I_{SNSFH}	L	デバイスが相対的なサーマルシャットダウンに達するとシャットダウンします。	自動リトライまたはラッチ、 セクション 8.3.4 を参照してください

8.3.10 全診断機能

8.3.10.1 オープン負荷の検出

8.3.10.1.1 チャンネル オン

チャンネルがオンで、DIAG_EN = Logic High の場合、デバイスの高精度電流センスを使用することで、外部 ADC によりオン状態の開放負荷を検出できます。FLT ピンでは検出が報告されていないことに注意してください。チャンネルがオンのときの開放負荷を決定するには、ユーザーまたはシステムが行う必要があります。

8.3.10.1.2 チャンネル オフ

DIAG_EN = Logic High の場合、OFF 状態で開放負荷検出が利用可能です。開放負荷の場合、出力電圧は電源電圧に近く、 $V_{BB} - V_{OUT} < V_{OL}$ となります。FLT ピンは Low になって MCU にフォルトを通知し、SNS ピンは I_{SNSFH} フォルト電流を出力します。出力には常に漏れ電流 $I_{OL,OFF}$ が流れています。これは、内部のロジック制御経路や外部の湿気や腐食などが原因で発生します。そのため、デバイスにはリーク電流をオフセットするための内部プルアップ抵抗 (R_{PU}) が実装されています。通常動作モードでの誤検出を避けるため、このプルアップ電流は出力負荷電流よりも小さくする必要があります。DIAG_EN が "High" の状態で、チャンネルがオフで、負荷が出力に接続されている場合、内部の R_{PU} 抵抗と出力負荷抵抗で抵抗デバイダが形成され、 V_{OUT} がプルアップされます。スリープ電流 (I_{SLEEP}) を低減するために、デバイスはスイッチおよびプルアップ抵抗を実装しており、それらは DIAG_EN および EN ピンで制御されます。

デバイスのすべてのバージョンについて、DIAG_EN および EN 信号は以下の表に従って R_{PU} 抵抗の接続を制御します。 $V_{BB} \geq V_{DET1}$ 立ち上がりスレッショルドで EN が "Low" の場合、DIAG_EN 信号の状態に関係なく、 R_{PU} 抵抗は V_{BB} と V_{OUT} の間に接続されたままになります。EN が "High" の場合、 R_{PU} 抵抗は他の信号に関係なく、 V_{BB} と V_{OUT} の間に接続されたままになります。

表 8-8. 制御信号に基づく R_{PU} 抵抗接続

VBB	EN	DIAG_EN	OUT と VBB 間の R_{PU} 抵抗接続
$V_{BB} < V_{DET1}$ 立ち下がりスレッショルド	L	L ~ H	t_{OL2} 遅延で接続
		H ~ L	即時に切断
$V_{BB} \geq V_{DET1}$ 立ち下がりスレッショルド	H	-	R_{PU} 抵抗は、VBB と VOUT 間に接続されたまま
-		-	R_{PU} 抵抗は、VBB と VOUT 間に接続されたまま

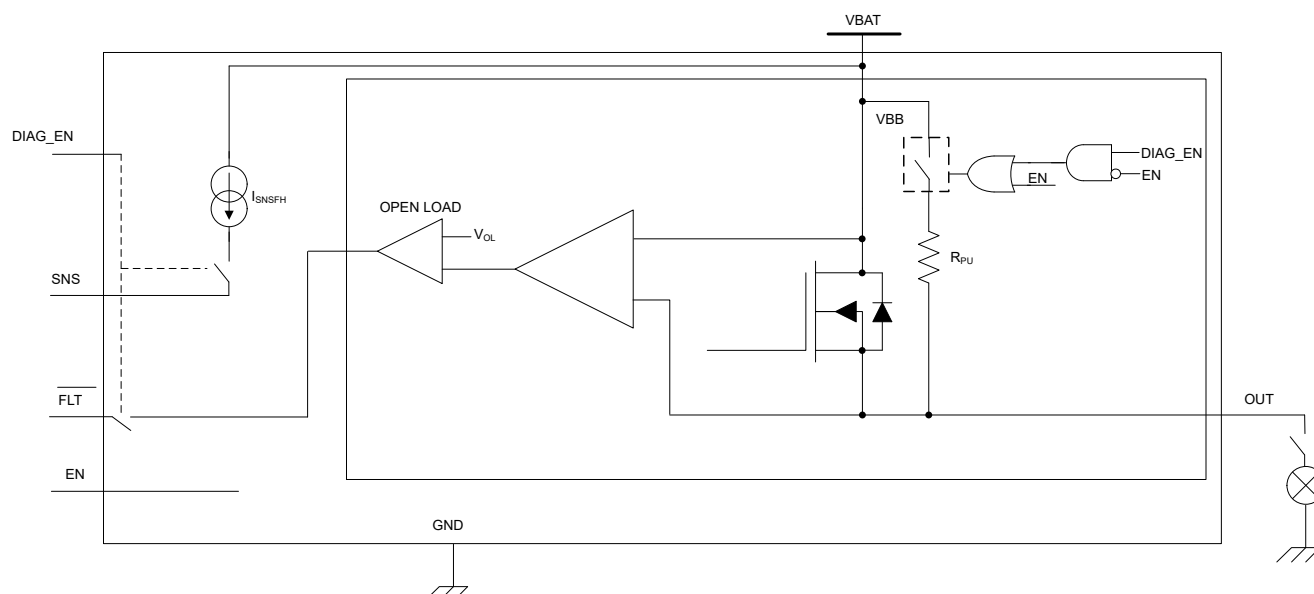
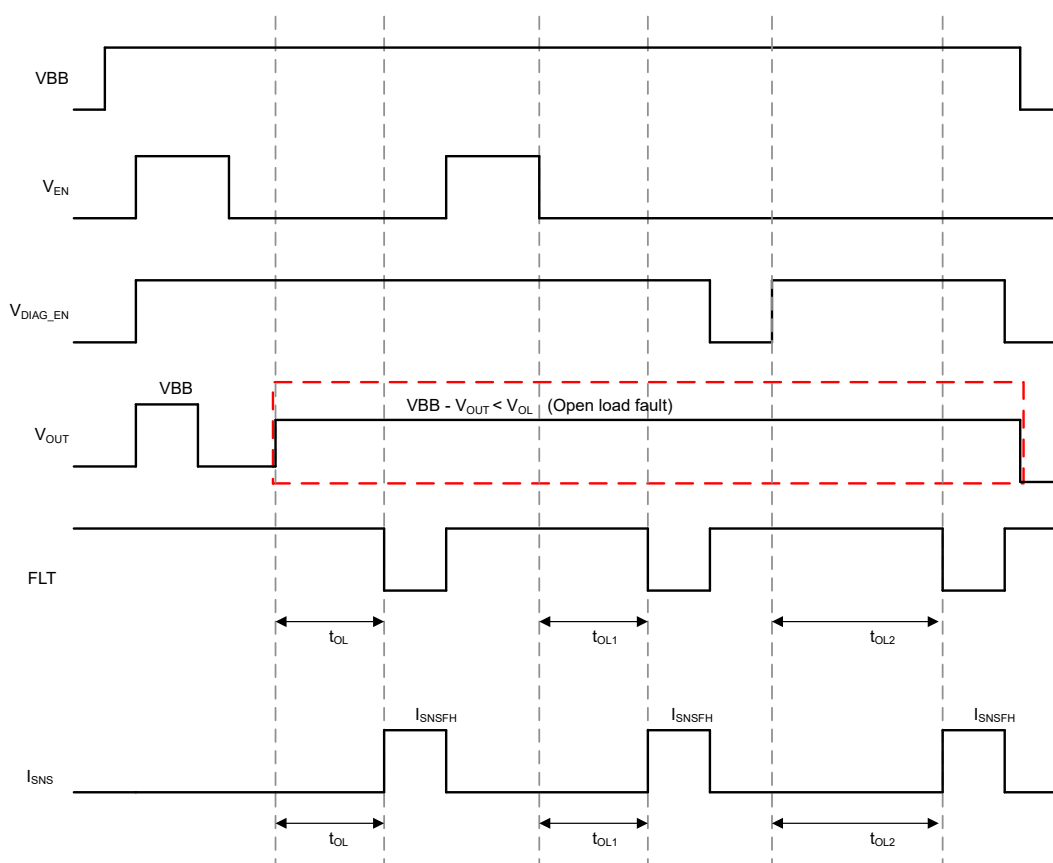


図 8-36. オフ状態での開放負荷検出 ($V_{BB} < V_{DET1}$ 立ち下がりスレッシュホールド)



注

制御信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間は 100ns です。制御信号には以下が含まれます。EN、DIAG_EN。

図 8-37. 開放負荷の検出タイミングの特性

8.3.10.2 バッテリへの短絡の検出

バッテリーへの短絡に対する検出メカニズムおよび動作は、オン状態とオフ状態の両方で、開放負荷検出と同じです。詳細については、表 8-7 を参照してください。

8.3.10.3 逆極性およびバッテリー保護

逆極性 (一般に逆バッテリーと呼ばれます) は、デバイスのグランドがバッテリー電位になる $V_{GND} = V_{BAT}$ で、電源ピンがグランドに接続される $V_{BB} = 0V$ のときに発生します。この場合、EN ピンにグランドプレーンへのパスがあれば、FET はオンになり、メイン チャネルを通じて消費電力を低減させ、ボディダイオードを通じて流れる電流を防ぎます。逆バッテリーイベントが発生したとき、デバイスを保護するために、抵抗 / ダイオードのグランドネットワークを設ける必要があることに注意してください (電源に集中型のブロッキング ダイオードが存在しない場合)。グランド保護ネットワークにより、デバイスのグランドはモジュールのグランド (およびマイコンのグランド) より電位が高くなります。このオフセットは、デバイスとマイクロ コントローラ間のロジック ピン インターフェイスにおいて考慮する必要があります。

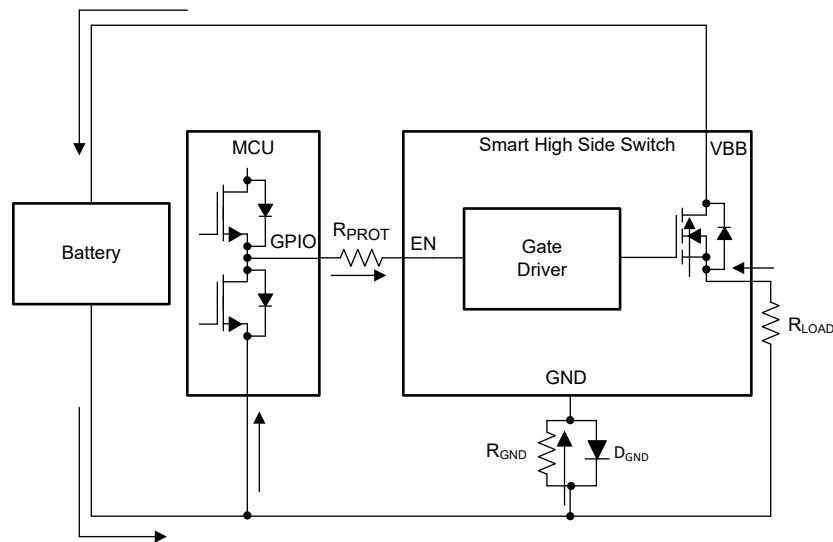


図 8-38. 逆バッテリー回路

外部保護回路の詳細については、[逆電流保護](#) を参照してください。

8.3.11 全保護機能

8.3.11.1 UVLO 保護

デバイスは電源電圧 V_{BB} を監視することで、 V_{BB} が低すぎるときに予期しない動作が発生することを防ぎます。 V_{BB} が V_{UVLOF} を下回ると、デバイスはシャットダウンします。 V_{BB} が V_{UVLOR} まで上昇すると、デバイスはオンになります。

8.3.11.2 GND 喪失保護

GND 喪失が発生すると、イネーブル信号が High か Low かどうかに関わらず、出力はオフになります。

ケース 1 (デバイス GND 喪失): 図 8-39 に示されるように、サーマル パッド (タブ)、IC_GND、電流制限グランドが 1 つのパターンで、システム グランドに接続されているとき、GND 喪失保護がアクティブになります。

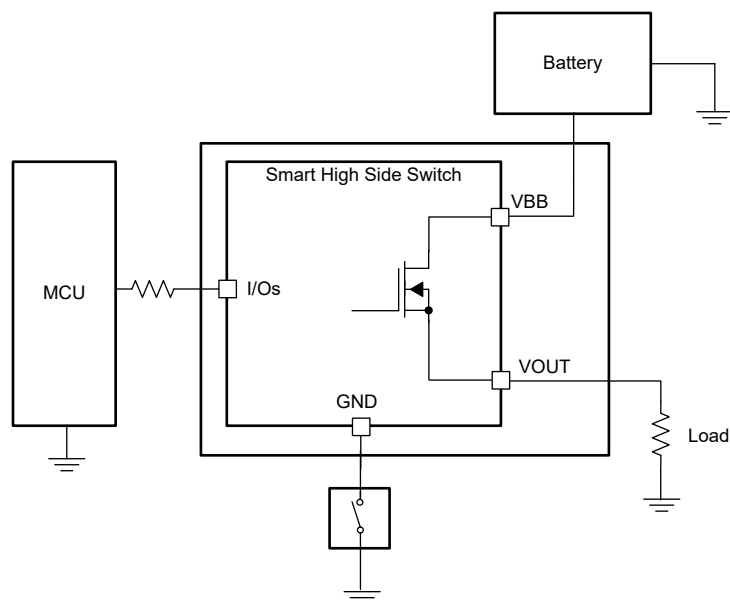


図 8-39. デバイスの GND 喪失

ケース 2 (モジュール GND 喪失): ECU モジュール全体の GND が失われた場合も、保護機能がアクティブになります。この状態では、負荷の GND は引き続き接続されています。

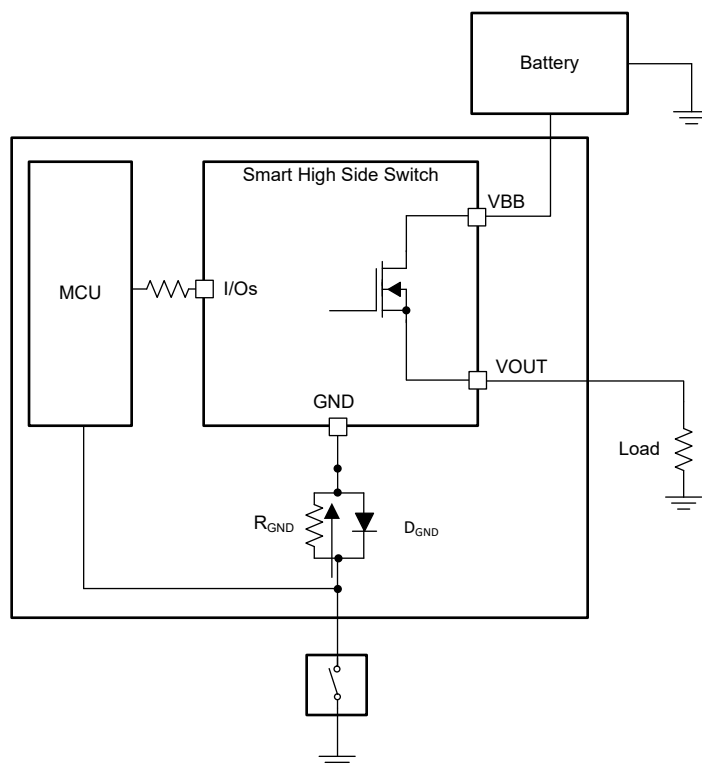


図 8-40. モジュールの GND 喪失

8.3.11.3 電源喪失保護

電源喪失が発生すると、入力が High か Low かどうかに関わらず、出力はオフになります。抵抗性または容量性負荷の場合は、それ以上電力を必要としないため、電源喪失保護は簡単に実現できます。ワースト ケースは、充電された誘導

性負荷の場合です。この場合は、インダクタンス出力ループを維持するために、すべての IO から駆動電流が流れます。TI では、マイコンの直列抵抗プラス GND ネットワーク(ダイオードと抵抗を並列に接続)、または外部のフリーホイール回路を推奨します。

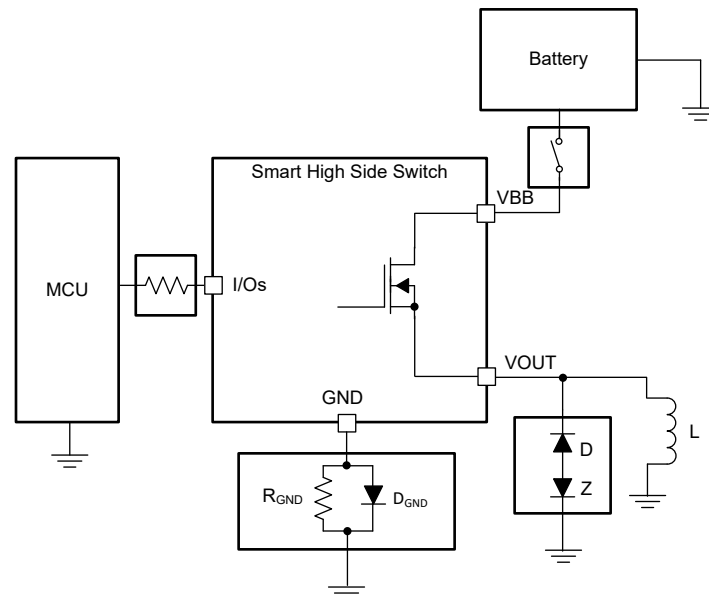


図 8-41. バッテリの損失

8.3.11.4 逆電流保護

方法 1: ブロック ダイオードを VBB に接続。逆極性時にデバイスと負荷の両方が保護されます。ブロッキングダイオードは、バッテリーの逆接続条件では電流を流しません。

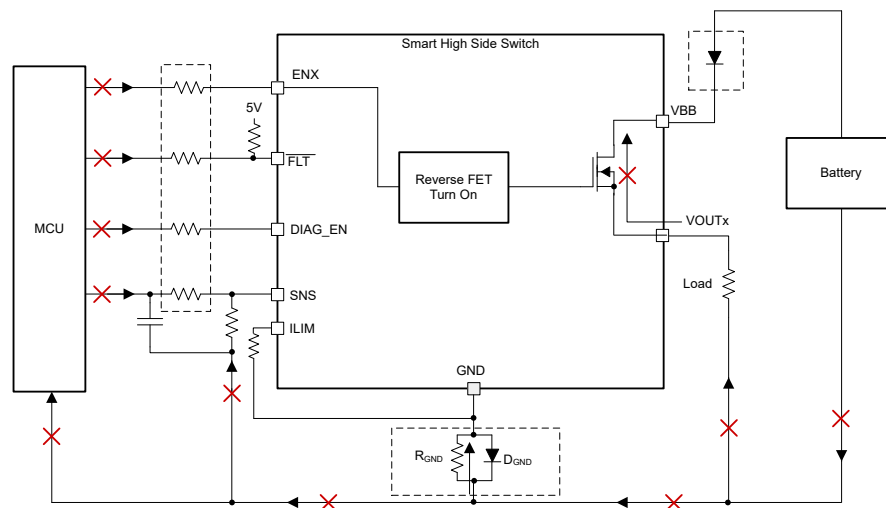


図 8-42. ブロックダイオードによる逆電流保護

方法 2 (GND ネットワーク保護): この接続では、ハイサイドのデバイスだけを保護します。負荷のインピーダンスにより、負荷の逆電流が制限されます。逆極性が生じた場合、パワー FET を流れる連続逆電流による熱が絶対最大接合部温度を超えないようにしてください。R_{ON(REV)} 値と R_{θJA} 仕様を用いてデバイスの温度を計算します。バッテリーの逆接続条件では、電力損失を抑えるために FET をオンにしてください。この動作は、正電圧が印加されている EN からシステム グランドまでのパスを通じて実現されます。デバイスの GND と基板の GND との間に使用する接続の種類に関わらず、GND 電圧のシフトが発生する場合は、通常動作を確保するために以下のような適切な接続であることを確認してください。

- デバイスの GND に電流制限プログラマブル抵抗を接続します。

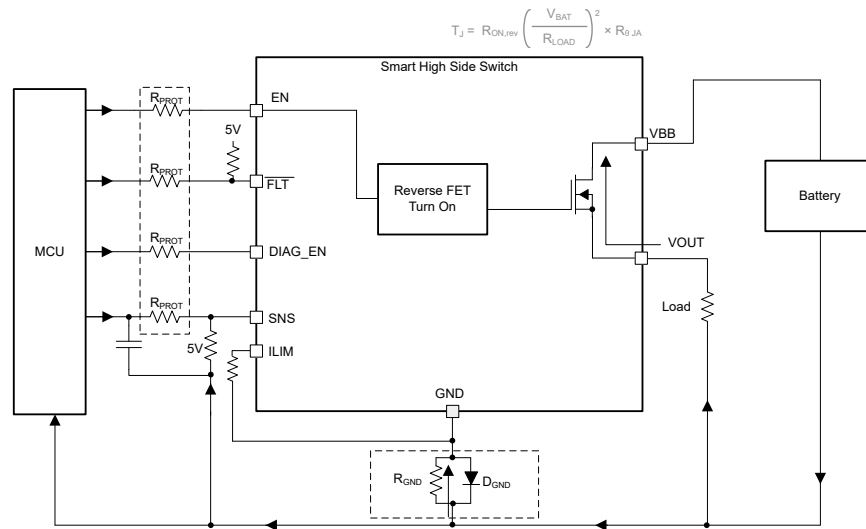


図 8-43. GND ネットワークによる逆電流保護

- 推奨事項 — 抵抗とダイオードの並列接続: 誘導性負荷がオフに切り換わると、負のピーク スパイクが発生する場合があります、HSS またはダイオードの破損につながる恐れがあります。そのため、TI では、誘導性負荷の駆動時には抵抗とダイオードを並列に使用することを推奨しています。4.7kΩ 抵抗と $I_F > 100\text{mA}$ のダイオードを選んで並列に使用することを推奨します。複数のハイサイド スイッチを使用する場合は、デバイス間で抵抗とダイオードを共有できます。この場合、グラウンド抵抗とグラウンド ダイオードを決定する際に、複数のハイサイド スイッチの I_{GND} を合算することを考慮してください。
- グラウンド抵抗: バッテリの逆接続または負の ISO パルスに対しては、抵抗値が大きいほど、電流制限効果が上がります。

$$R_{GND} \geq \frac{-V_{CC}}{-I_{GND}} \quad (12)$$

ここで、

- $-V_{CC}$ は最大逆バッテリー電圧です (ISO 7637 パルス 1 のような負のサージ電圧にさらされる可能性があります)。
- $-I_{GND}$ は、グラウンド ピンが耐えることのできる最大逆電流であり、絶対最大定格で参照可能です。
- グラウンド・ダイオード: 逆電圧をブロックするためにダイオードが必要ですが、これはグラウンド シフト ($\approx 600\text{mV}$) にもつながります。なお、ISO 7637 pulse 1 テストでは、ダイオードがバイアスされないように、ダイオードを約 300V の逆電圧にする必要があります。

8.3.11.5 MCU I/O の保護

負の ISO パルスや、誘導性負荷によるバッテリー損失など、多くの条件では、デバイスの GND ピンに負の電位が生じて、マイコンの I/O ピン (一般的に、ピンに接続された内部回路) が損傷する可能性があります。そのため、マイコンと HSS の間に直列抵抗が必要です。

また、GND の損失に対する適切な保護のため、TI は R_{PROT} 抵抗に 10kΩ 抵抗を推奨しています。

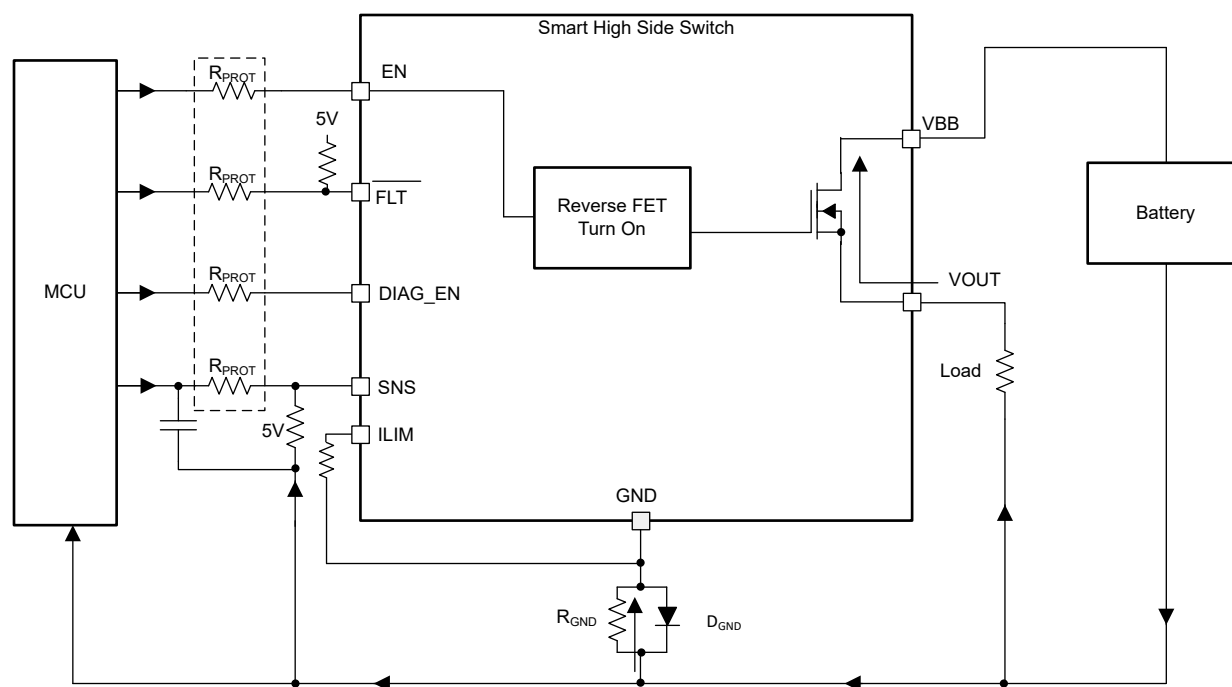


図 8-44. マイコン I/O 保護

8.4 デバイスの機能モード

デバイスには、EN ピン、DIAG_EN ピン、および VBB 電圧に基づいて遷移する複数の状態があります。さまざまな状態はデータシートを通じて参照されます。

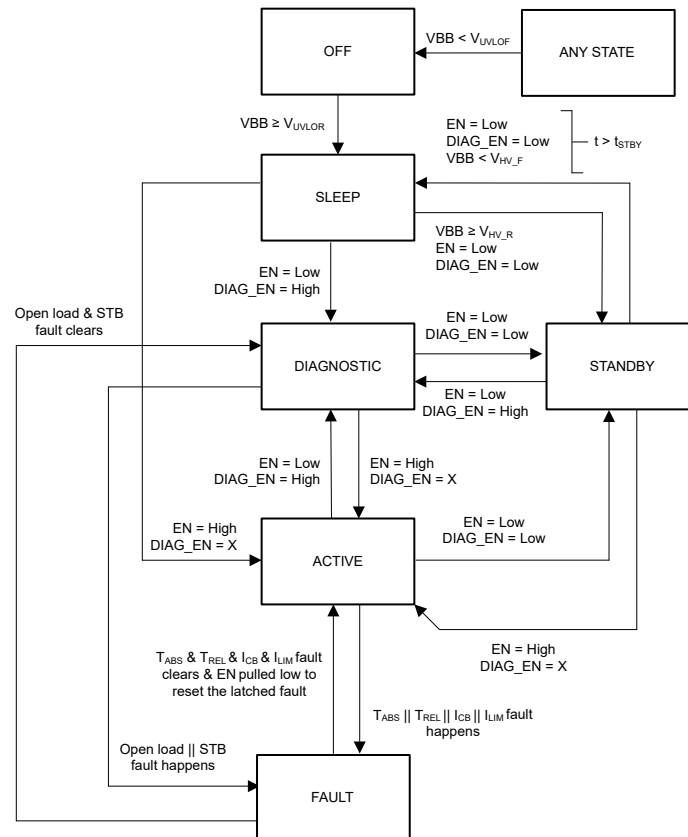


図 8-45. 状態遷移図

8.4.1 OFF

デバイスがオフの状態は、デバイスの VBB 電圧が V_{UVLOF} を下回ったときに発生します。

8.4.2 SLEEP

このデバイス状態は、EN ピンが t_{STBY} を超える時間 Low に保持され、かつ VBB が V_{HV_F} 未満の場合に STANDBY 状態から遷移して入ります。出力はオフになります。SLEEP 状態では、デバイス内のすべてのブロックがオフになり、VBB への電流は I_{SLEEP} となります。SLEEP 状態からは、EN ピンが High になれば ACTIVE 状態へ、EN ピンを介さず DIAG_EN ピンが High になれば DIAGNOSTIC 状態へ、VBB が V_{HV_R} を上回れば STANDBY 状態へ遷移できます。

8.4.3 STANDBY

EN ピンが Low のとき、デバイスは STANDBY 状態に入ります。出力はオフになり、DIAG_EN ピンも Low になりますが、 t_{STBY} 時間はまだ経過していません。この状態では、すべての内部レールが遮断されて SLEEP モードになることなく、デバイス出力を PWM を使用して変調できます。デバイスが t_{STBY} を待機し、VBB が V_{HV_F} を下回ると、デバイスは完全にシャットダウンし、SLEEP 状態に移行します。ただし、その時間が t_{STBY} 未満で EN ピンが High に戻った場合、デバイスは ACTIVE 状態へ遷移します。同様に、DIAG_EN が High になると、デバイスは DIAGNOSTIC 状態に遷移します。

8.4.4 診断

EN が Low で DIAG_EN ピンが High のとき、デバイスは診断状態に入ります。この状態では、開放負荷またはバッテリーへの短絡を診断できます。開放負荷またはバッテリー短絡フォルトのいずれかのフォルト条件が発生すると、デバイスは $\overline{FLT}$ をアサートし、SNS ピンは I_{SNSFH} 電流を出力します。

8.4.5 アクティブ

EN ピンを High にして出力をオンにすると、デバイスは **ACTIVE** 状態に入ります。**ACTIVE** 状態では、電流制限値が ILIM ピンの外部抵抗によって設定されます。**ACTIVE** 状態で DIAG_EN ピンが High にされると、SNS ピンは負荷電流に比例した電流を出力します。また、いずれかのチャンネルでフォルトが発生したかどうかは、 $\overline{\text{FLT}}$ ピンが通知します。DIAG_EN が High または Low のときにすべてのチャンネルをオフにした場合、デバイスは **ACTIVE** 状態から遷移できます。デバイスがオフで DIAG_EN が High の場合、デバイスは診断状態に遷移します。デバイスがオフで DIAG_EN ピンが Low の場合、デバイスは診断状態に遷移します。

8.4.6 フォルト

EN ピンが High の状態で、何らかの事象によりデバイスが通常動作と異なる挙動を示した場合、デバイスは故障状態に入ります。これらの故障事象には、絶対的なサーマルシャットダウン、相対的なサーマルシャットダウン、電流制限、開放負荷、バッテリー短絡故障が含まれます。これらの直接的または結果的な各故障イベントにより、FET はシャットオフされ、デバイスとシステムを保護します。

8.4.7 低電力モード

低電力モード状態は、アクティブになるチャンネルが $I_{\text{LPM, entry}}$ レベルを t_{STBY} よりも長い間下回ること、DIAG_EN が low になる場合です。このデバイスは不要な内部ブロックをすべてオフにし、 I_{Q} から $I_{\text{Q, LPM}}$ への静止電流を低減します。デバイスは保護状態を維持しますが、デバイスがこのモードから復帰するまで、診断または異常検出出力は行われません。

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

TPS1HC03-Q1 デバイスは、電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーター、サブモジュールなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷を駆動できます。包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。電流制限を外部で調整可能なため、突入電流や過負荷電流をクランプすることで、システム全体の信頼性を向上させます。

9.2 代表的なアプリケーション

次の図に、TPS1HC03-Q1 に対する外部回路の接続例を示します。

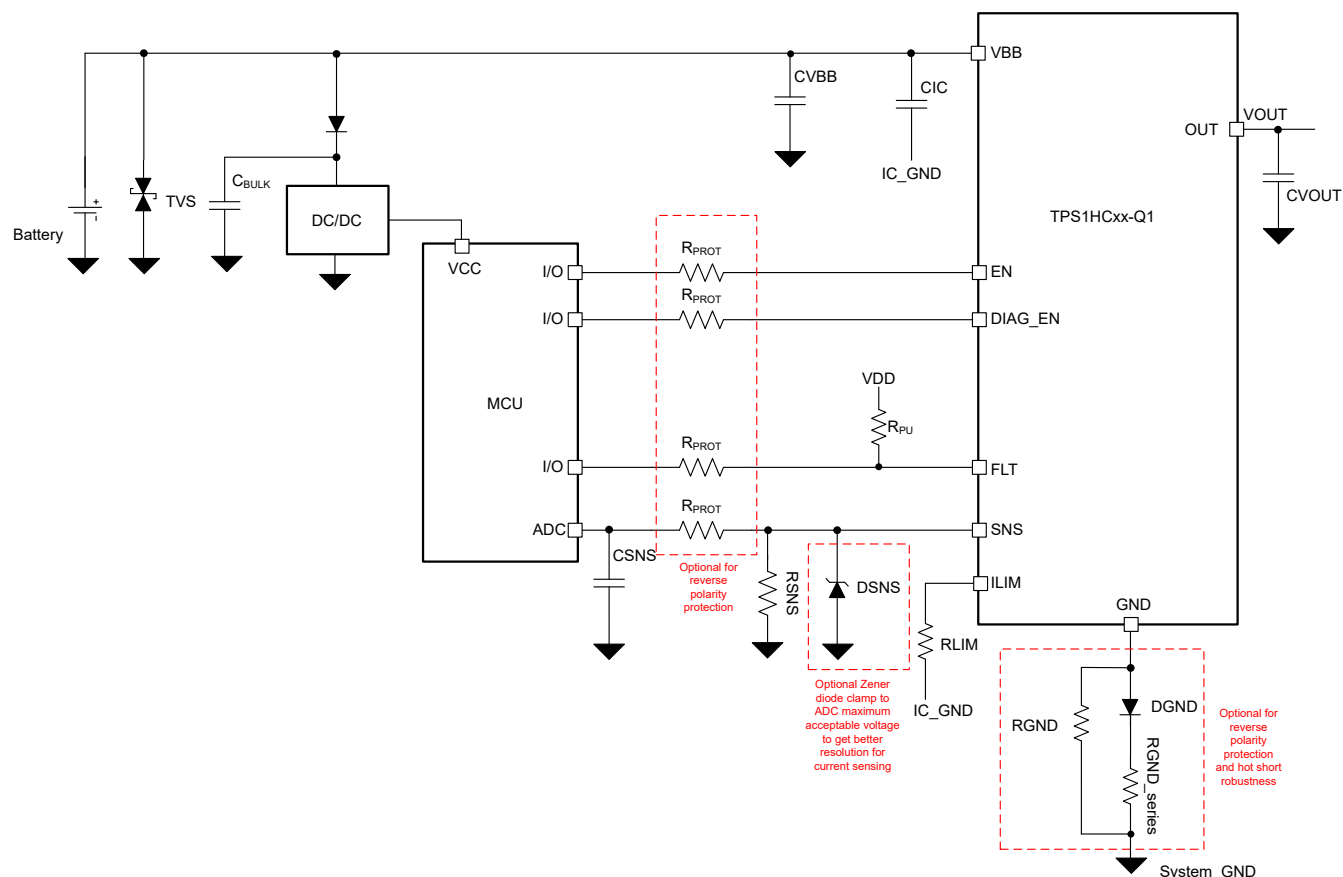


図 9-1. 代表的なアプリケーションの図

9.2.1 設計要件

表 9-1. 推獎部品値

部品	説明	目的
TVS	SMBJ39CA	バッテリーからのフィルタ電圧過渡 (ISO7637-2)

表 9-1. 推奨部品値 (続き)

部品	説明	目的
C_{VBB}	220nF	より優れた EMI 性能
C_{IC}	100nF	EMI を低減できるように、入力側の静電容量は最小
C_{BULK}	10 μ F	電源レールの電圧過渡をフィルタリングするのに役立ちます
R_{PROT}	10k Ω	マイクロコントローラとデバイス I/O ピンの保護抵抗
R_{LIM}	値は「電気的特性」の表に記載されています	調整可能な電流制限スレッシュホールド
R_{SNS}	1k Ω	センス電流をセンス電圧に変換します
D_{SNS}	SMBJ50A	SNS ピン電圧を ADC の最大許容電圧にクランプすることで、電流検出分解能を向上させることができます。
C_{FILTER}	100nF	SNS ラインの R_{PROT} と組み合わせることでローパス・フィルタを作成し、MCU の ADC に入るノイズをフィルタ処理します
C_{VOUT}	22nF	EMI 特性の改善、電圧過渡のフィルタリング
R_{PULLUP}	4.7k Ω	オープンドレインピン ($\overline{FLT}$ および LPM) のプルアップ抵抗
R_{GND}	4.7k Ω	誘導性負荷のターンオフ時に GND の電位を安定させます
D_{GND}	BAS21 ダイオード	通常動作中は、GND をシステムグラウンドに近づけて配置します
R_{GND_series}	1 Ω	高温での堅牢性のために D_{GND} に直列に抵抗を接続します。

9.2.2 詳細な設計手順

SNS ピンに外付け部品が接続されていない場合は **式 1** を用いて R_{SNS} 抵抗値を算出でき、電流検出分解能を向上させるために、SNS ピン電圧を ADC の最大許容電圧である $V_{ADC, max}$ にクランプする外付けツェナーダイオードまたは抵抗分圧器を SNS ピンに接続する場合は **式 2** を用いて算出できます。より高い電流検出精度を達成するには、許容誤差 1% 以内の抵抗を推奨します。

表 9-2. 代表的なアプリケーション

パラメータ	値 (SNS ピンに外付け部品なし)	値 (SNS ピンに外付けツェナーダイオードまたは抵抗分圧器を接続)
$I_{LOAD, max}$	40A	40A
$I_{LOAD, min}$	200mA	200mA
$V_{ADC, max}$	5V	5V
$V_{ADC, min}$	5mV	5mV
V_{HR} (必要)	-	1V
K_{SNS} 、 $I_{LOAD, min}$ にて	8182	8182
K_{SNS} 、 $I_{LOAD, max}$ にて	8010	8010
K_{CL}	1000	1000
I_{SNSFH}	7.4mA	7.4mA
V_{HR} (最大 R_{SNS} を用いて計算)	1.63V	-
R_{SNS} (最小値)	205 Ω	205 Ω
R_{SNS} (最大値)	676 Ω	801 Ω

このアプリケーションでは、SNS ピンにツェナーダイオード (D_{SNS}) を接続する構成のため、**式 2** の要件を満たす R_{SNS} 値として **700 Ω** を選択できます。

より広いダイナミック電流範囲を必要とする他のアプリケーションでは、測定可能な低電流側の値を重視することで R_{SNS} を増加させることもできます。同様に、高い電流に関心がある場合、 R_{SNS} を減少させることができます。

調整可能な電流制限値 I_{CL} を設定するには、式 13 を使用して R_{LIM} の値を選択します。

$$R_{LIM} = \frac{K_{CL}}{I_{CL}} \quad (13)$$

TI は、5V マイコンの IO 接続に対して、 $R_{PROT} = 10k\Omega$ を推奨しています。

9.2.2.1 EMC 過渡外乱テスト

車載環境では電氣的条件が厳しいため、電氣的な過渡外乱に対する耐性が必要になります。これは、バッテリーに直接接続されるハイサイド パワー スイッチでは特に重要です。詳細なテスト要件は、ISO 7637-2:2011 および ISO 16750-2:2010 規格に従います。

表 9-3. 12V システムにおける ISO 7637-2:2011(E)

テスト項目	テストパルスの重症度レベルとそれに応じた $V_s^{(1)(2)}$		パルス時間 (t_d)	最小パルス数またはテスト時間	バーストサイクルのパルス反復時間		入力抵抗 (Ω) ⁽³⁾	機能性能ステータス分類 ⁽⁴⁾
	レベル	V_s/V			最小値	最大値		
1	III	-112	2ms	500 パルス	0.5s	—	10	ステータス II
2a	III	55	50 μ s	500 パルス	0.2s	5s	2	ステータス II
2b	IV	10	0.2s~2s	10 パルス	0.5s	5s	0~0.05	ステータス II
3a	IV	-220	0.1 μ s	1h	90ms	100ms	50	ステータス II
3b	IV	150	0.1 μ s	1h	90ms	100ms	50	ステータス II

- (1) 入力が low 状態と high 状態の両方でテスト済みです。
- (2) パルス 2A の電圧は、GND 基準で VBB から最大 54V となります。レベル III に合格するためには、電圧抑制メカニズムを使用する必要があります。このテストは、VBB からシステム グランドに 1 μ F のコンデンサを接続した状態で実施されます。
- (3) GND ピン ネットワークは、BAS21-7-F ダイオードと並列接続した 4.7k Ω 抵抗です。
- (4) ステータス II: 機能はテスト中は設計どおり動作しませんが、テスト後は自動的に通常動作に復帰します。

表 9-4. 12V システムでの ISO 16750-2:2010(E) 負荷ダンプ テスト B

テスト項目	テストパルスの重症度レベルとそれに応じた $V_s^{(1)(2)}$		パルス時間 (t_d)	最小パルス数またはテスト時間	バーストサイクルのパルス反復時間	入力抵抗 (Ω) ⁽³⁾	機能性能ステータス分類 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
	レベル	V_s/V					
テスト B		35	40ms から 400ms に変更	5 パルス	60s	0.5~4	ステータス II

- (1) 入力が low 状態と high 状態の両方でテスト済みです (DIAG_EN、EN、VBB はすべて入力として分類)。
- (2) ワorst ケースのテスト条件を考慮し、VBB および VOUT にフィルタ コンデンサなしでデバイスをテストします。
- (3) GND ピン ネットワークは、BAS21-7-F ダイオードと並列接続した 4.7k Ω 抵抗です。
- (4) ステータス II: 機能はテスト中は設計どおり動作しませんが、テスト後は自動的に通常動作に復帰します。
- (5) 36V の外付けサブレッサを選択してください。

9.2.3 過渡熱性能

TPS1HC03-Q1 デバイスは、短時間に大きな電流が流れるさまざまな過渡条件を経験します。たとえば、次のような条件があります：

- ・ 大容量性負荷またはバルブ負荷充電中の突入電流。
- ・ 出力のグランドへの短絡、過電流保護のトリガなどの故障条件。
- ・ モータまたはソレノイドなどの誘導性負荷が短時間駆動された後、解放される。

過渡条件の場合、熱インピーダンスパラメータ ($Z_{\theta JA}$) は、接合部から周囲への熱性能を示します。下の図に、FR4 2s2p 基板を使用した自然対流条件下での評価基板の熱インピーダンスのシミュレーション結果を示します。このデバイス (チップ + パッケージ) は、76.2×114.3×1.5mm の基板でモデル化されており、2 つの内側銅層 (厚さ 70 μ m の銅で 2 層、厚さ 35 μ m の銅で 2 層) を備えています。VBB および VOUT パッドの下に配置された 5 つのサーマル ビアで、第一内部銅層 (12mm × 12mm) と接続しています。すべてのシミュレーションは、25°C の周囲温度で、チャネルの消費電力を 1W に設定して実施しました。

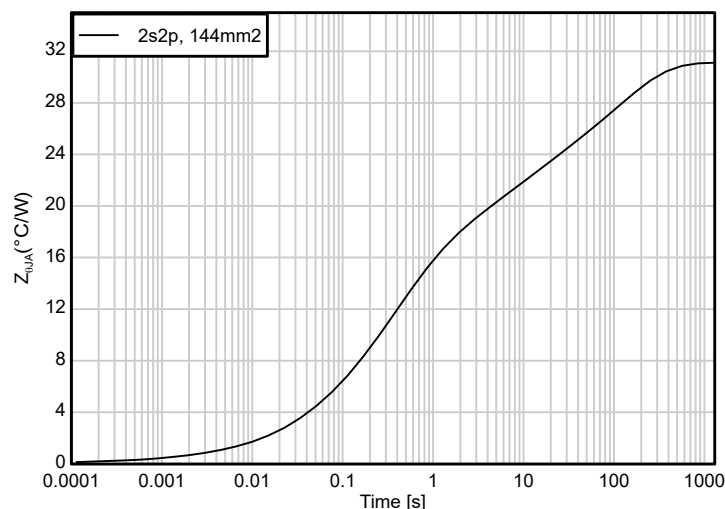


図 9-2. $Z_{\theta JA}$ (過渡熱インピーダンス)、JEDEC 規格の 2s2p PCB レイアウトによる、VBB および VOUT パッドの下に 5 つのサーマル ピア

9.2.4 アプリケーション曲線

以下の一部の画像でデバイスチャネルを示すために下付き添字「1」が使用されることがあります。

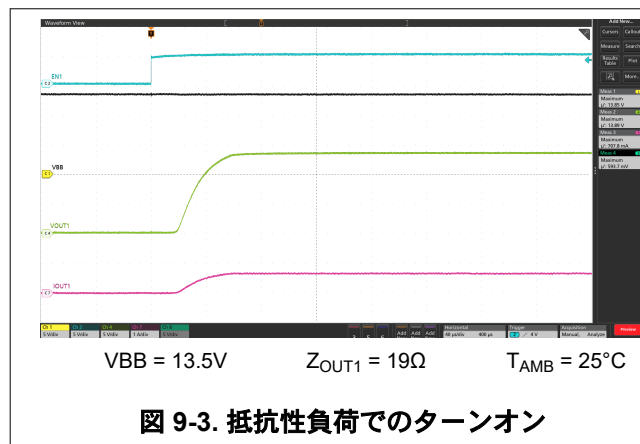


図 9-3. 抵抗性負荷でのターンオン

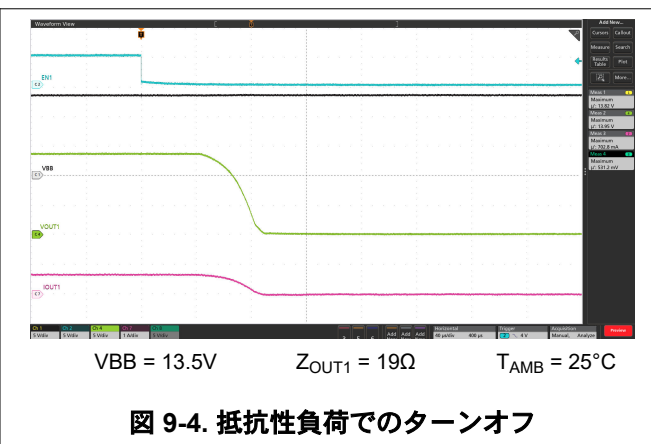


図 9-4. 抵抗性負荷でのターンオフ

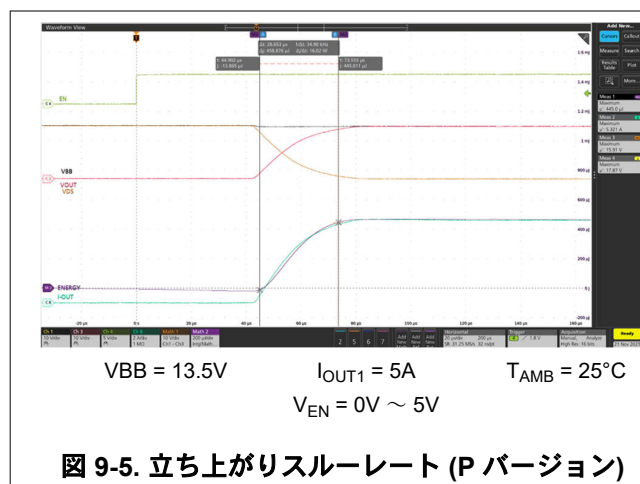


図 9-5. 立ち上がりスルーレート (P バージョン)

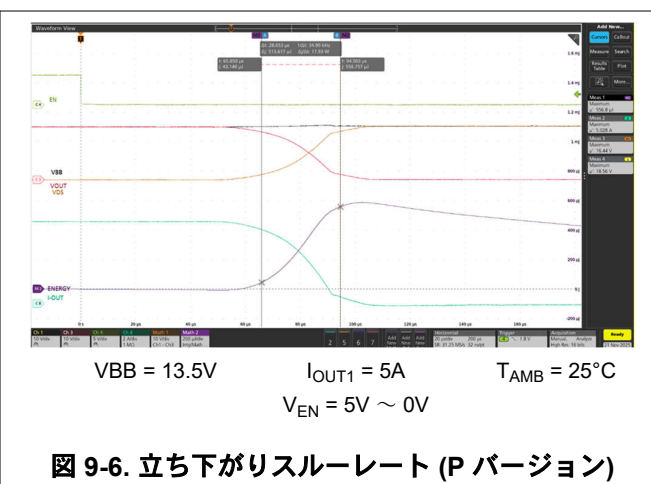
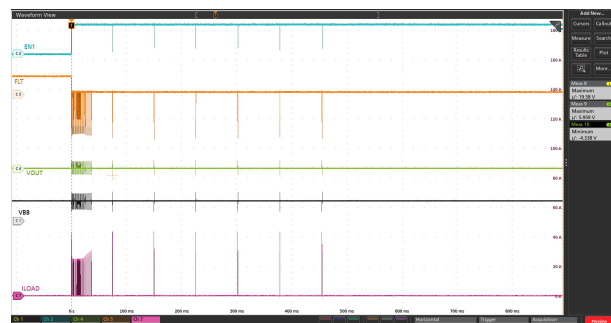
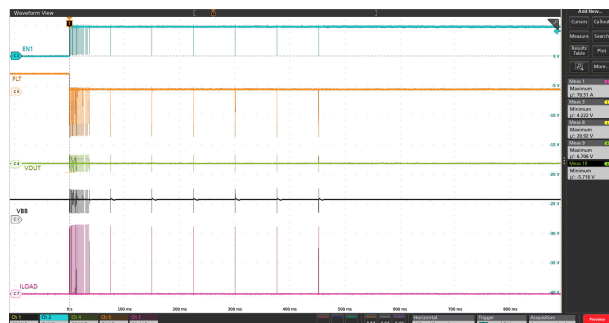


図 9-6. 立ち下がりスルーレート (P バージョン)



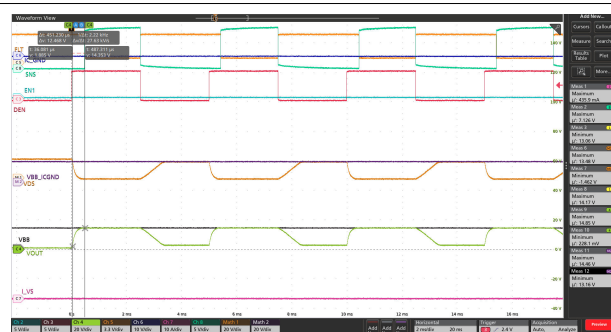
VBB = 13.5V V_{OUT1} = STG T_{AMB} = 25°C
I_{LIM} = 開放 V_{EN1} = 5 V GND 回路網付き

図 9-7. 出力が GND に短絡された場合のデバイスのターンオン動作 (ILIM = 開放)



VBB = 13.5V V_{OUT1} = STG T_{AMB} = 25°C
I_{LIM} = STG V_{EN1} = 5 V GND 回路網付き

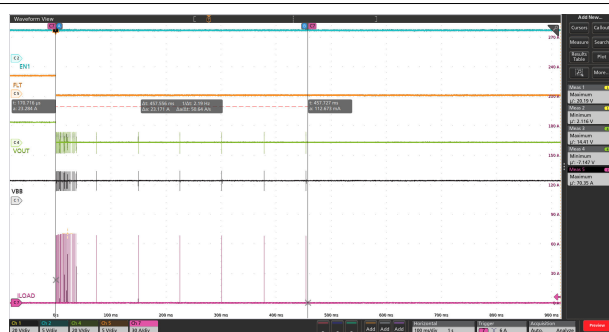
図 9-8. 出力が GND に短絡された場合のデバイスのターンオン動作 (ILIM = STG)



VBB = 13.5V V_{OUT} = 開放負荷 T_{AMB} = 25°C
DIAG_EN = PWM V_{EN1} = 0 V
(200Hz)

DIAG_EN が High のとき、SNS は I_{SNSFH} 電流を出力し、
DIAG_EN が Low のときはフローティングになります
DIAG_EN が High のとき、FLT がアサートされます

図 9-9. デバイスの開放負荷故障発生時の開放負荷検出遅延 (t_{OL2}) (P、D バージョン)



VBB = 13.5V Z_{OUT1} = 1μH + 100mΩ T_{AMB} = 25°C
ILIM = STG V_{EN1} = 5 V グランド回路網なし

図 9-10. ホット ショート (再試行動作)



VBB = 13.5V Z_{OUT1} = 1μH + 100mΩ T_{AMB} = 25°C
ILIM = STG V_{EN1} = 5 V グランド回路網なし

図 9-11. ホットショート (再試行動作) 初回再試行ウィンドウの拡大表示

9.3 電源に関する推奨事項

このデバイスは車載用および産業用のアプリケーションに適しています。通常の電源接続は、12V の車載用システムです。電源電圧は、[推奨動作条件](#) に規定されている範囲内に必要があります。

表 9-5. 動作電圧範囲

VBB 電圧範囲	注
3V ~ 6V	コールド クランクやスタート / ストップなど、12V 未満の車載用バッテリー動作を拡張。デバイスは完全に機能し、保護されていますが、 R_{ON} 、電流センス精度、電流制限精度、タイミング パラメータなど一部のパラメータが仕様からずれる場合があります。電気的特性で個々の仕様をチェックし、電圧範囲を確認してください。
6V ~ 18V	公称 12V の車載用バッテリーの電圧範囲。すべてのパラメータ仕様が適用され、デバイスは完全に機能し、保護されています。
18V ~ 28V	ダブル バッテリーなど、12V 以上の車載用バッテリー動作を拡張。デバイスは完全に機能し、保護 (24V までの短絡保護) されていますが、 R_{ON} 、電流センス精度、電流制限精度、タイミングパラメータなど一部のパラメータが仕様からずれる場合があります。電気的特性で個々の仕様をチェックし、電圧範囲を確認してください。
35V	負荷ダンブ電圧。デバイスは動作可能で、パルスは損傷を受けることなく通過しますが、短絡に対する保護はありません。

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

良好な放熱性能を得るため、VBB パッドは大きな銅流し込みに接続します。PCB 上面では、以下のレイアウト例に示すように、流し込みがパッケージ寸法を超えて広がる場合があります。これに加えて、一つ以上の内部 PCB 層や最下層に VBB プレーンを配置することを推奨します。ビアを使用して、これらのプレーンを上側の VBB 流し込みに接続する必要があります。VOUT のパッドを基板上の大きな銅流し込みに接続すると、熱が内部の銅ピラーを経由して基板上の大きな銅流し込みに伝達されるため、放熱性能の向上にも役立ちます。

TI は、マイクロコントローラに接続する IO 信号がビアを経由して、次に内部の PCB 層を通過することを推奨します。

設計に使用されている場合には、 C_{IC} コンデンサは、デバイスの VBB ピンおよび GND ピンにできるだけ近づけて配置してください。逆バッテリー保護のためにグランド・ネットワークを使用する場合は、 C_{IC} コンデンサを VBB ネットから IC_GND ネットに接続する必要があります。最適な性能を実現するため、 C_{VBB} コンデンサは VBB ピンの近くに配置し、システムグランドに接続する必要があります。

R_{LIM} 部品は、デバイスの ILIM ピンと GND ピンの近くに配置する必要があります。逆接バッテリー保護としてグランド ネットワークを使用する場合、所定の電流制限特性を得るためには、 R_{LIM} を ILIM ピンから IC_GND ネットへ接続する必要があります。

FLT ピンと SNS ピンの配線は、相互干渉を避けるため、十分に離してルーティングする必要があります (直交配置または異なる層での配線が推奨されます)。

TPS1HC03-Q1 のフットプリントはファミリ内の他デバイスと互換性があり、共通基板設計に利用できます。

9.4.2 レイアウト例

9.4.2.1 GND ネットワークなし

GND ネットワークなしの PCB レイアウトの例を以下の図に示します。TI は、マイクロコントローラに接続する IO 信号がビアを経由して、次に内部の PCB 層を通過することを推奨します。

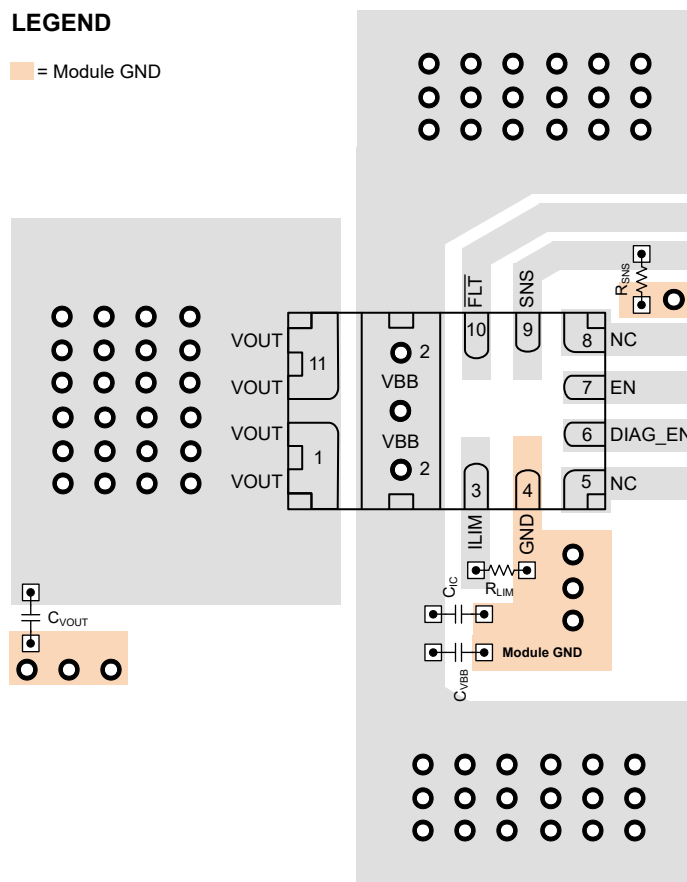


図 9-12. GND ネットワークを使わないレイアウト例

9.4.2.2 GND ネットワークあり

GND ネットワークを採用した PCB レイアウトの例を以下の図に示します。TI は、マイクロコントローラに接続する IO 信号がビアを経由して、次に内部の PCB 層を通過することを推奨します。

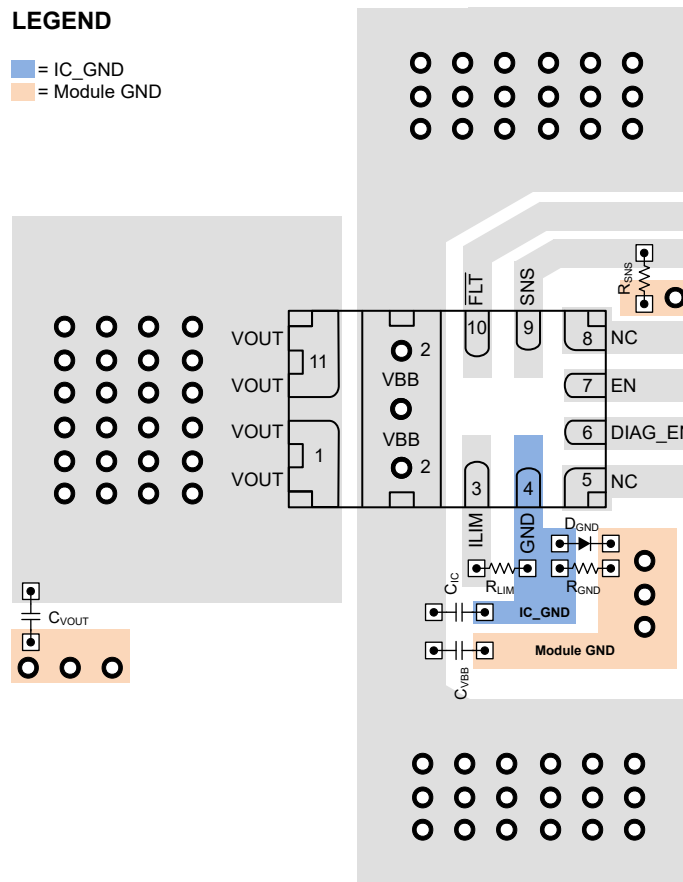


図 9-13. GND ネットワークを使ったレイアウト例

9.4.3 ウェッタブル フランク パッケージ

従来の QFN パッケージでは、自動光学検査 (AOI) によって PCB への適切な半田接続を確認することは困難です。パッケージの切断工程後に露出する銅エッジは酸化しやすく、安定した半田濡れ性を確保することが難しくなります。均一な半田フィレットが形成されない場合、検査時に適切なはんだ接続を外観で確認することができません。

上記の課題を解消するため、ウェッタブル フランク プロセスでは、機械的および冶金的手法を用いて、QFN パッケージ側面に所定高さまでの濡れ性を付与します。これにより検査可能な半田フィレットが形成され、適切な接続状態を外観で確認でき、検査要件を満たすことが可能となります。

ウェッタブル フランクには、ディンプル カット、ステップ カット、イマージョン ティンの 3 種類があります。ディンプル カットおよびステップ カットでは、パッケージ側面に明確な溝形状が形成されますが、無電解スズ方式では物理的な溝を設けることなく、側面にスズめっきを施す手法を用います。

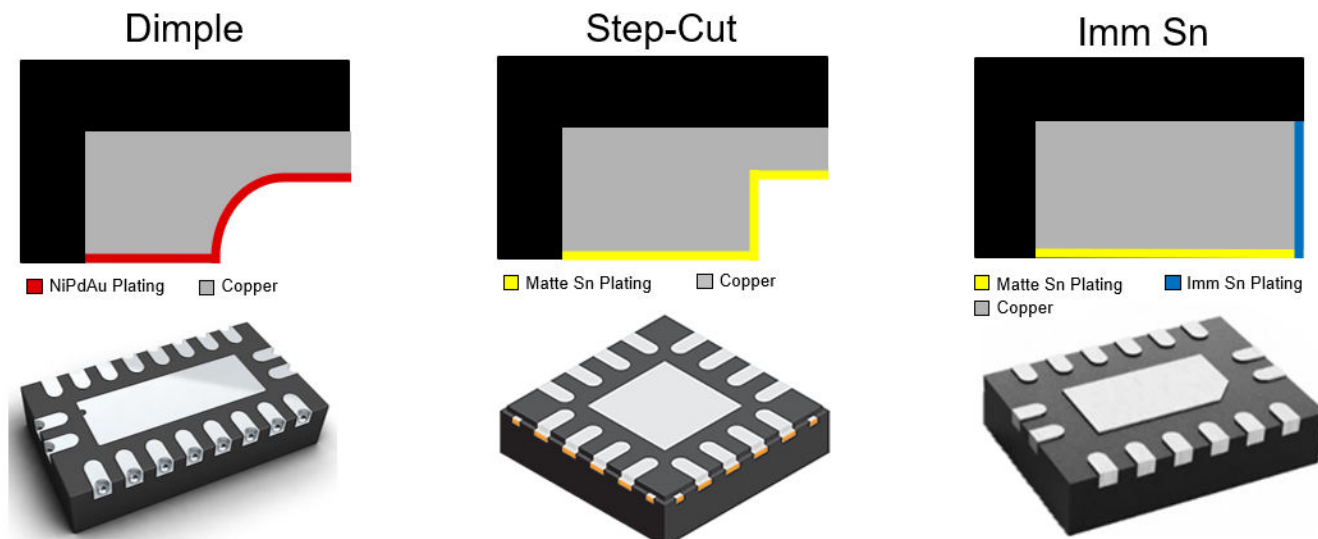


図 9-14. ウェットブル フランク パッケージの種類

TPS1HC03-Q1 の VAH パッケージは、無電解スズめっき方式を採用しています。デバイス パッケージは、リード フレームの一部である露出側面を備えており、パッケージの側面に、半田が密着するための表面積を確保しています。錫メッキ自体は白色であるため、検査時に半田の被覆状況を視覚的に明確に確認することができます。この濡れは、パッケージの電気的特性や信頼性性能に影響を与えません。この実装は、半田材の側面濡れ高さ $100\mu\text{m}$ 以上という業界要件を満たしており、自動光学検査を可能にしつつ、信頼性の高い接続を確保します。

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項

サード・パーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメンツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サード・パーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サード・パーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
July 2026	*	初版リリース

12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントの改訂を伴わない場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS1HC03PQVAHRQ1	Active	Production	VQFN-HR (VAH) 11	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-45 to 125	1HC03P

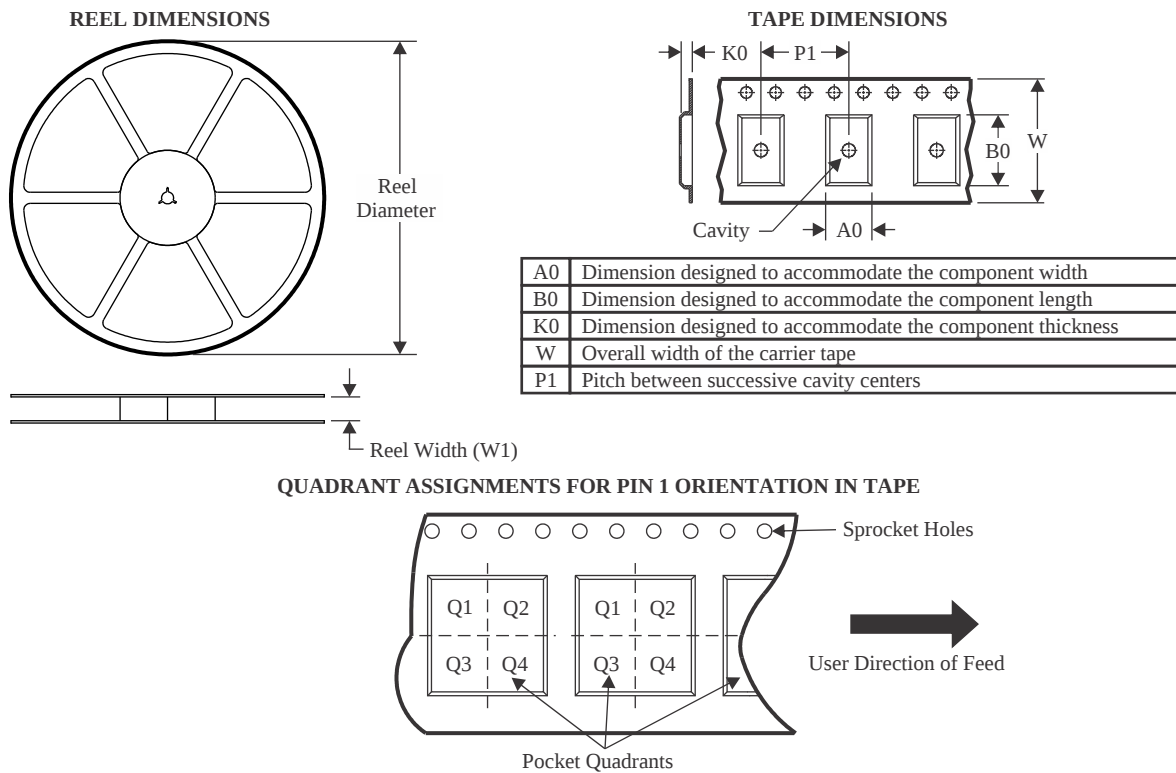
- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

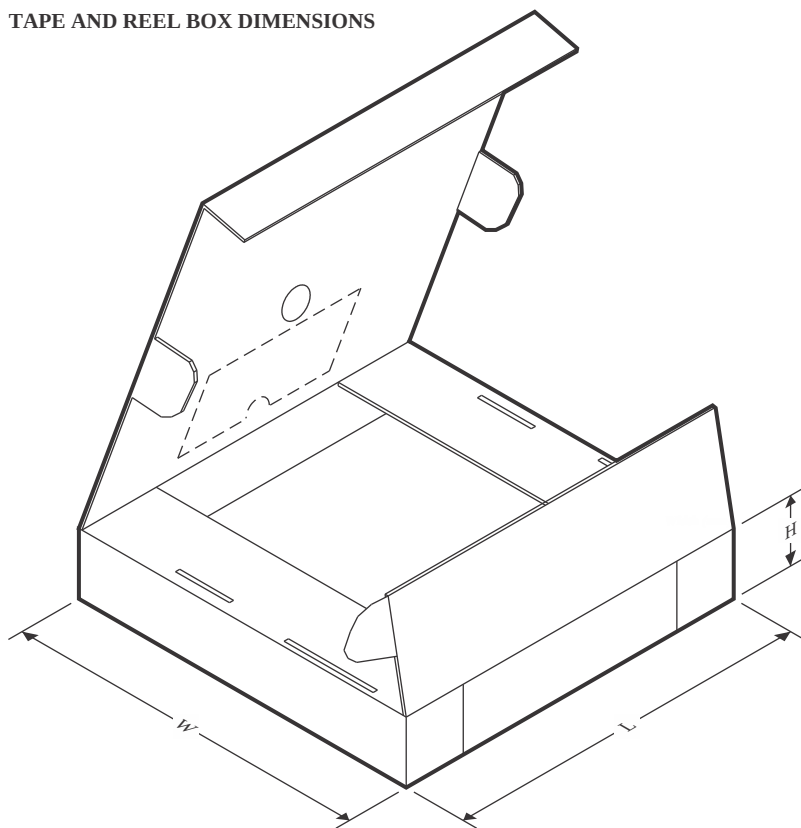
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS1HC03PQVAHRQ1	VQFN-HR	VAH	11	3000	180.0	12.4	2.5	3.9	1.2	4.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS1HC03PQVAHRQ1	VQFN-HR	VAH	11	3000	210.0	185.0	35.0

GENERIC PACKAGE VIEW

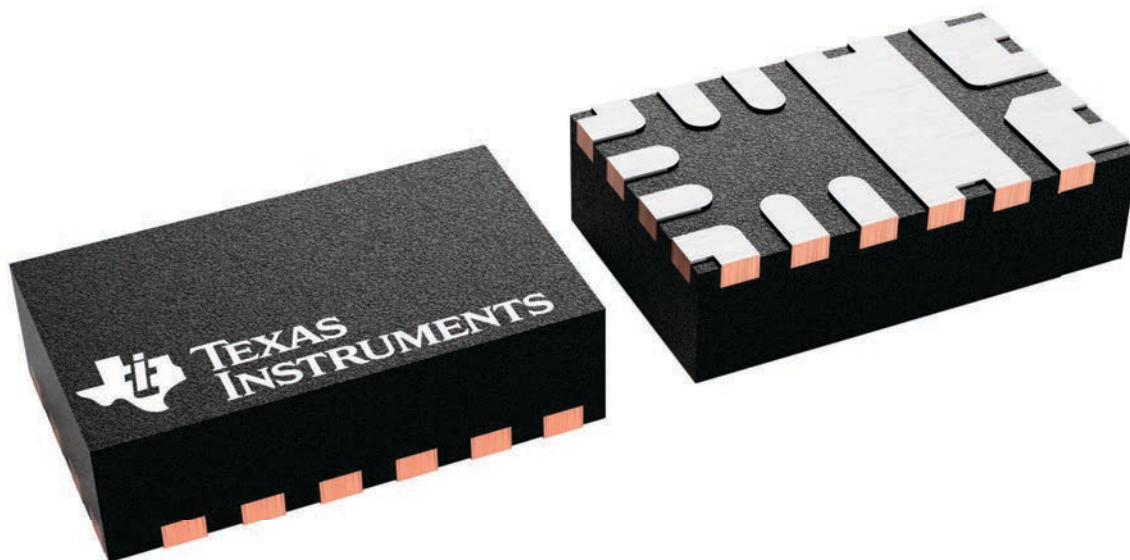
VAH 11

VQFN-HR - 1 mm max height

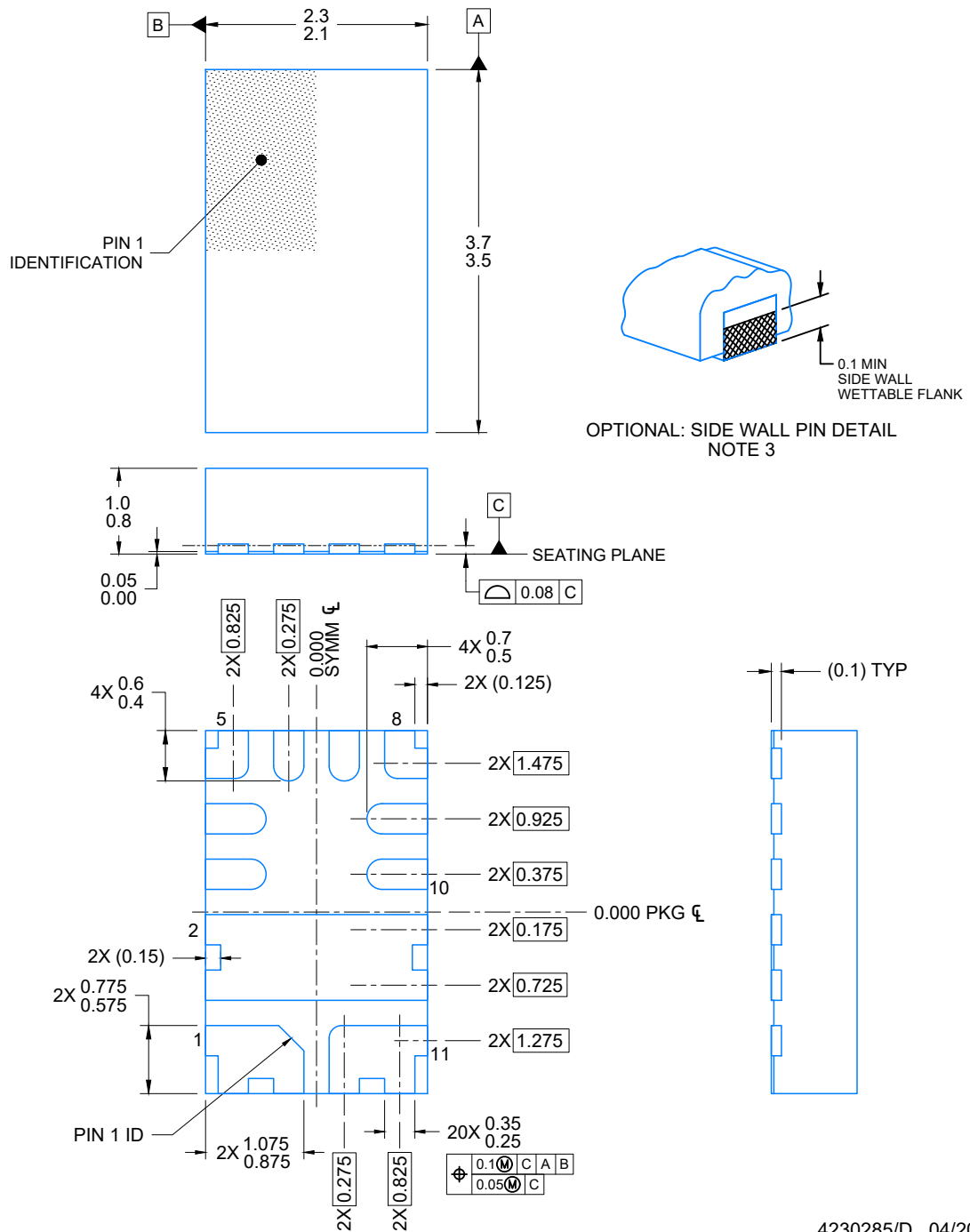
2.2 x 3.6, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



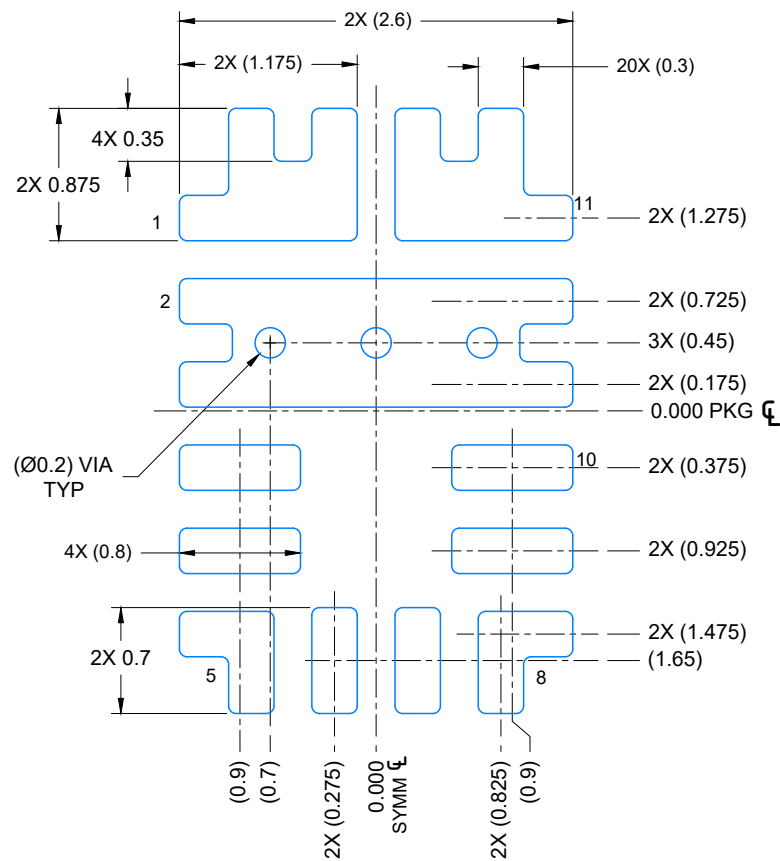
4230955/A



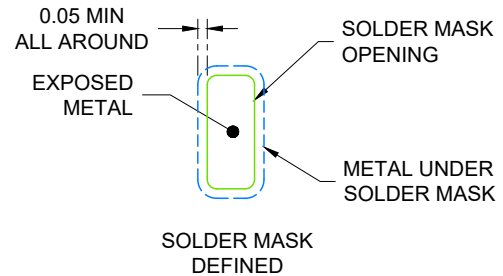
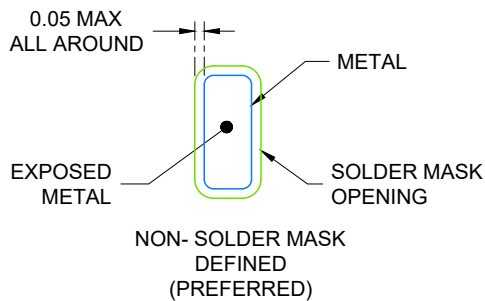
4230285/D 04/2026

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Minimum 0.1 mm solder wetting on pin side wall. Available for wettable flank version only.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X

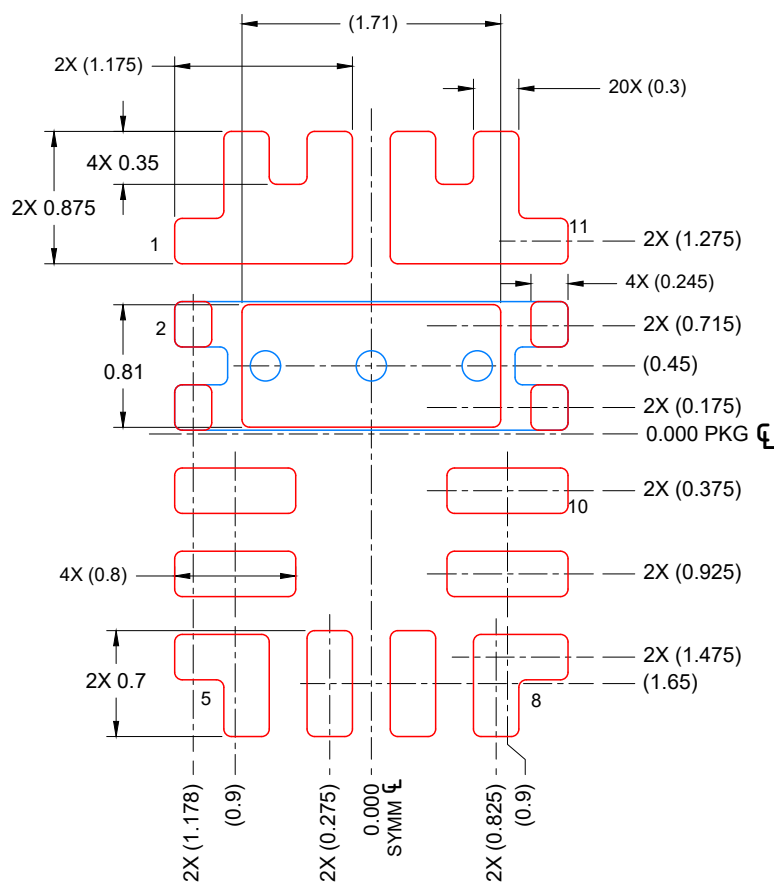


SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4230285/D 04/2026

NOTES: (continued)

4. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE: 20X

4230285/D 04/2026

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月